

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 特許公報(B2)

(11) 特許番号

特許第6017368号
(P6017368)

(45) 発行日 平成28年10月26日(2016.10.26)

(24) 登録日 平成28年10月7日(2016.10.7)

(51) Int.Cl.

H01L 51/50 (2006.01)

F 1

H05B 33/14

B

H05B 33/22

D

H05B 33/22

A

請求項の数 9 (全 87 頁)

(21) 出願番号 特願2013-87110 (P2013-87110)
 (22) 出願日 平成25年4月18日 (2013.4.18)
 (65) 公開番号 特開2013-239703 (P2013-239703A)
 (43) 公開日 平成25年11月28日 (2013.11.28)
 審査請求日 平成28年4月6日 (2016.4.6)
 (31) 優先権主張番号 特願2012-96883 (P2012-96883)
 (32) 優先日 平成24年4月20日 (2012.4.20)
 (33) 優先権主張国 日本国 (JP)

早期審査対象出願

(73) 特許権者 000153878
 株式会社半導体エネルギー研究所
 神奈川県厚木市長谷398番地
 (72) 発明者 濑尾 哲史
 神奈川県厚木市長谷398番地 株式会社
 半導体エネルギー研究所内
 (72) 発明者 濑尾 広美
 神奈川県厚木市長谷398番地 株式会社
 半導体エネルギー研究所内
 (72) 発明者 下垣 智子
 神奈川県厚木市長谷398番地 株式会社
 半導体エネルギー研究所内
 審査官 濱野 隆

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】発光素子、発光装置、電子機器、および照明装置

(57) 【特許請求の範囲】

【請求項1】

一対の電極間に、正孔輸送層と、発光層と、を有し、
 前記発光層は、
 電子輸送性を有する第1の有機化合物と、
 正孔輸送性を有する第2の有機化合物と、
 三重項励起エネルギーを発光に変える第3の有機化合物と、を有し、
 前記第1の有機化合物と前記第2の有機化合物は、励起錯体を形成する組み合わせであり、

前記正孔輸送層は、2種類以上の有機化合物を有し、かつ、少なくとも前記第2の有機化合物を有し、

前記励起錯体の発光スペクトルは、前記第3の有機化合物の吸収スペクトルと重なりを有する

ことを特徴とする発光素子。

【請求項2】

一対の電極間に、正孔輸送層と、発光層と、を有し、

前記発光層は、

電子輸送性を有する第1の有機化合物と、

正孔輸送性を有する第2の有機化合物と、

三重項励起エネルギーを発光に変える第3の有機化合物と、を有し、

10

20

前記第1の有機化合物と前記第2の有機化合物は、励起錯体を形成する組み合わせであり、

前記正孔輸送層は、2種類以上の有機化合物を有し、かつ、少なくとも前記第2の有機化合物を有し、

前記励起錯体から前記第3の有機化合物へエネルギー移動し、前記第3の有機化合物が発光する

ことを特徴とする発光素子。

【請求項3】

一対の電極間に、正孔注入層と、正孔輸送層と、発光層と、電子輸送層と、電子注入層と、を有し、

10

前記発光層は、

電子輸送性を有する第1の有機化合物と、

正孔輸送性を有する第2の有機化合物と、

三重項励起エネルギーを発光に変える第3の有機化合物と、を有し、

前記第1の有機化合物と前記第2の有機化合物は、励起錯体を形成する組み合わせであり、

前記正孔輸送層は、2種類以上の有機化合物を有し、かつ、少なくとも前記第2の有機化合物を有し、

前記励起錯体の発光スペクトルは、前記第3の有機化合物の吸収スペクトルと重なりを有する

20

ことを特徴とする発光素子。

【請求項4】

一対の電極間に、正孔注入層と、正孔輸送層と、発光層と、電子輸送層と、電子注入層と、を有し、

前記発光層は、

電子輸送性を有する第1の有機化合物と、

正孔輸送性を有する第2の有機化合物と、

三重項励起エネルギーを発光に変える第3の有機化合物と、を有し、

前記第1の有機化合物と前記第2の有機化合物は、励起錯体を形成する組み合わせであり、

30

前記正孔輸送層は、2種類以上の有機化合物を有し、かつ、少なくとも前記第2の有機化合物を有し、

前記励起錯体から前記第3の有機化合物へエネルギー移動し、前記第3の有機化合物が発光する

ことを特徴とする発光素子。

【請求項5】

請求項1乃至請求項4のいずれか一において、

前記正孔輸送層は、

前記第1の有機化合物よりもT₁準位が高い第4の有機化合物を有する
ことを特徴とする発光素子。

40

【請求項6】

請求項1乃至請求項4のいずれか一において、

前記正孔輸送層は、

前記第2の有機化合物よりもT₁準位が高い第4の有機化合物を有する
ことを特徴とする発光素子。

【請求項7】

請求項1乃至請求項6のいずれか一に記載の発光素子を有する発光装置。

【請求項8】

請求項7に記載の発光装置を有する電子機器。

【請求項9】

50

請求項 7 に記載の発光装置を有する照明装置。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

本発明の一態様は、電界を加えることにより発光が得られる有機化合物を一対の電極間に挟んでなる発光素子、また、このような発光素子を有する発光装置、電子機器、及び照明装置に関する。

【背景技術】

【0002】

薄型軽量、高速応答性、直流低電圧駆動などの特徴を有する有機化合物を発光体として用いた発光素子は、次世代のフラットパネルディスプレイへの応用が期待されている。特に、発光素子をマトリクス状に配置した表示装置は、従来の液晶表示装置と比較して、視野角が広く視認性が優れる点に優位性があると考えられている。

【0003】

発光素子の発光機構は、一対の電極間に発光体を含む発光層を挟んで電圧を印加することにより、陰極から注入された電子および陽極から注入された正孔が発光層の発光中心で再結合して分子励起子を形成し、その分子励起子が基底状態に緩和する際にエネルギーを放出して発光するといわれている。励起状態には一重項励起状態と三重項励起状態が知られ、発光はどちらの励起状態を経ても可能であると考えられており、一重項励起状態 (S^{*}) からの発光が蛍光、三重項励起状態 (T^{*}) からの発光が燐光と呼ばれている。

【0004】

このような発光素子に関しては、その素子特性を向上させる為に、素子構造の改良や材料開発等が盛んに行われている（例えば、特許文献 1 参照）。

【先行技術文献】

【特許文献】

【0005】

【特許文献 1】特開 2010-182699 号公報

【発明の概要】

【発明が解決しようとする課題】

【0006】

特許文献 1 において、報告されているように素子構造の改良などは進んできてはいるものの、発光効率、信頼性、発光特性といった面での改善の余地が残されており、より優れた発光素子の開発が望まれている。

【0007】

そこで、本発明の一態様では、駆動電圧が低く、且つ発光効率が高い発光素子を提供することを目的の一とする。

【課題を解決するための手段】

【0008】

本発明の一態様は、一対の電極間に正孔輸送層と、正孔輸送層上に形成された発光層と、を有し、発光層は、電子輸送性を有する第 1 の有機化合物と、正孔輸送性を有する第 2 の有機化合物と、三重項励起エネルギーを発光に変える発光性の第 3 の有機化合物と、を有し、第 1 の有機化合物と第 2 の有機化合物は、励起錯体を形成する組み合わせであり、正孔輸送層が 2 種類以上の有機化合物（例えば、第 2 の有機化合物及び正孔輸送性を有する第 5 の有機化合物）により形成され、少なくとも第 2 の有機化合物を有することを特徴とする発光素子である。

【0009】

また、本発明の他の一態様は、一対の電極間に正孔注入層と、正孔注入層上に形成された正孔輸送層と、正孔輸送層上に形成された発光層と、発光層上に形成された電子輸送層と、電子輸送層上に形成された電子注入層と、を有し、発光層は、電子輸送性を有する第 1 の有機化合物と、正孔輸送性を有する第 2 の有機化合物と、三重項励起エネルギーを発

10

20

30

40

50

光に変える発光性の第3の有機化合物と、を有し、第1の有機化合物と第2の有機化合物は、励起錯体を形成する組み合わせであり、正孔輸送層が2種類以上の有機化合物（例えば、第2の有機化合物及び正孔輸送性を有する第5の有機化合物）により形成され、少なくとも第2の有機化合物を有することを特徴とする発光素子である。

【0010】

なお、上記各構成において、第1の有機化合物をホスト材料として用い、第2の有機化合物をアシスト材料として用い、第3の有機化合物をゲスト材料として用いると好ましい。すなわち、発光層における第3の有機化合物の質量分率（または体積分率）が、第1の有機化合物および第2の有機化合物のそれに比して少ないことが好ましい。

【0011】

また、上記各構成において、第1の有機化合物（ホスト材料）と第2の有機化合物（アシスト材料）により形成された励起錯体の発光波長は、第1の有機化合物（ホスト材料）と第2の有機化合物（アシスト材料）のそれぞれの発光波長（蛍光波長）に比べて長波長側に存在するため、第1の有機化合物（ホスト材料）の蛍光スペクトルや第2の有機化合物（アシスト材料）の蛍光スペクトルを、より長波長側に位置する発光スペクトルに変換することができる。

【0012】

したがって、本発明の一態様である発光素子は、発光層において励起錯体を形成することにより、第1の有機化合物（ホスト材料）と第2の有機化合物（アシスト材料）それぞれの発光波長（蛍光波長）よりも長波長側に存在する励起錯体の発光スペクトルと、第3の有機化合物（ゲスト材料）の吸収スペクトルとの重なりを利用したエネルギー移動を行うことができ、エネルギー移動効率が高く、発光効率の高い発光素子を実現することができる。

【0013】

また、正孔輸送層において、正孔輸送層が2種類以上の有機化合物により形成され、少なくとも第2の有機化合物（アシスト材料）を有することにより、発光層の発光効率を高くし、且つ発光層の駆動電圧を低くすることができる。まず、正孔輸送層が発光層に用いる第2の有機化合物（アシスト材料）を有することにより、正孔輸送層-発光層間で同じHOMO準位を介した正孔輸送が行われるため、正孔輸送層から発光層へのホール注入障壁が極めて小さくなる。これにより、素子の駆動電圧が低減される。また、正孔輸送層が第2の有機化合物（アシスト材料）以外の有機化合物を有することにより、発光層の三重項励起エネルギーが正孔輸送層にまで拡散するのを抑制することができる。したがって、素子の発光効率を高めることができる。

【0014】

この効果は、正孔輸送層が、2種類以上の有機化合物により形成され、第2の有機化合物（アシスト材料）を有する場合でしか得られない効果である。例えば、正孔輸送層が第2の有機化合物を有さない場合は、正孔輸送層-発光層間で異なるHOMO準位を介した正孔輸送が行われるため、駆動電圧は上昇する。一方、正孔輸送層が第2の有機化合物のみからなる層である場合、発光層および正孔輸送層の双方に含まれている第2の有機化合物を介して、発光層の三重項励起エネルギーが正孔輸送層にまで拡散するため、発光効率は低下する。

【0015】

また、上記各構成において、正孔輸送層は、第1の有機化合物（ホスト材料）よりも最低三重項励起エネルギー準位（T₁準位）が高い第4の有機化合物を有すると好ましい。また、正孔輸送層は、第2の有機化合物（アシスト材料）よりもT₁準位が高い第4の有機化合物を有すると好ましい。

【0016】

この時、駆動電圧低減の効果を得るために、正孔輸送層における第2の有機化合物（アシスト材料）の質量分率（または体積分率）は、20%以上が好ましい。また、発光層の三重項励起エネルギーが正孔輸送層にまで拡散することを防ぐためには、正孔輸送層に

10

20

30

40

50

おける第2の有機化合物(アシスト材料)の質量分率(または体積分率)は、80%以下が好ましい。したがって、正孔輸送層における第4の有機化合物の質量分率(または体積分率)も、20%以上80%以下が好ましい。

【0017】

また、上記各構成において、第1の有機化合物(ホスト材料)が不足型複素芳香族化合物であり、第2の有機化合物(アシスト材料)が過剰型複素芳香族化合物または芳香族アミン化合物であり、第3の有機化合物(ゲスト材料)が発光性有機金属錯体であると好ましい。

【0018】

また、本発明の一態様は、発光素子を有する発光装置、発光装置を有する電子機器、及び照明装置も範疇に含めるものである。したがって、本明細書中における発光装置とは、画像表示デバイス、もしくは光源(照明装置含む)を指す。また、発光装置にコネクター、例えばFPC(Flexible printed circuit)もしくはTCP(Tape Carrier Package)が取り付けられたモジュール、TCPの先にプリント配線板が設けられたモジュール、または発光素子にCOG(Chip On Glass)方式によりIC(集積回路)が直接実装されたモジュールも全て発光装置に含むものとする。

【発明の効果】

【0019】

なお、本発明の一態様である発光素子は、発光層において、励起錯体を形成することにより、第1の有機化合物(ホスト材料)と第2の有機化合物(アシスト材料)それぞれの発光波長(蛍光波長)よりも長波長側に存在する励起錯体の発光スペクトルと、第3の有機化合物(ゲスト材料)の吸収スペクトルとの重なりを利用したエネルギー移動を行うことができるため、エネルギー移動効率が高く、発光効率の高い発光素子を実現することができる。

【0020】

さらに、本発明の一態様である発光素子は、正孔輸送層において、発光層に用いる第2の有機化合物(アシスト材料)を有することにより、高い発光効率を維持しながら、発光素子の駆動電圧(特に駆動開始電圧)を低くすることができる。

【図面の簡単な説明】

【0021】

【図1】本発明の一態様の発光素子を説明する図。

【図2】本発明の一態様の概念を説明する図。

【図3】DBq(略称)一分子、TPA(略称)一分子、及びDBq(略称)とTPA(略称)の二量体のエネルギー準位を説明する図。

【図4】DBq(略称)一分子、TPA(略称)一分子、及びDBq(略称)とTPA(略称)の二量体のHOMO及びLUMOの分布を説明する図。

【図5】本発明の一態様の概念を説明する図。

【図6】本発明の一態様の発光素子を説明する図。

【図7】発光素子の構造について説明する図。

【図8】発光素子の構造について説明する図。

【図9】発光装置について説明する図。

【図10】電子機器について説明する図。

【図11】電子機器について説明する図。

【図12】照明器具について説明する図。

【図13】実施例における発光素子の構造について説明する図。

【図14】実施例1に示す発光素子の電流密度-輝度特性を示す図。

【図15】実施例1に示す発光素子の電圧-輝度特性を示す図。

【図16】実施例1に示す発光素子の輝度-電流効率特性を示す図。

【図17】実施例1に示す発光素子の電圧-電流特性を示す図。

10

20

30

40

50

【図18】実施例1に示す発光素子の発光スペクトルを示す図。

【図19】実施例2に示す発光素子の電流密度-輝度特性を示す図。

【図20】実施例2に示す発光素子の電圧-輝度特性を示す図。

【図21】実施例2に示す発光素子の輝度-電流効率特性を示す図。

【図22】実施例2に示す発光素子の電圧-電流特性を示す図。

【図23】実施例2に示す発光素子の発光スペクトルを示す図。

【図24】実施例3に示す発光素子の電流密度-輝度特性を示す図。

【図25】実施例3に示す発光素子の電圧-輝度特性を示す図。

【図26】実施例3に示す発光素子の輝度-電流効率特性を示す図。

【図27】実施例3に示す発光素子の電圧-電流特性を示す図。 10

【図28】実施例3に示す発光素子の発光スペクトルを示す図。

【図29】実施例4に示す発光素子の電流密度-輝度特性を示す図。

【図30】実施例4に示す発光素子の電圧-輝度特性を示す図。

【図31】実施例4に示す発光素子の輝度-電流効率特性を示す図。

【図32】実施例4に示す発光素子の電圧-電流特性を示す図。

【図33】実施例4に示す発光素子の発光スペクトルを示す図。

【図34】実施例4に示す発光素子の駆動時間-規格化輝度特性を示す図。

【図35】実施例5に示す発光素子の電流密度-輝度特性を示す図。

【図36】実施例5に示す発光素子の電圧-輝度特性を示す図。

【図37】実施例5に示す発光素子の輝度-電流効率特性を示す図。 20

【図38】実施例5に示す発光素子の電圧-電流特性を示す図。

【図39】実施例5に示す発光素子の発光スペクトルを示す図。

【図40】実施例5に示す発光素子の駆動時間-規格化輝度特性を示す図。

【図41】実施例6に示す発光素子の電流密度-輝度特性を示す図。

【図42】実施例6に示す発光素子の電圧-輝度特性を示す図。

【図43】実施例6に示す発光素子の輝度-電流効率特性を示す図。

【図44】実施例6に示す発光素子の電圧-電流特性を示す図。

【図45】実施例6に示す発光素子の発光スペクトルを示す図。

【図46】実施例7に示す発光素子の電流密度-輝度特性を示す図。

【図47】実施例7に示す発光素子の電圧-輝度特性を示す図。 30

【図48】実施例7に示す発光素子の輝度-電流効率特性を示す図。

【図49】実施例7に示す発光素子の電圧-電流特性を示す図。

【図50】実施例7に示す発光素子の発光スペクトルを示す図。

【図51】2mDBTPDBq-I (略称) の燐光発光スペクトルを示す図。

【図52】PCzPCN1 (略称) の燐光発光スペクトルを示す図。

【図53】DPA2SF (略称) の燐光発光スペクトルを示す図。

【図54】BPAFLP (略称) の燐光発光スペクトルを示す図。

【図55】PCPPn (略称) の燐光発光スペクトルを示す図。

【発明を実施するための形態】

【0022】 40

以下、本発明の実施の態様について図面を用いて詳細に説明する。但し、本発明は以下の説明に限定されず、本発明の趣旨及びその範囲から逸脱することなくその形態及び詳細を様々に変更し得ることが可能である。従って、本発明は以下に示す実施の形態の記載内容に限定して解釈されるものではない。

【0023】

なお、図面等において示す各構成の、位置、大きさ、範囲などは、理解の簡単のため、実際の位置、大きさ、範囲などを表していない場合がある。このため、開示する発明は、必ずしも、図面等に開示された位置、大きさ、範囲などに限定されない。

【0024】

なお、本明細書等における「第1」、「第2」、「第3」などの序数詞は、構成要素の 50

混同を避けるために付すものであり、数的に限定するものではないことを付記する。

【0025】

(実施の形態1)

本実施の形態では、本発明の一態様である発光素子を構成する上での概念および具体的な発光素子の構成について説明する。まず、本発明の一態様である発光素子の素子構造について、図1を用いて説明する。

【0026】

図1に示す素子構造は、一対の電極(第1の電極101、第2の電極103)間に正孔輸送層112と、正孔輸送層112上に形成された発光層113と、を有し、発光層113は、電子輸送性を有する第1の有機化合物120と、正孔輸送性を有する第2の有機化合物122と、三重項励起エネルギーを発光に変える発光性の第3の有機化合物124と、を有し、第1の有機化合物120と第2の有機化合物122は、励起錯体を形成する組み合わせであり、正孔輸送層112が2種類以上の有機化合物(例えば、第2の有機化合物122及び正孔輸送性を有する第5の有機化合物)により形成され、少なくとも第2の有機化合物122を有する。

【0027】

なお、図1において、第1の電極101と正孔輸送層112の間に設けられた領域には、正孔注入層や、正孔輸送層を必要に応じて形成することができる。また、図1において、第2の電極103と発光層113の間に設けられた領域には、電子注入層や電子輸送層を必要に応じて形成することができる。

【0028】

なお、第1の有機化合物120をホスト材料として用い、第2の有機化合物122をアシスト材料として用い、第3の有機化合物124をゲスト材料として用いるとよい。すなわち、発光層における第3の有機化合物の質量分率(または体積分率)が、第1の有機化合物および第2の有機化合物のそれに比して少ないことが好ましい。以下の説明において、第1の有機化合物120をホスト材料、第2の有機化合物122をアシスト材料、第3の有機化合物124をゲスト材料として呼ぶ場合がある。

【0029】

第1の有機化合物120(ホスト材料)は、例えば $10^{-6} \text{ cm}^2 / \text{V s}$ 以上の電子移動度を有する電子輸送性材料を用いることができる。また、第2の有機化合物122(アシスト材料)は、例えば $10^{-6} \text{ cm}^2 / \text{V s}$ 以上の正孔移動度を有する正孔輸送性材料を用いることができる。

【0030】

なお、上記構成において、第1の有機化合物120(ホスト材料)及び第2の有機化合物122(アシスト材料)のそれぞれの最低三重項励起エネルギーの準位(T_1 準位)は、第3の有機化合物124(ゲスト材料)の T_1 準位よりも高いことが好ましい。第1の有機化合物120(ホスト材料)及び第2の有機化合物122(アシスト材料)の T_1 準位が、第3の有機化合物124(ゲスト材料)の T_1 準位よりも低いと、発光に寄与する第3の有機化合物124(ゲスト材料)の三重項励起エネルギーを第1の有機化合物120(ホスト材料)及び第2の有機化合物122(アシスト材料)が消光(クエンチ)してしまい、発光効率の低下を招くためである。

【0031】

また、ホスト材料からゲスト材料へのエネルギー移動効率を高めるため、分子間の移動機構として知られているフェルスター機構(双極子-双極子相互作用)およびデクスター機構(電子交換相互作用)を考慮した上で、ホスト材料の発光スペクトル(一重項励起状態からのエネルギー移動を論じる場合は蛍光スペクトル、三重項励起状態からのエネルギー移動を論じる場合は燐光スペクトル)とゲスト材料の吸収スペクトル(より詳細には、最も長波長(低エネルギー)側の吸収帯におけるスペクトル)との重なりが大きくなることが好ましい。

【0032】

10

20

30

40

50

しかしながら、ゲスト材料として、例えば燐光性化合物を用いた場合、ホスト材料の蛍光スペクトルを、ゲスト材料の最も長波長（低エネルギー）側の吸収帯における吸収スペクトルと重ねることは困難である。なぜならば、そのようにしてしまうと、ホスト材料の燐光スペクトルは蛍光スペクトルよりも長波長（低エネルギー）側に位置するため、ホスト材料のT₁準位が燐光性化合物のT₁準位を下回ってしまい、上述したクエンチの問題が生じてしまうからである。一方、クエンチの問題を回避するため、ホスト材料のT₁準位がゲスト材料として用いた燐光性化合物のT₁準位を上回るように設計すると、今度はホスト材料の蛍光スペクトルが短波長（高エネルギー）側にシフトするため、その蛍光スペクトルはゲスト材料の最も長波長（低エネルギー）側の吸収帯における吸収スペクトルと重ならなくなる。したがって、ホスト材料の蛍光スペクトルをゲスト材料の最も長波長（低エネルギー）側の吸収帯における吸収スペクトルと重ね、ホスト材料の一重項励起状態からのエネルギー移動を最大限に高めることは、通常困難である。

【0033】

そこで本発明においては、第1の有機化合物120、および第2の有機化合物122は、励起錯体（example：エキサイプレックスとも言う）を形成する組み合わせである。励起錯体について、図2（A）、及び図2（B）を用いて以下説明を行う。

【0034】

図2（A）は、励起錯体の概念を示す模式図であり、第1の有機化合物120（又は第2の有機化合物122）の蛍光スペクトル、第1の有機化合物120（又は第2の有機化合物122）の燐光スペクトル、第3の有機化合物124の吸収スペクトル、及び励起錯体の発光スペクトルを表す。

【0035】

例えば、発光層113において、第1の有機化合物120（ホスト材料）の蛍光スペクトル及び第2の有機化合物122（アシスト材料）の蛍光スペクトルは、より長波長側に位置する励起錯体の発光スペクトルに変換される。そして、励起錯体の発光スペクトルと第3の有機化合物124（ゲスト材料）の吸収スペクトルとの重なりが大きくなるように、第1の有機化合物120（ホスト材料）と第2の有機化合物122（アシスト材料）を選択すれば、一重項励起状態からのエネルギー移動を最大限に高めることができる（図2（A）参照）。

【0036】

なお、三重項励起状態に關しても、ホスト材料ではなく励起錯体からのエネルギー移動が生じると考えられる。

【0037】

したがって、形成された励起錯体の発光波長は、第1の有機化合物120（ホスト材料）と、第2の有機化合物122（アシスト材料）のそれぞれの発光波長（蛍光波長）に比べて、長波長側に存在することから、第1の有機化合物120（ホスト材料）の蛍光スペクトルや第2の有機化合物122（アシスト材料）の蛍光スペクトルを、より長波長側に位置する発光スペクトルとすることができます。

【0038】

さらに、励起錯体は一重項励起エネルギーと三重項励起エネルギーの差が極めて小さいと考えられる。換言すれば、励起錯体の一重項状態からの発光スペクトルと三重項状態からの発光スペクトルは、極めて近接することになる。したがって、上述したように励起錯体の発光スペクトル（一般には、励起錯体の一重項状態からの発光スペクトル）を、第3の有機化合物124（ゲスト材料）の最も長波長側に位置する吸収帯に重ねるよう設計した場合、励起錯体の三重項状態からの発光スペクトル（常温では観測されず、低温でも観測されない場合が多い）も、第3の有機化合物124（ゲスト材料）の最も長波長側に位置する吸収帯に重なることになる。つまり、一重項励起状態からのエネルギー移動だけでなく、三重項励起状態からのエネルギー移動の効率も高まり、結果的に、一重項・三重項の双方を効率よく発光させることができる。

【0039】

10

20

30

40

50

このように、本発明の一態様である発光素子は、発光層113において形成された励起錯体の発光スペクトルと、第3の有機化合物124（ゲスト材料）の吸収スペクトルとの重なりを利用して、エネルギー移動をするために、エネルギー移動効率が高い。

【0040】

また、励起錯体は励起状態でのみ存在するため、エネルギーを吸収できる基底状態が存在しない。したがって、第3の有機化合物124（ゲスト材料）の一重項励起状態及び三重項励起状態から励起錯体へのエネルギー移動により第3の有機化合物124（ゲスト材料）が発光する前に失活する（すなわち発光効率を損なう）という現象は、原理的に生じないと考えられる。

【0041】

なお、上述した励起錯体は、励起状態における異種分子間の相互作用によって形成される。また、励起錯体は、比較的低いLUMO（LUMO: Lowest Unoccupied Molecular Orbital、最低空分子軌道）準位をもつ材料と、高いHOMO（HOMO: Highest Occupied Molecular Orbital、最高被占有軌道）準位をもつ材料との間で形成しやすいことが一般に知られている。

【0042】

ここで、第1の有機化合物120、第2の有機化合物122、及び励起錯体のエネルギー準位の概念について、図2（B）を用いて説明を行う。なお、図2（B）は、第1の有機化合物120、第2の有機化合物122、及び励起錯体のエネルギー準位を模式的に示した図である。

【0043】

第1の有機化合物120（ホスト材料）と、第2の有機化合物122（アシスト材料）のHOMO準位及びLUMO準位は、それぞれ異なる。具体的には、第1の有機化合物120のHOMO準位 < 第2の有機化合物122のHOMO準位 < 第1の有機化合物120のLUMO準位 < 第2の有機化合物122のLUMO準位という順でエネルギー準位が異なる。そして、この2つの有機化合物により励起錯体が形成された場合、励起錯体のLUMO準位は、第1の有機化合物120（ホスト材料）に由来し、HOMO準位は、第2の有機化合物122（アシスト材料）に由来する（図2（B）参照）。

【0044】

また、励起錯体の発光波長は、HOMO準位とLUMO準位間のエネルギー差に依存する。大まかな傾向として、エネルギー差が大きいと発光波長は短くなり、エネルギー差が小さいと発光波長は長くなる。

【0045】

したがって、励起錯体のエネルギー差は、第1の有機化合物120（ホスト材料）のエネルギー差、及び第2の有機化合物122（アシスト材料）のエネルギー差よりも小さくなる。つまり、第1の有機化合物120と第2の有機化合物122のそれぞれの発光波長に比べて、励起錯体の発光波長は長波長となる。

【0046】

ここで、実際に励起錯体がこのような特性を有しているかどうかに關し、分子軌道計算を用いて検証した。一般に、複素芳香族化合物と芳香族アミンとの組み合わせは、芳香族アミンのLUMO準位に比べて低い複素芳香族化合物のLUMO準位（電子が入りやすい性質）と、複素芳香族化合物のHOMO準位に比べて高い芳香族アミンのHOMO準位（ホールが入りやすい性質）の影響で、励起錯体を形成することが多い。そこで、本発明の一態様における第1の有機化合物120のモデルとして複素芳香族化合物のLUMOを構成する代表的な骨格のジベンゾ[f, h]キノキサリン（略称：DBq）を用い、本発明の一態様における第2の有機化合物122のモデルとして芳香族アミンのHOMOを構成する代表的な骨格のトリフェニルアミン（略称：TPA）を用い、これらを組み合わせて計算を行った。

【0047】

10

20

30

40

50

まず、DBq（略称）一分子とTPA（略称）一分子の最低励起一重項状態（S₁）と最低励起三重項状態（T₁）における最適分子構造及び励起エネルギーを、時間依存密度汎関数法（TD-DFT）を用いて計算した。さらに、DBq（略称）とTPA（略称）の二量体についても励起エネルギーを計算した。

【0048】

DFT（密度汎関数法）の全エネルギーはポテンシャルエネルギー、電子間静電エネルギー、電子の運動エネルギー、及び、複雑な電子間の相互作用を全て含む交換相関エネルギーの和で表される。DFTでは、交換相関相互作用を電子密度で表現された一電子ポテンシャルの汎関数（関数の関数の意）で近似しているため、計算は高速かつ高精度である。ここでは、混合汎関数であるB3LYPを用いて、交換と相関エネルギーに係る各パラメータの重みを規定した。

【0049】

また、基底関数として、6-311（それぞれの原子価軌道に三つの短縮関数を用いたtriple split valence基底系の基底関数）を全ての原子に適用した。

【0050】

上述の基底関数により、例えば、水素原子であれば、1s～3sの軌道が考慮され、また、炭素原子であれば、1s～4s、2p～4pの軌道が考慮されることになる。さらに、計算精度向上のため、分極基底系として、水素原子にはp関数を、水素原子以外にはd関数を加えた。

【0051】

なお、量子化学計算プログラムとしては、Gaussian 09を使用した。計算は、ハイパフォーマンスコンピュータ（SGI社製、Altix 4700）を用いて行った。

【0052】

まず、DBq（略称）一分子、TPA（略称）一分子、及びDBq（略称）とTPA（略称）の二量体に関し、HOMO準位及びLUMO準位を算出した。HOMO準位及びLUMO準位を図3に示す。

【0053】

図3に示すように、DBq（略称）とTPA（略称）の二量体は、TPA（略称）のLUMO準位に比べて低いDBq（略称）のLUMO準位（-1.99eV）と、DBq（略称）のHOMO準位に比べて高いTPA（略称）のHOMO準位（-5.21eV）との影響で、DBq（略称）とTPA（略称）の励起錯体を形成することが示唆される。

【0054】

次に、DBq（略称）一分子、TPA（略称）一分子、及びDBq（略称）とTPA（略称）の二量体のHOMO及びLUMOの分布を図4に示す。

【0055】

なお、図4（A）はDBq（略称）一分子のLUMOの分布を示し、図4（B）はDBq（略称）一分子のHOMOの分布を示し、図4（C）はTPA（略称）一分子のLUMOの分布を示し、図4（D）はTPA（略称）一分子のHOMOの分布を示し、図4（E）はDBq（略称）とTPA（略称）の二量体のLUMOの分布を示し、図4（F）はDBq（略称）とTPA（略称）の二量体のHOMOの分布を、それぞれ示している。

【0056】

図4（E）及び図4（F）に示すように、DBq（略称）とTPA（略称）の二量体のLUMOはDBq（略称）側に、HOMOはTPA（略称）側に分布し、図3に示す結果を示唆している。

【0057】

また、本発明の一態様における励起錯体の形成過程には、以下の2つの過程が考えられる。

【0058】

10

20

40

50

1つ目の励起錯体の形成過程は、第1の有機化合物120（ホスト材料）及び第2の有機化合物122（アシスト材料）がキャリアを持った状態（カチオンまたはアニオン）から、励起錯体を形成する形成過程である。

【0059】

一般的には、電子及び正孔がホスト材料中で再結合した場合、励起状態のホスト材料からゲスト材料に励起エネルギーが移動し、ゲスト材料が励起状態に至り、発光するが、ホスト材料からゲスト材料に励起エネルギーが移動する前に、ホスト材料自体が発光する、または励起エネルギーが熱エネルギーとなることで、励起エネルギーの一部を失活してしまう。

【0060】

しかし、本発明の一態様においては、第1の有機化合物120（ホスト材料）及び第2の有機化合物122（アシスト材料）がキャリアを持った状態（カチオンまたはアニオン）から励起錯体を形成するため、第1の有機化合物120（ホスト材料）の一重項励起子の形成を抑制することができる。つまり、一重項励起子を形成することなく、直接励起錯体を形成する過程が存在しうる。これにより、上記一重項励起エネルギーの失活も抑制することができる。したがって、寿命が長い発光素子を実現することができる。

【0061】

例えば、第1の有機化合物120が、電子輸送性材料の中でも電子（キャリア）を捕獲しやすい性質を有する（LUMO準位の低い）電子トラップ性の化合物であり、第2の有機化合物122が、正孔輸送性の材料の中でも正孔（キャリア）を捕獲しやすい性質を有する（HOMO準位の高い）正孔トラップ性の化合物である場合には、第1の有機化合物120のアニオンと第2の有機化合物122のカチオンから、直接励起錯体が形成されることになる。このような過程で形成される励起錯体のことを特にエレクトロプレックス（electroplex）と呼ぶこととする。

【0062】

このようにして第1の有機化合物120（ホスト材料）の一重項励起状態の発生を抑制し、エレクトロプレックスから第3の有機化合物124（ゲスト材料）にエネルギー移動を行うことにより、発光効率が高い発光素子が得られる。なお、この場合、第1の有機化合物120（ホスト材料）の三重項励起状態の発生も同様に抑制され、直接励起錯体が形成されるため、励起錯体から第3の有機化合物124（ゲスト材料）にエネルギー移動する考えられる。

【0063】

2つ目の励起錯体の形成過程は、第1の有機化合物120（ホスト材料）及び第2の有機化合物122（アシスト材料）の一方が一重項励起子を形成した後、基底状態の他方と相互作用して励起錯体を形成する素過程である。エレクトロプレックスとは異なり、この場合は一旦、第1の有機化合物120（ホスト材料）または第2の有機化合物122（アシスト材料）の一重項励起状態が生成してしまうが、これは速やかに励起錯体に変換されるため、やはり一重項励起エネルギーの失活を抑制することができる。したがって、第1の有機化合物120または第2の有機化合物122が励起エネルギーを失活することを抑制することができる。なお、この場合、第1の有機化合物120（ホスト材料）の三重項励起状態も同様に、速やかに励起錯体に変換され、励起錯体から第3の有機化合物124（ゲスト材料）にエネルギー移動すると考えられる。

【0064】

なお、第1の有機化合物120（ホスト材料）が電子トラップ性の化合物であり、一方で第2の有機化合物122（アシスト材料）が正孔トラップ性の化合物であり、これら化合物のHOMO準位の差、及びLUMO準位の差が大きい場合（具体的には差が0.3eV以上）、電子は選択的に第1の有機化合物120（ホスト材料）に入り、正孔は選択的に第2の有機化合物122（アシスト材料）に入る。この場合、一重項励起子を経て励起錯体が形成される過程よりも、エレクトロプレックスが形成される過程の方が優先されると考えられる。

10

20

30

40

50

【0065】

次に、励起エネルギーの計算結果を示す。DBq(略称)一分子のS₁の励起エネルギーは、3.294 eVであり、蛍光波長は、376.4 nmであった。また、DBq(略称)一分子のT₁の励起エネルギーは、2.460 eVであり、燐光波長は、504.1 nmであった。一方、TPA(略称)一分子のS₁の励起エネルギーは、3.508 eVであり、蛍光波長は、353.4 nmであった。また、TPA(略称)一分子のT₁の励起エネルギーは、2.610 eVであり、燐光波長は、474.7 nmであった。

【0066】

ここで、DBq(略称)とTPA(略称)の二量体のS₁とT₁における最適分子構造から得られた励起エネルギーを示す。DBq(略称)とTPA(略称)の二量体のS₁の励起エネルギーは、2.036 eVであり、蛍光波長は、609.1 nmであった。また、DBq(略称)とTPA(略称)の二量体のT₁の励起エネルギーは、2.030 eVであり、燐光波長は、610.0 nmであった。

10

【0067】

以上のことから、DBq(略称)とTPA(略称)の二量体の蛍光波長は、DBq(略称)一分子やTPA(略称)一分子の蛍光波長に比べ、より長波長側に存在することがわかる。そして、DBq(略称)とTPA(略称)の二量体の蛍光波長と燐光波長の差はわずか0.9 nmであり、ほぼ同じ波長であることがわかる。

【0068】

この結果から、励起錯体は一重項励起エネルギーと三重項励起エネルギーをほぼ同じエネルギーに集約することができると言える。したがって、上述したように、励起錯体はその一重項状態、及び三重項状態の双方から、燐光性化合物に対して効率よくエネルギー移動できることが示唆された。

20

【0069】

このような効果は、励起錯体をエネルギー移動の媒体に用いることによる特異な効果である。一般的には、ホスト材料の一重項励起状態あるいは三重項励起状態から、燐光性化合物へのエネルギー移動が考慮されている。一方、本発明の一態様では、ホスト材料と他の材料との励起錯体をまず形成させ、その励起錯体からのエネルギー移動を用いている点で従来と大きく異なる。そして、この相違点により、従来にない高い発光効率が得られているのである。

30

【0070】

なお、一般に、励起錯体を発光素子の発光層に用いると、発光色を制御できるなどの利用価値はあるものの、発光効率は大きく低下するのが常である。したがって、励起錯体を用いた発光素子は、高効率な発光素子を得るには適さないと従来は考えられてきた。しかしながら、本発明の一態様で示すように、励起錯体をエネルギー移動の媒体に用いることで、逆に極限まで発光効率を高めることができることを本発明者等は見出した。これは、従来の固定概念とは相反する技術思想である。

【0071】

なお、励起錯体の発光スペクトルと第3の有機化合物124(ゲスト材料)の吸収スペクトルを十分に重ねるために、発光スペクトルのピークのエネルギー値と、吸収スペクトルの最も低エネルギー側の吸収帯のピークのエネルギー値との差が0.3 eV以内であることが好ましい。より好ましくは0.2 eV以内であり、最も好ましいのは0.1 eV以内である。

40

【0072】

また、本発明の一態様である発光素子において、励起錯体の励起エネルギーは第3の有機化合物124(ゲスト材料)に十分にエネルギー移動し、励起錯体からの発光は実質的に観察されないことが好ましい。したがって、励起錯体を介して第3の有機化合物124(ゲスト材料)にエネルギーを移動して、第3の有機化合物124が、燐光を発することが好ましい。なお、第3の有機化合物124としては、三重項励起エネルギーを発光に変える発光性の材料であればよく、特に燐光性有機金属錯体であることが好ましい。

50

【0073】

次に、本発明の一態様である正孔輸送層112と発光層113のエネルギー準位の概念について、図5(A)、図5(B)、及び図5(C)を用いて説明を行う。なお、図5(A)、図5(B)、及び図5(C)は、正孔輸送層112(正孔輸送層112a、112b、112c)と発光層113のエネルギー準位を模式的に示した図である。

【0074】

なお、図5(A)、図5(B)、及び図5(C)に示す発光層113は、上記説明した励起錯体を形成する第1の有機化合物120と第2の有機化合物122との組み合わせである。

【0075】

図5(A)に示す正孔輸送層112aのエネルギー準位は、第2の有機化合物122(アシスト材料)よりもT₁準位が高く、且つ第2の有機化合物122(アシスト材料)よりもHOMO準位が低い1種類の有機化合物により正孔輸送層112aを形成する構成について、例示している。

【0076】

図5(A)に示す構成の場合、正孔輸送層112aのT₁準位が第2の有機化合物122(アシスト材料)よりも高いため、発光層113から正孔輸送層112aへ励起エネルギーが拡散しにくく、発光層113の発光効率を高めることができる。また、駆動開始電圧は、第2の有機化合物を適切に選ぶことにより(励起錯体の発光波長を適切に制御することにより)、十分に低くすることができる。しかしながら、素子の実用輝度領域での駆動電圧は、正孔輸送層112aのHOMO準位にも影響される。すなわち、発光層113よりも正孔輸送層112aのHOMO準位が低いため、正孔輸送層112aから発光層113への正孔の移動が潤滑に進まず、特に高輝度(実用輝度)領域でのI-V特性が悪くなる。その結果、駆動電圧を下げることが困難になる。

【0077】

次に、図5(B)に示す正孔輸送層112bのエネルギー準位は、第2の有機化合物122(アシスト材料)とT₁準位及びHOMO準位が同じ1種類の有機化合物により正孔輸送層112bを形成する構成について、例示している。すなわち、正孔輸送層112bが第2の有機化合物122(アシスト材料)と同種の材料により形成する場合である。

【0078】

図5(B)に示す構成の場合、励起錯体を形成する発光層113のHOMO準位と正孔輸送層112bのHOMO準位が同じため、極限まで発光層113の駆動電圧を下げることができる。しかしながら、発光層113の発光効率が低下するといった現象が見られる。この現象は、発光層113中の第2の有機化合物122(アシスト材料)と、同種の材料を正孔輸送層112bに用いるために、発光層113の三重項励起エネルギーが正孔輸送層112bにまで拡散するためだと考えられる。

【0079】

次に、図5(C)に示す正孔輸送層112cのエネルギー準位は、本発明の一態様であり、2種類以上の有機化合物により形成され、少なくとも第2の有機化合物122(アシスト材料)を有する正孔輸送層112cを形成する構成について、例示している。また、図5(C)に示す正孔輸送層112cのエネルギー準位は、第1の有機化合物120及び第2の有機化合物122よりもT₁準位が高く、且つ第2の有機化合物122よりもHOMO準位が低い第4の有機化合物126を有する正孔輸送層112cを形成する構成である。

【0080】

図5(C)に示す構成の場合、T₁準位の高い第4の有機化合物126の影響により、第2の有機化合物122よりもHOMO準位を低くすることができる。したがって、発光層113から正孔輸送層112cへ励起エネルギーが拡散しにくく、発光層113の発光効率を高めることができる。また、正孔輸送層112cは、HOMO準位の低い第4の有機化合物126を有しているにも関わらず、第2の有機化合物122を有するため、素子

10

20

30

40

50

の駆動開始電圧のみならず、実用輝度領域での駆動電圧をも下げることができる。

【0081】

また、本発明の一態様である発光素子において、第1の有機化合物120（ホスト材料）に螢光性化合物を用いると、第1の有機化合物120自体が発光しやすくなり、第3の有機化合物124（ゲスト材料）にエネルギー移動されにくくなる。この場合、第1の有機化合物120が効率よく発光すればよいが、第1の有機化合物120（ホスト材料）は濃度消光の問題が発生するため、高い発光効率を達成するのは困難である。したがって、第1の有機化合物120（ホスト材料）、及び第2の有機化合物122（アシスト材料）の少なくとも一方が螢光性化合物（すなわち、一重項励起状態から発光や熱失活が起こりやすい化合物）である場合が有効となる。したがって、第1の有機化合物120および第2の有機化合物122の少なくとも一方が螢光性化合物であることが好ましい。10

【0082】

以上のように、本実施の形態で示した発光素子は、励起錯体の発光スペクトルと第3の有機化合物（ゲスト材料）の吸収スペクトルとの重なりを利用したエネルギー移動により、エネルギー移動効率を高めることができるために、発光効率の高い発光素子を実現することができる。

【0083】

また、本実施の形態で示した発光素子は、発光層に用いる正孔輸送性を有する第2の有機化合物が、正孔輸送層にも含まれた素子構成である。このような構成とすることで、発光素子の駆動電圧、特に駆動開始電圧を正孔輸送層が有する第2の有機化合物により低くすることができる。また、本発明の一態様である発光素子は、第2の有機化合物だけで形成した正孔輸送層と比較し、第2の有機化合物以外の材料も有するため、発光層からの三重項励起エネルギーの拡散を第2の有機化合物以外の材料により抑制し、発光効率の高い優れた発光素子とすることができます。20

【0084】

なお、本実施の形態に示す構成は、他の実施の形態に示す構成と適宜組み合わせて用いることができる。

【0085】

（実施の形態2）

本実施の形態では、実施の形態1に示す発光素子の変形例について、図6を用いて説明する。なお、実施の形態1で示す発光素子と同様の機能を有する部分については、同様の符号を用い、その繰り返しの説明は省略する。30

【0086】

本実施の形態に示す発光素子は、図6に示すように、一対の電極（第1の電極101、第2の電極103）間に正孔注入層111と、正孔注入層111上に形成された正孔輸送層112と、正孔輸送層112上に形成された発光層113と、発光層113上に形成された電子輸送層114と、電子輸送層114上に形成された電子注入層115と、を有し、発光層113は、電子輸送性を有する第1の有機化合物120と、正孔輸送性を有する第2の有機化合物122と、三重項励起エネルギーを発光に変える発光性の第3の有機化合物124と、を有し、第1の有機化合物120と第2の有機化合物122は、励起錯体を形成する組み合わせであり、正孔輸送層112が2種類以上の有機化合物により形成され、少なくとも第2の有機化合物122を有する。40

【0087】

なお、発光層113において、第3の有機化合物124（ゲスト材料）を第1の有機化合物120（ホスト材料）及び第2の有機化合物122（アシスト材料）に分散させた構成とすることにより、発光層113の濃度が高いことによる濃度消光を抑制し、発光素子の発光効率を高めることができる。

【0088】

また、第1の有機化合物120（ホスト材料）、及び第2の有機化合物122（アシスト材料）は、励起錯体を形成する組み合わせである。50

【0089】

以下に本実施の形態に示す発光素子を作製するまでの具体例について説明する。

【0090】

基板100は発光素子の支持体として用いられる。基板100としては、例えばガラス、石英、又はプラスチックなどを用いることができる。また可撓性基板を用いてもよい。可撓性基板とは、曲げることができる(フレキシブル)基板のことであり、例えば、ポリカーボネート、ポリアリレート、ポリエーテルスルファンからなるプラスチック基板等が挙げられる。また、フィルム(ポリプロピレン、ポリエステル、ポリフッ化ビニル、ポリ塩化ビニル等からなる)、無機蒸着フィルムなどを用いることもできる。なお、発光素子の作製工程において支持体として機能するものであれば、これら以外のものでもよい。

10

【0091】

第1の電極101及び第2の電極103には、金属、合金、電気伝導性化合物、およびこれらの混合物などを用いることができる。具体的には、酸化インジウム-酸化スズ(ITO: Indium Tin Oxide)、珪素若しくは酸化珪素を含有した酸化インジウム-酸化スズ、酸化インジウム-酸化亜鉛、酸化タンゲステン及び酸化亜鉛を含有した酸化インジウム、金(Au)、白金(Pt)、ニッケル(Ni)、タンゲステン(W)、クロム(Cr)、モリブデン(Mo)、鉄(Fe)、コバルト(Co)、銅(Cu)、パラジウム(Pd)、チタン(Ti)の他、元素周期表の第1族または第2族に属する元素、すなわちリチウム(Li)やセシウム(Cs)等のアルカリ金属、およびマグネシウム(Mg)、カルシウム(Ca)、ストロンチウム(Sr)等のアルカリ土類金属、およびこれらを含む合金(MgAg、AlLi)、ユウロピウム(Eu)、イッテルビウム(Yb)等の希土類金属およびこれらを含む合金、その他グラフェン等を用いることができる。なお、第1の電極101及び第2の電極103は、例えばスパッタリング法や蒸着法(真空蒸着法を含む)等により形成することができる。なお、本実施の形態においては、第1の電極101を陽極として用い、第2の電極103を陰極として用いる。

20

【0092】

正孔注入層111及び正孔輸送層112に用いる正孔輸送性の高い物質としては、例えば、4,4'-ビス[N-(1-ナフチル)-N-フェニルアミノ]ビフェニル(略称:NPBまたは-NPD)やN,N'-ビス(3-メチルフェニル)-N,N'-ジフェニル-[1,1'-ビフェニル]-4,4'-ジアミン(略称:TPD)、4,4',4''-トリス(カルバゾール-9-イル)トリフェニルアミン(略称:TCTA)、4,4',4''-トリス(N,N-ジフェニルアミノ)トリフェニルアミン(略称:TDA-TA)、4,4',4'''-トリス[N-(3-メチルフェニル)-N-フェニルアミノ]トリフェニルアミン(略称:MTDATA)、4,4'-ビス[N-(スピロ-9,9'-ビフルオレン-2-イル)-N-フェニルアミノ]ビフェニル(略称:BSPB)などの芳香族アミン化合物、3-[N-(9-フェニルカルバゾール-3-イル)-N-フェニルアミノ]-9-フェニルカルバゾール(略称:PCzPCA1)、3,6-ビス[N-(9-フェニルカルバゾール-3-イル)-N-フェニルアミノ]-9-フェニルカルバゾール(略称:PCzPCA2)、3-[N-(1-ナフチル)-N-(9-フェニルカルバゾール-3-イル)アミノ]-9-フェニルカルバゾール(略称:PCzPCN1)等が挙げられる。その他、4,4'-ジ(N-カルバゾリル)ビフェニル(略称:CBP)、1,3,5-トリス[4-(N-カルバゾリル)フェニル]ベンゼン(略称:TCPB)、9-[4-(10-フェニル-9-アントラセニル)フェニル]-9H-カルバゾール(略称:CzPA)等のカルバゾール誘導体、等を用いることができる。また、後述する正孔輸送性材料を用いることもできる。ここに述べた物質は、主に10⁻⁶ cm²/Vs以上の正孔移動度を有する物質である。但し、電子よりも正孔の輸送性の高い物質であれば、これら以外のものを用いてもよい。

30

【0093】

さらに、正孔注入層111及び正孔輸送層112として、ポリ(N-ビニルカルバゾール)(略称:PVK)、ポリ(4-ビニルトリフェニルアミン)(略称:PVTPA)、

40

50

ポリ [N - (4 - { N ' - [4 - (4 - ジフェニルアミノ) フェニル] フェニル - N ' - フェニルアミノ } フェニル) メタクリルアミド] (略称 : P T P D M A) 、ポリ [N , N ' - ビス (4 - プチルフェニル) - N , N ' - ビス (フェニル) ベンジジン] (略称 : P o l y - T P D) などの高分子化合物を用いることもできる。

【 0 0 9 4 】

また、正孔注入層 111 に用いることができるアクセプター性物質としては、遷移金属酸化物や元素周期表における第 4 族乃至第 8 族に属する金属の酸化物を挙げができる。具体的には、酸化モリブデンが特に好ましい。

【 0 0 9 5 】

また、発光層 113 は、第 1 の有機化合物 120 (ホスト材料) 、第 2 の有機化合物 122 (アシスト材料) 、及び第 3 の有機化合物 124 (ゲスト材料) を有している。

【 0 0 9 6 】

第 1 の有機化合物 120 (ホスト材料) としては、電子輸送性材料を用いることが好ましい。また、第 2 の有機化合物 122 (アシスト材料) としては、正孔輸送性材料を用いることが好ましい。また、第 3 の有機化合物 124 (ゲスト材料) としては、三重項励起エネルギーを発光に変える発光性材料が好ましい。

【 0 0 9 7 】

上記電子輸送性材料としては、含窒素複素芳香族化合物のような 不足型複素芳香族化合物が好ましく、例えば、2 - (4 - ビフェニル) - 5 - (4 - t e r t - プチルフェニル) - 1 , 3 , 4 - オキサジアゾール (略称 : P B D) 、3 - (4 - ビフェニル) - 4 - フェニル - 5 - (4 - t e r t - プチルフェニル) - 1 , 2 , 4 - トリアゾール (略称 : T A Z) 、1 , 3 - ビス [5 - (p - t e r t - プチルフェニル) - 1 , 3 , 4 - オキサジアゾール - 2 - イル] ベンゼン (略称 : O X D - 7) 、9 - [4 - (5 - フェニル - 1 , 3 , 4 - オキサジアゾール - 2 - イル) フェニル] - 9 H - カルバゾール (略称 : C O 1 1) 、2 , 2 ' , 2 ' ' - (1 , 3 , 5 - ベンゼントリイル) トリス (1 - フェニル - 1 H - ベンゾイミダゾール) (略称 : T P B I) 、2 - [3 - (ジベンゾチオフェン - 4 - イル) フェニル] - 1 - フェニル - 1 H - ベンゾイミダゾール (略称 : m D B T B I m - I I) などのポリアゾール骨格を有する複素環化合物 (オキサジアゾール誘導体、イミダゾール誘導体、トリアゾール誘導体等) や、2 - [3 - (ジベンゾチオフェン - 4 - イル) フェニル] ジベンゾ [f , h] キノキサリン (略称 : 2 m D B T P D B q - I I) 、2 - [3 ' - (ジベンゾチオフェン - 4 - イル) ビフェニル - 3 - イル] ジベンゾ [f , h] キノキサリン (略称 : 2 m D B T B P D B q - I I) 、2 - [3 ' - (9 H - カルバゾール - 9 - イル) ビフェニル - 3 - イル] ジベンゾ [f , h] キノキサリン (略称 : 2 m C z B P D B q) 、4 , 6 - ビス [3 - (フェナントレン - 9 - イル) フェニル] ピリミジン (略称 : 4 , 6 m P n P 2 P m) 、4 , 6 - ビス [3 - (4 - ジベンゾチエニル) フェニル] ピリミジン (略称 : 4 , 6 m D B T P 2 P m - I I) などのジアジン骨格を有する複素環化合物 (ピラジン誘導体、ピリミジン誘導体、ピリダジン誘導体、キノキサリン誘導体、ジベンゾキノキサリン誘導体等) や、3 , 5 - ビス [(3 - 9 H - カルバゾール - 9 - イル) フェニル] ピリジン (略称 : 3 5 D C z P P y) 、1 , 3 , 5 - トリ [3 - (3 - ピリジル) フェニル] ベンゼン (略称 : T m P y P B) などのピリジン骨格を有する複素環化合物 (ピリジン誘導体、キノリン誘導体、ジベンゾキノリン誘導体等) が挙げられる。上述した中でも、ジアジン骨格を有する複素環化合物やピリジン骨格を有する複素環化合物は、信頼性が良好であり好ましい。特に、ジアジン (ピリミジンやピラジン) 骨格を有する複素環化合物は、電子輸送性が高く、駆動電圧低減にも寄与する。

【 0 0 9 8 】

また、上記正孔輸送性材料としては、過剰型複素芳香族化合物 (例えばカルバゾール誘導体やインドール誘導体) や芳香族アミン化合物が好ましく、例えば、4 , 4 ' - ビス [N - (1 - ナフチル) - N - フェニルアミノ] ビフェニル (略称 : N P B) 、N , N ' - ビス (3 - メチルフェニル) - N , N ' - ジフェニル - [1 , 1 ' - ビフェニル] - 4 , 4 ' - ジアミン (略称 : T P D) 、4 , 4 ' - ビス [N - (スピロ - 9 , 9 ' - ピフル

10

20

30

40

50

オレン - 2 - イル) - N フェニルアミノ] ビフェニル(略称: B S P B)、4 - フェニル - 4 ' - (9 - フェニルフルオレン - 9 - イル) トリフェニルアミン(略称: B P A F L P)、4 - フェニル - 3 ' - (9 - フェニルフルオレン - 9 - イル) トリフェニルアミン(略称: m B P A F L P)、4 - フェニル - 4 ' - (9 - フェニル - 9 H - カルバゾール - 3 - イル) トリフェニルアミン(略称: P C B A 1 B P)、4 , 4 ' - ジフェニル - 4 ' ' - (9 - フェニル - 9 H - カルバゾール - 3 - イル) トリフェニルアミン(略称: P C B B i 1 B P)、4 - (1 - ナフチル) - 4 ' - (9 - フェニル - 9 H - カルバゾール - 3 - イル) - トリフェニルアミン(略称: P C B A N B)、4 , 4 ' - ジ(1 - ナフチル) - 4 ' ' - (9 - フェニル - 9 H - カルバゾール - 3 - イル) トリフェニルアミン(略称: P C B N B B)、9 , 9 - ジメチル - N - フェニル - N - [4 - (9 - フェニル - 9 H - カルバゾール - 3 - イル) フェニル] - フルオレン - 2 - アミン(略称: P C B A F)、N - フェニル - N - [4 - (9 - フェニル - 9 H - カルバゾール - 3 - イル) フェニル] スピロ - 9 , 9 ' - ビフルオレン - 2 - アミン(略称: P C B A S F)などの芳香族アミン骨格を有する化合物や、1 , 3 - ビス(N - カルバゾリル) ベンゼン(略称: m C P)、4 , 4 ' - ジ(N - カルバゾリル) ビフェニル(略称: C B P)、3 , 6 - ビス(3 , 5 - ジフェニルフェニル) - 9 - フェニルカルバゾール(略称: C z T P)、3 , 3 ' - ビス(9 - フェニル - 9 H - カルバゾール)(略称: P C C P)などのカルバゾール骨格を有する化合物や、4 , 4 ' , 4 ' ' - (ベンゼン - 1 , 3 , 5 - トリイル) トリ(ジベンゾチオフェン)(略称: D B T 3 P - I I)、2 , 8 - ジフェニル - 4 - [4 - (9 - フェニル - 9 H - フルオレン - 9 - イル) フェニル] ジベンゾチオフェン(略称: D B T F L P - I I I)、4 - [4 - (9 - フェニル - 9 H - フルオレン - 9 - イル) フェニル] - 6 - フェニルジベンゾチオフェン(略称: D B T F L P - I V)などのチオフェン骨格を有する化合物や、4 , 4 ' , 4 ' ' - (ベンゼン - 1 , 3 , 5 - トリイル) トリ(ジベンゾフラン)(略称: D B F 3 P - I I)、4 - {3 - [3 - (9 - フェニル - 9 H - フルオレン - 9 - イル) フェニル] フェニル} ジベンゾフラン(略称: m m D B F F L B i - I I)などのフラン骨格を有する化合物が挙げられる。上述した中でも、芳香族アミン骨格を有する化合物やカルバゾール骨格を有する化合物は、信頼性が良好であり、また、正孔輸送性が高く、駆動電圧低減にも寄与するため好ましい。

【0099】

なお、これらの電子輸送性材料および正孔輸送性材料は、青色の領域に吸収スペクトルを有さないことが好ましい。具体的には、吸収スペクトルの吸収端が440 nm以下であることが好ましい。

【0100】

一方、三重項励起エネルギーを発光に変える発光性材料としては、例えば、燐光性材料や熱活性化遅延蛍光を示す熱活性化遅延蛍光(TADF)材料が挙げられる。

【0101】

燐光性材料として、例えば440 nm ~ 520 nmに発光のピークを有する燐光性材料としては、トリス{2 - [5 - (2 - メチルフェニル) - 4 - (2 , 6 - ジメチルフェニル) - 4 H - 1 , 2 , 4 - トリアゾール - 3 - イル - N²] フェニル - C} イリジウム(I I I)(略称: I r (m p p t z - d m p)₃)、トリス(5 - メチル - 3 , 4 - ジフェニル - 4 H - 1 , 2 , 4 - トリアゾラト)イリジウム(I I I)(略称: [I r (M p t z)₃])、トリス[4 - (3 - ビフェニル) - 5 - イソプロピル - 3 - フェニル - 4 H - 1 , 2 , 4 - トリアゾラト]イリジウム(I I I)(略称: I r (i P r p t z - 3 b)₃)のような4 H - トリアゾール骨格を有する有機金属イリジウム錯体や、トリス[3 - メチル - 1 - (2 - メチルフェニル) - 5 - フェニル - 1 H - 1 , 2 , 4 - トリアゾラト]イリジウム(I I I)(略称: [I r (M p t z 1 - m p)₃])、トリス(1 - メチル - 5 - フェニル - 3 - プロピル - 1 H - 1 , 2 , 4 - トリアゾラト)イリジウム(I I I)(略称: I r (P r p t z 1 - M e)₃)のような1 H - トリアゾール骨格を有する有機金属イリジウム錯体や、f a c - トリス[1 - (2 , 6 - ジイソプロピルフェニル) - 2 - フェニル - 1 H - イミダゾール]イリジウム(I I I)(略称: I r (i

10

20

30

40

50

P r p m i)₃)、トリス[3 - (2 , 6 - ジメチルフェニル) - 7 - メチルイミダゾ[1 , 2 - f] フェナントリジナト] イリジウム (I I I) (略称 : I r (d m p i m p t - M e)₃) のようなイミダゾール骨格を有する有機金属イリジウム錯体や、ビス[2 - (4 ' , 6 ' - ジフルオロフェニル) ピリジナト - N , C^{2'}] イリジウム (I I I) テトラキス (1 - ピラゾリル) ボラート (略称 : F I r 6) 、ビス[2 - (4 ' , 6 ' - ジフルオロフェニル) ピリジナト - N , C^{2'}] イリジウム (I I I) ピコリナート (略称 : F I r p i c) 、ビス{ 2 - [3 ' , 5 ' - ビス (トリフルオロメチル) フェニル] ピリジナト - N , C^{2'} } イリジウム (I I I) ピコリナート (略称 : I r (C F₃ p p y)₂ (p i c)) 、ビス[2 - (4 ' , 6 ' - ジフルオロフェニル) ピリジナト - N , C^{2'}] イリジウム (I I I) アセチルアセトナート (略称 : F I r (a c a c)) のような電子吸引基を有するフェニルピリジン誘導体を配位子とする有機金属イリジウム錯体が挙げられる。上述した中でも、4 H - トリアゾール骨格を有する有機金属イリジウム錯体は、信頼性や発光効率にも優れるため、特に好ましい。 10

【 0 1 0 2 】

また、例えば 5 2 0 n m ~ 6 0 0 n m に発光のピークを有する燐光性材料としては、トリス (4 - メチル - 6 - フェニルピリミジナト) イリジウム (I I I) (略称 : I r (m p p m)₃) 、トリス (4 - t - ブチル - 6 - フェニルピリミジナト) イリジウム (I I I) (略称 : I r (t B u p p m)₃) 、 (アセチルアセトナト) ビス (6 - メチル - 4 - フェニルピリミジナト) イリジウム (I I I) (略称 : I r (m p p m)₂ (a c a c)) 、 (アセチルアセトナト) ビス (6 - t e r t - ブチル - 4 - フェニルピリミジナト) イリジウム (I I I) (略称 : I r (t B u p p m)₂ (a c a c)) 、 (アセチルアセトナト) ビス [4 - (2 - ノルボルニル) - 6 - フェニルピリミジナト] イリジウム (I I I) (e n d o - , e x o - 混合物) (略称 : I r (n b p p m)₂ (a c a c)) 、 (アセチルアセトナト) ビス [5 - メチル - 6 - (2 - メチルフェニル) - 4 - フェニルピリミジナト] イリジウム (I I I) (略称 : I r (m p m p p m)₂ (a c a c)) 、 (アセチルアセトナト) ビス (4 , 6 - ジフェニルピリミジナト) イリジウム (I I I) (略称 : I r (d p p m)₂ (a c a c)) のようなピリミジン骨格を有する有機金属イリジウム錯体や、 (アセチルアセトナト) ビス (3 , 5 - ジメチル - 2 - フェニルピラジナト) イリジウム (I I I) (略称 : I r (m p p r - M e)₂ (a c a c)) 、 (アセチルアセトナト) ビス (5 - イソプロビル - 3 - メチル - 2 - フェニルピラジナト) イリジウム (I I I) (略称 : I r (m p p r - i P r)₂ (a c a c)) のようなピラジン骨格を有する有機金属イリジウム錯体や、トリス (2 - フェニルピリジナト - N , C^{2'}) イリジウム (I I I) (略称 : I r (p p y)₃) 、ビス (2 - フェニルピリジナト - N , C^{2'}) イリジウム (I I I) アセチルアセトナート (略称 : I r (p p y)₂ a c a c) 、ビス (ベンゾ[h] キノリナト) イリジウム (I I I) アセチルアセトナート (略称 : I r (b z q)₂ (a c a c)) 、トリス (ベンゾ[h] キノリナト) イリジウム (I I I) (略称 : I r (b z q)₃) 、トリス (2 - フェニルキノリナト - N , C^{2'}) イリジウム (I I I) (略称 : I r (p q)₃) 、ビス (2 - フェニルキノリナト - N , C^{2'}) イリジウム (I I I) アセチルアセトナート (略称 : I r (p q)₂ (a c a c)) のようなピリジン骨格を有する有機金属イリジウム錯体の他、トリス (アセチルアセトナト) (モノフェナントロリン) テルビウム (I I I) (略称 : T b (a c a c)₃ (P h e n)) のような希土類金属錯体が挙げられる。上述した中でも、ピリミジン骨格を有する有機金属イリジウム錯体は、信頼性や発光効率にも際だって優れるため、特に好ましい。 30

【 0 1 0 3 】

また、例えば 6 0 0 n m ~ 7 0 0 n m に発光のピークを有する燐光性材料としては、ビス[4 , 6 - ビス (3 - メチルフェニル) ピリミジナト] (ジイソブチリルメタナト) イリジウム (I I I) (略称 : I r (5 m d p p m)₂ (d i b m)) 、ビス[4 , 6 - ビス (3 - メチルフェニル) ピリミジナト] (ジピバロイルメタナト) イリジウム (I I I) (略称 : I r (5 m d p p m)₂ (d p m)) 、ビス[4 , 6 - ジ (ナフタレン - 1 - 40

イル)ピリミジナト] (ジピバロイルメタナト)イリジウム(III) (略称: Ir (d₁n_{pm})₂ (dpm)) のようなピリミジン骨格を有する有機金属イリジウム錯体や、(アセチルアセトナト)ビス(2,3,5-トリフェニルピラジナト)イリジウム(III) (略称: Ir (tppr)₂ (acac))、ビス(2,3,5-トリフェニルピラジナト) (ジピバロイルメタナト)イリジウム(III) (略称: Ir (tppr)₂ (dpm))、(アセチルアセトナト)ビス[2,3-ビス(4-フルオロフェニル)キノキサリナト]イリジウム(III) (略称: Ir (Fdpq)₂ (acac)) のようなピラジン骨格を有する有機金属イリジウム錯体や、トリス(1-フェニルイソキノリナト-N, C²)イリジウム(III) (略称: Ir (piq)₃)、ビス(1-フェニルイソキノリナト-N, C²)イリジウム(III)アセチルアセトナート (略称: Ir (piq)₂ acac) のようなピリジン骨格を有する有機金属イリジウム錯体の他、2,3,7,8,12,13,17,18-オクタエチル-21H, 23H-ポルフィリン白金(II) (略称: PtOEP) のような白金錯体や、トリス(1,3-ジフェニル-1,3-プロパンジオナト) (モノフェナントロリン) ヨーロピウム(III) (略称: Eu (DBM)₃ (Phen))、トリス[1-(2-テノイル)-3,3,3-トリフルオロアセトナト] (モノフェナントロリン) ヨーロピウム(III) (略称: Eu (TTA)₃ (Phen)) のような希土類金属錯体が挙げられる。上述した中でも、ピリミジン骨格を有する有機金属イリジウム錯体は、信頼性や発光効率にも際だって優れるため、特に好ましい。また、ピラジン骨格を有する有機金属イリジウム錯体は、色度の良い赤色発光が得られる。

10

20

【0104】

なお、TADF 材料における遅延蛍光とは、通常の蛍光と同様のスペクトルを持ちながら、寿命が著しく長い発光をいう。その寿命は、10⁻⁶秒以上、好ましくは10⁻³秒以上である。TADF 材料として、具体的には、フラーレンやその誘導体、プロフラビン等のアクリジン誘導体、エオシン等が挙げられる。また、マグネシウム(Mg)、亜鉛(Zn)、カドミウム(Cd)、スズ(Sn)、白金(Pt)、インジウム(In)、もしくはパラジウム(Pd)等を含む金属含有ポルフィリンが挙げられる。該金属含有ポルフィリンとしては、例えば、プロトポルフィリン-フッ化スズ錯体(SnF₂ (Proto IX))、メソポルフィリン-フッ化スズ錯体(SnF₂ (Meso IX))、ヘマトポルフィリン-フッ化スズ錯体(SnF₂ (Hemato IX))、コブロポルフィリンテトラメチルエステル-フッ化スズ錯体(SnF₂ (Copro III-4Me))、オクタエチルポルフィリン-フッ化スズ錯体(SnF₂ (OEP))、エチオポルフィリン-フッ化スズ錯体(SnF₂ (Etio I))、オクタエチルポルフィリン-塩化白金錯体(PtCl₂ (OEP))等が挙げられる。さらに、2-ビフェニル-4,6-ビス(12-フェニルインドロ[2,3-a]カルバゾール-11-イル)-1,3,5-トリアジン (略称: PIC-TRZ) 等の過剰型複素芳香環及び不足型複素芳香環を有する複素環化合物を用いることもできる。なお、過剰型複素芳香環と不足型複素芳香環とが直接結合した物質は、過剰型複素芳香環のドナー性と不足型複素芳香環のアクセプター性が共に強くなり、S₁ と T₁ のエネルギー差が小さくなるため、特に好ましい。

30

40

【0105】

ただし、上述した第1の有機化合物120 (ホスト材料)、第2の有機化合物122 (アシスト材料)、及び第3の有機化合物124 (ゲスト材料)にそれぞれ用いることができる材料は、これらに限定されることなく、励起錯体を形成できる組み合わせであり、励起錯体の発光スペクトルが、第3の有機化合物124 (ゲスト材料)の吸収スペクトルと重なり、励起錯体の発光スペクトルのピークが第3の有機化合物124 (ゲスト材料)の吸収スペクトルのピークよりも長波長なものであればよい。

【0106】

また、第1の有機化合物120 (ホスト材料)に電子輸送性材料を用い、第2の有機化合物122 (アシスト材料)に正孔輸送性材料を用いる場合、その混合比によってキャリ

50

アバランスを制御することができる。具体的には、第1の有機化合物120：第2の有機化合物122=1:9~9:1の範囲とするのが好ましい。

【0107】

電子輸送層114は、電子輸送性の高い物質を含む層である。電子輸送層114には、上述した電子輸送性材料の他、トリス(8-キノリノラト)アルミニウム(略称:Alq₃)、トリス(4-メチル-8-キノリノラト)アルミニウム(略称:Almq₃)、ビス(10-ヒドロキシベンゾ[*h*]キノリナト)ベリリウム(略称:BeBq₂)、BA1q、Zn(BOX)₂、ビス[2-(2-ヒドロキシフェニル)ベンゾチアゾラト]亜鉛(略称:Zn(BTZ)₂)などの金属錯体を用いることができる。また、2-(4-ビフェニル)-5-(4-tert-ブチルフェニル)-1,3,4-オキサジアゾール(略称:PB_D)、1,3-ビス[5-(p-tert-ブチルフェニル)-1,3,4-オキサジアゾール-2-イル]ベンゼン(略称:OXD-7)、3-(4-tert-ブチルフェニル)-4-フェニル-5-(4-ビフェニル)-1,2,4-トリアゾール(略称:TAZ)、3-(4-tert-ブチルフェニル)-4-(4-エチルフェニル)-5-(4-ビフェニル)-1,2,4-トリアゾール(略称:p-EtTAZ)、バソフェナントロリン(略称:BPhen)、バソキュプロイン(略称:BCP)、4,4'-ビス(5-メチルベンゾオキサゾール-2-イル)スチルベン(略称:BzOs)などの複素芳香族化合物も用いることができる。また、ポリ(2,5-ピリジン-ジイル)(略称:PPy)、ポリ[(9,9-ジヘキシルフルオレン-2,7-ジイル)-co-(ピリジン-3,5-ジイル)](略称:PF-Py)、ポリ[(9,9-ジオクチルフルオレン-2,7-ジイル)-co-(2,2'-ビピリジン-6,6'-ジイル)](略称:PF-BPy)のような高分子化合物を用いることもできる。ここに述べた物質は、主に10⁻⁶cm²/Vs以上の電子移動度を有する物質である。なお、正孔よりも電子の輸送性の高い物質であれば、上記以外の物質を電子輸送層114として用いてもよい。

【0108】

また、電子輸送層114は、単層のものだけでなく、上記物質からなる層が2層以上積層したものとしてもよい。

【0109】

電子注入層115は、電子注入性の高い物質を含む層である。電子注入層115には、フッ化リチウム(LiF)、フッ化セシウム(CsF)、フッ化カルシウム(CaF₂)、リチウム酸化物(LiO_x)等のようなアルカリ金属またはアルカリ土類金属の化合物を用いることができる。また、フッ化エルビウム(ErF₃)のような希土類金属化合物を用いることができる。また、上述した電子輸送層114を構成する物質を用いることもできる。

【0110】

あるいは、電子注入層115に、有機化合物と電子供与体(ドナー)とを混合してなる複合材料を用いてもよい。このような複合材料は、電子供与体によって有機化合物に電子が発生するため、電子注入性および電子輸送性に優れている。この場合、有機化合物としては、発生した電子の輸送に優れた材料であることが好ましく、具体的には、例え上述した電子輸送層114を構成する物質(金属錯体や複素芳香族化合物等)を用いることができる。電子供与体としては、有機化合物に対し電子供与性を示す物質であればよい。具体的には、アルカリ金属やアルカリ土類金属や希土類金属が好ましく、リチウム、セシウム、マグネシウム、カルシウム、エルビウム、イッテルビウム等が挙げられる。また、アルカリ金属酸化物やアルカリ土類金属酸化物が好ましく、リチウム酸化物、カルシウム酸化物、バリウム酸化物等が挙げられる。また、酸化マグネシウムのようなルイス塩基を用いることもできる。また、テトラチアフルバレン(略称:TTF)等の有機化合物を用いることもできる。

【0111】

なお、上述した正孔注入層111、正孔輸送層112、発光層113、電子輸送層11

10

20

30

40

50

4、電子注入層 115 は、それぞれ、蒸着法（真空蒸着法を含む）、インクジェット法、塗布法等の方法で形成することができる。

【0112】

また、上述した発光素子の発光層 113 で得られた発光は、第1の電極 101 及び第2の電極 103 のいずれか一方または両方を通り外部に取り出される。したがって、本実施の形態における第1の電極 101 及び第2の電極 103 のいずれか一方、または両方が透光性を有する電極となる。

【0113】

以上のように、本実施の形態で示した発光素子は、励起錯体の発光スペクトルと第3の有機化合物（ゲスト材料）の吸収スペクトルとの重なりを利用したエネルギー移動により、エネルギー移動効率を高めることができるために、発光効率の高い発光素子を実現することができる。

10

【0114】

また、本実施の形態で示した発光素子は、発光層に用いる正孔輸送性を有する第2の有機化合物が、正孔輸送層にも含まれた素子構成である。このような構成とすることで、発光素子の駆動電圧、特に駆動開始電圧を正孔輸送層が有する第2の有機化合物により低くすることができる。また、本発明の一態様である発光素子は、第2の有機化合物だけで形成した正孔輸送層と比較し、第2の有機化合物以外の材料も有するため、発光層からの三重項励起エネルギーの拡散を第2の有機化合物以外の材料により抑制し、発光効率の高い優れた発光素子とすることができます。

20

【0115】

また、本実施の形態で示した発光素子は、本発明の一態様であり、特に正孔輸送層及び発光層の構成に特徴を有する。したがって、本実施の形態で示した構成を適用することで、パッシブマトリクス型の発光装置やアクティブマトリクス型の発光装置などを作製することができ、これらは、いずれも本発明に含まれるものとする。

【0116】

なお、アクティブマトリクス型の発光装置の場合において、TFTの構造は、特に限定されない。例えば、スタガ型や逆スタガ型の TFT を適宜用いることができる。また、TFT 基板に形成される駆動用回路についても、N型およびP型の TFT からなるものでもよいし、N型の TFT または P型の TFT のいずれか一方のみからなるものであってもよい。さらに、TFT に用いられる半導体膜の結晶性についても特に限定されない。例えば、非晶質半導体膜、結晶性半導体膜、その他、酸化物半導体膜等を用いることができる。

30

【0117】

なお、本実施の形態に示す構成は、他の実施の形態に示す構成と適宜組み合わせて用いることができる。

【0118】

（実施の形態 3）

本実施の形態では、本発明の一態様として、電荷発生層を挟んで発光層を複数有する構造の発光素子（以下、タンデム型発光素子という）について説明する。

【0119】

40

本実施の形態に示す発光素子は、図 7 (A) に示すように一対の電極（第1の電極 301 及び第2の電極 303）間に、複数の発光層（第1の発光層 311、第2の発光層 312）を有するタンデム型発光素子である。

【0120】

本実施の形態において、第1の電極 301 は、陽極として機能する電極であり、第2の電極 303 は陰極として機能する電極である。なお、第1の電極 301 及び第2の電極 303 は、実施の形態 2 と同様な構成を用いることができる。また、複数の発光層（第1の発光層 311、第2の発光層 312）は、実施の形態 1 または実施の形態 2 で示した発光層と同様な構成であっても良いが、いずれかが同様の構成であっても良い。すなわち、第1の発光層 311 と第2の発光層 312 は、同じ構成であっても異なる構成であってもよ

50

く、その構成は実施の形態1または実施の形態2と同様なものを適用することができる。

【0121】

また、複数の発光層（第1の発光層311、第2の発光層312）の間には、電荷発生層313が設けられている。電荷発生層313は、第1の電極301と第2の電極303に電圧を印加したときに、一方の発光層に電子を注入し、他方の発光層に正孔を注入する機能を有する。本実施の形態の場合には、第1の電極301に第2の電極303よりも電位が高くなるように電圧を印加すると、電荷発生層313から第1の発光層311に電子が注入され、第2の発光層312に正孔が注入される。

【0122】

なお、電荷発生層313は、光の取り出し効率の点から、可視光に対して透光性を有する（具体的には、電荷発生層313に対する可視光の透過率が、40%以上）ことが好ましい。また、電荷発生層313は、第1の電極301や第2の電極303よりも低い導電率であっても機能する。

【0123】

電荷発生層313は、正孔輸送性の高い有機化合物に電子受容体（アクセプター）が添加された構成であっても、電子輸送性の高い有機化合物に電子供与体（ドナー）が添加された構成であってもよい。また、これらの両方の構成が積層されていても良い。

【0124】

正孔輸送性の高い有機化合物に電子受容体が添加された構成とする場合において、正孔輸送性の高い有機化合物としては、例えば、N P BやT P D、T D A T A、M T D A T A、4,4'-ビス[N-(スピロ-9,9'-ビフルオレン-2-イル)-N-フェニルアミノ]ビフェニル（略称：B S P B）などの芳香族アミン化合物等を用いることができる。ここに述べた物質は、主に $10^{-6} \text{ cm}^2 / \text{Vs}$ 以上の正孔移動度を有する物質である。但し、電子よりも正孔の輸送性の高い有機化合物であれば、上記以外の物質を用いても構わない。

【0125】

また、電子受容体としては、7,7,8,8-テトラシアノ-2,3,5,6-テトラフルオロキノジメタン（略称：F₄-TCNQ）、クロラニル等を挙げることができる。また、遷移金属酸化物を挙げることができる。また元素周期表における第4族乃至第8族に属する金属の酸化物を挙げることができる。具体的には、酸化バナジウム、酸化ニオブ、酸化タンタル、酸化クロム、酸化モリブデン、酸化タンゲステン、酸化マンガン、酸化レニウムは電子受容性が高いため好ましい。中でも特に、酸化モリブデンは大気中でも安定であり、吸湿性が低く、扱いやすいため好ましい。

【0126】

一方、電子輸送性の高い有機化合物に電子供与体が添加された構成とする場合において、電子輸送性の高い有機化合物としては、例えば、A l q、A l m q₃、B e B q₂、B A l qなど、キノリン骨格またはベンゾキノリン骨格を有する金属錯体等を用いることができる。また、この他、Z n (B O X)₂、Z n (B T Z)₂などのオキサゾール系、チアゾール系配位子を有する金属錯体なども用いることができる。さらに、金属錯体以外にも、P B DやO X D-7、T A Z、B P h e n、B C Pなども用いることができる。ここに述べた物質は、主に $10^{-6} \text{ cm}^2 / \text{Vs}$ 以上の電子移動度を有する物質である。なお、正孔よりも電子の輸送性の高い有機化合物であれば、上記以外の物質を用いても構わない。

【0127】

また、電子供与体としては、アルカリ金属またはアルカリ土類金属または希土類金属または元素周期表における第13族に属する金属およびその酸化物、炭酸塩を用いることができる。具体的には、リチウム(Li)、セシウム(Cs)、マグネシウム(Mg)、カルシウム(Ca)、イッテルビウム(Yb)、インジウム(Ind)、酸化リチウム、炭酸セシウムなどを用いることが好ましい。また、テトラチアナフタセンのような有機化合物を電子供与体として用いてもよい。

10

20

30

40

50

【0128】

なお、上述した材料を用いて電荷発生層313を形成することにより、発光層が積層された場合における駆動電圧の上昇を抑制することができる。

【0129】

図7(A)においては、発光層を2層有する発光素子について説明したが、図7(B)に示すように、n層(ただし、nは、3以上)の発光層を積層した発光素子についても、同様に適用することが可能である。本実施の形態に係る発光素子のように、一対の電極間に複数の発光層を有する場合、発光層と発光層との間に電荷発生層313を配置することで、電流密度を低く保ったまま、高輝度領域での発光が可能である。電流密度を低く保てるため、長寿命素子を実現できる。また、照明を応用例とした場合は、電極材料の抵抗による電圧降下を小さくできるので、大面積での均一発光が可能となる。また、低電圧駆動が可能で消費電力が低い発光装置を実現することができる。

10

【0130】

また、それぞれの発光層の発光色を異なるものにすることで、発光素子全体として、所望の色の発光を得ることができる。例えば、2つの発光層を有する発光素子において、第1の発光層の発光色と第2の発光層の発光色を補色の関係になるようにすることで、発光素子全体として白色発光する発光素子を得ることも可能である。なお、補色とは、混合すると無彩色になる色同士の関係をいう。つまり、補色の関係にある色を発光する物質から得られた光と混合すると、白色発光を得ることができる。

【0131】

20

また、3つの発光層を有する発光素子の場合でも同様であり、例えば、第1の発光層の発光色が赤色であり、第2の発光層の発光色が緑色であり、第3の発光層の発光色が青色である場合、発光素子全体としては、白色発光を得ることができる。

【0132】

なお、本実施の形態に示す構成は、他の実施の形態に示した構成と適宜組み合わせて用いることができる。

【0133】

(実施の形態4)

本実施の形態では、本発明の一態様である発光装置について説明する。

【0134】

30

本実施の形態に示す発光装置は、一対の電極間での光の共振効果を利用した微小光共振器(マイクロキャビティ)構造を有しており、図8に示す様に一対の電極(反射電極451及び半透過・半反射電極452)間に少なくともEL層455を有する発光素子を、複数有している。また、EL層455は、少なくとも正孔輸送層(図示しない)と、発光層454(454R、454G、454B)を有し、その他、正孔注入層、電子輸送層、電子注入層、電荷発生層などが含まれていても良い。

【0135】

第1の発光素子450Rは、反射電極451上に第1の透明導電層453aと、第1の発光層454B、第2の発光層454G、第3の発光層454Rを一部に含むEL層455と、半透過・半反射電極452とが順次積層された構造を有する。また、第2の発光素子450Gは、反射電極451上に第2の透明導電層453bと、EL層455と、半透過・半反射電極452とが順次積層された構造を有する。また、第3の発光素子450Bは、反射電極451上にEL層455と、半透過・半反射電極452とが順次積層された構造を有する。

40

【0136】

なお、上記発光素子(第1の発光素子450R、第2の発光素子450G、第3の発光素子450B)において、反射電極451、EL層455、半透過・半反射電極452は共通である。また、第1の発光層454Bでは、420nm以上480nm以下の波長領域にピークをもつ光(B)を発光させ、第2の発光層454Gでは、500nm以上550nm以下の波長領域にピークを持つ光(G)を発光させ、第3の発光層454Rで

50

は、600 nm 以上 760 nm 以下の波長領域にピークを持つ光 (_R) を発光させる。これにより、いずれの発光素子 (第 1 の発光素子 450R、第 2 の発光素子 450G、第 3 の発光素子 450B) でも、第 1 の発光層 454B、第 2 の発光層 454G、及び第 3 の発光層 454R からの発光が重ね合わされた、すなわち可視光領域に渡るプロードな光を発光させることができる。なお、上記より、波長の長さは、_B < _G < _R なる関係であるとする。

【 0137 】

本実施の形態に示す各発光素子は、それぞれ反射電極 451 と半透過・半反射電極 452 との間に E L 層 455 を挟んでなる構造を有しており、E L 層 455 に含まれる各発光層から全方向に射出される発光は、微小光共振器 (マイクロキャビティー) としての機能を有する反射電極 451 と半透過・半反射電極 452 とによって共振される。なお、反射電極 451 は、反射性を有する導電性材料により形成され、その膜に対する可視光の反射率が 40% ~ 100%、好ましくは 70% ~ 100% であり、かつその抵抗率が $1 \times 10^{-2} \Omega \cdot cm$ 以下の膜であるとする。また、半透過・半反射電極 452 は、反射性を有する導電性材料と光透過性を有する導電性材料とにより形成され、その膜に対する可視光の反射率が 20% ~ 80%、好ましくは 40% ~ 70% であり、かつその抵抗率が $1 \times 10^{-2} \Omega \cdot cm$ 以下の膜であるとする。

【 0138 】

また、本実施の形態では、各発光素子で、第 1 の発光素子 450R と第 2 の発光素子 450G にそれぞれ設けられた透明導電層 (第 1 の透明導電層 453a、第 2 の透明導電層 453b) の厚みを変えることにより、発光素子毎に反射電極 451 と半透過・半反射電極 452 の間の光学距離を変えている。つまり、各発光素子の各発光層から発光するプロードな光は、反射電極 451 と半透過・半反射電極 452 の間において、共振する波長の光を強め、共振しない波長の光を減衰させることができるために、素子毎に反射電極 451 と半透過・半反射電極 452 の間の光学距離を変えることにより、異なる波長の光を取り出すことができる。

【 0139 】

なお、光学距離 (光路長ともいう) とは、実際の距離に屈折率をかけたものであり、本実施の形態においては、実膜厚に n (屈折率) をかけたものを表している。すなわち、「光学距離 = 実膜厚 $\times n$ 」である。

【 0140 】

また、第 1 の発光素子 450R では、反射電極 451 から半透過・半反射電極 452 までの光学的距離を $m_R / 2$ (ただし、 m は 1 以上の自然数)、第 2 の発光素子 450G では、反射電極 451 から半透過・半反射電極 452 までの光学的距離を $m_G / 2$ (ただし、 m は 1 以上の自然数)、第 3 の発光素子 450B では、反射電極 451 から半透過・半反射電極 452 までの光学的距離を $m_B / 2$ (ただし、 m は 1 以上の自然数) としている。

【 0141 】

以上より、第 1 の発光素子 450R からは、主として E L 層 455 に含まれる第 3 の発光層 454R で発光した光 (_R) が取り出され、第 2 の発光素子 450G からは、主として E L 層 455 に含まれる第 2 の発光層 454G で発光した光 (_G) が取り出され、第 3 の発光素子 450B からは、主として E L 層 455 に含まれる第 1 の発光層 454B で発光した光 (_B) が取り出される。なお、各発光素子から取り出される光は、半透過・半反射電極 452 側からそれぞれ射出される。

【 0142 】

また、上記構成において、反射電極 451 から半透過・半反射電極 452 までの光学的距離は、厳密には反射電極 451 における反射領域から半透過・半反射電極 452 における反射領域までの距離である。しかし、反射電極 451 や半透過・半反射電極 452 における反射領域の位置を厳密に決定することは困難であるため、反射電極 451 と半透過・半反射電極 452 の任意の位置を反射領域と仮定することで充分に上述の効果を得ること

10

20

30

40

50

ができるものとする。

【0143】

次に、第1の発光素子450Rにおいて、第3の発光層454Rからの発光のうち、反射電極451によって反射されて戻ってきた光(第1の反射光)は、第3の発光層454Rから半透過・半反射電極452に直接入射する光(第1の入射光)と干渉を起こすため、反射電極451と第3の発光層454Rの光学的距離を $(2n_R - 1)R / 4$ (ただし、 n_R は1以上の自然数)に調節する。光学的距離を調節することにより、第1の反射光と第1の入射光との位相を合わせ、第3の発光層454Rからの発光を増幅させることができる。

【0144】

なお、反射電極451と第3の発光層454Rとの光学的距離とは、厳密には反射電極451における反射領域と第3の発光層454Rにおける発光領域との光学的距離ということができる。しかし、反射電極451における反射領域や第3の発光層454Rにおける発光領域の位置を厳密に決定することは困難であるため、反射電極451と第3の発光層454Rの任意の位置を、それぞれ反射領域、発光領域と仮定することで充分に上述の効果を得ることができるものとする。

【0145】

次に、第2の発光素子450Gにおいて、第2の発光層454Gからの発光のうち、反射電極451によって反射されて戻ってきた光(第2の反射光)は、第2の発光層454Gから半透過・半反射電極452に直接入射する光(第2の入射光)と干渉を起こすため、反射電極451と第2の発光層454Gの光学的距離を $(2n_G - 1)G / 4$ (ただし、 n_G は1以上の自然数)に調節する。光学的距離を調節することにより、第2の反射光と第2の入射光との位相を合わせ、第2の発光層454Gからの発光を増幅させることができる。

【0146】

なお、反射電極451と第2の発光層454Gとの光学的距離とは、厳密には反射電極451における反射領域と第2の発光層454Gにおける発光領域との光学的距離ということができる。しかし、反射電極451における反射領域や第2の発光層454Gにおける発光領域の位置を厳密に決定することは困難であるため、反射電極451と第2の発光層454Gの任意の位置を、それぞれ反射領域、発光領域と仮定することで充分に上述の効果を得ることができるものとする。

【0147】

次に、第3の発光素子450Bにおいて、第1の発光層454Bからの発光のうち、反射電極451によって反射されて戻ってきた光(第3の反射光)は、第1の発光層454Bから半透過・半反射電極452に直接入射する光(第3の入射光)と干渉を起こすため、反射電極451と第1の発光層454Bの光学的距離を $(2n_B - 1)B / 4$ (ただし、 n_B は1以上の自然数)に調節する。光学的距離を調節することにより、第3の反射光と第3の入射光との位相を合わせ、第1の発光層454Bからの発光を増幅させることができる。

【0148】

なお、反射電極451と第1の発光層454Bとの光学的距離とは、厳密には反射電極451における反射領域と第1の発光層454Bにおける発光領域との光学的距離ということができる。しかし、反射電極451における反射領域や第1の発光層454Bにおける発光領域の位置を厳密に決定することは困難であるため、反射電極451と第1の発光層454Bの任意の位置を、それぞれ反射領域、発光領域と仮定することで充分に上述の効果を得ることができるものとする。

【0149】

なお、上記構成において、いずれの発光素子もEL層に複数の発光層を有する構造を有しているが、本発明はこれに限られることはなく、例えば、実施の形態3で説明したタンデム型(積層型)発光素子の構成と組み合わせて、一つの発光素子に電荷発生層を挟んで

10

20

30

40

50

複数の発光層を形成する構成としてもよい。

【0150】

本実施の形態で示した発光装置は、マイクロキャビティ構造を有しており、同じ構成のE L層を有していても発光素子毎に異なる波長の光を取り出すことができるためR G Bの塗り分けが不要となる。従って、高精細化を実現することが容易であるなどの理由からフルカラー化を実現する上で有利である。また、特定波長の正面方向の発光強度を強めることができるとなるため、低消費電力化を図ることができる。この構成は、3色以上の画素を用いたカラーディスプレイ（画像表示装置）に適用する場合に、特に有用であるが、照明などの用途に用いてもよい。

【0151】

なお、本実施の形態に示す構成は、他の実施の形態に示す構成と適宜組み合わせて用いることができる。

【0152】

（実施の形態5）

本実施の形態では、本発明の一態様である発光素子を有する発光装置について説明する。

【0153】

また、上記発光装置は、パッシブマトリクス型の発光装置でもアクティブマトリクス型の発光装置でもよい。なお、本実施の形態に示す発光装置には、他の実施形態で説明した発光素子を適用することが可能である。

20

【0154】

本実施の形態では、アクティブマトリクス型の発光装置について図9を用いて説明する。

【0155】

なお、図9（A）は発光装置を示す上面図であり、図9（B）は図9（A）を鎖線A-Bで切断した断面図である。本実施の形態に係るアクティブマトリクス型の発光装置は、素子基板501上に設けられた画素部502と、駆動回路部（ソース線駆動回路）503と、駆動回路部（ゲート線駆動回路）504（504a及び504b）と、を有する。画素部502、駆動回路部503、及び駆動回路部504は、シール材505によって、素子基板501と封止基板506との間に封止されている。

30

【0156】

また、素子基板501上には、駆動回路部503、及び駆動回路部504に外部からの信号（例えば、ビデオ信号、クロック信号、スタート信号、又はリセット信号等）や電位を伝達する外部入力端子を接続するための引き回し配線507が設けられる。ここでは、外部入力端子としてFPC（フレキシブルプリントサーキット）508を設ける例を示している。なお、ここではFPCしか図示されていないが、このFPCにはプリント配線基板（PWB）が取り付けられていても良い。本明細書における発光装置には、発光装置本体だけでなく、それにFPCもしくはPWBが取り付けられた状態をも含むものとする。

【0157】

次に、断面構造について図9（B）を用いて説明する。素子基板501上には駆動回路部及び画素部が形成されているが、ここでは、ソース線駆動回路である駆動回路部503と、画素部502が示されている。

40

【0158】

駆動回路部503はnチャネル型TFT509とpチャネル型TFT510とを組み合わせたCMOS回路が形成される例を示している。なお、駆動回路部を形成する回路は、種々のCMOS回路、PMOS回路もしくはNMOS回路で形成しても良い。また、本実施の形態では、基板上に駆動回路を形成したドライバ一体型を示すが、必ずしもその必要はなく、基板上ではなく外部に駆動回路を形成することもできる。

【0159】

また、画素部502はスイッチング用TFT511と、電流制御用TFT512と電流

50

制御用 TFT 512 の配線 (ソース電極又はドレイン電極) に電気的に接続された第 1 の電極 513 とを含む複数の画素により形成される。なお、第 1 の電極 513 の端部を覆って絶縁物 514 が形成されている。ここでは、ポジ型の感光性アクリル樹脂を用いることにより形成する。なお、本実施の形態においては、第 1 の電極 513 を陽極として用いる。

【 0160 】

また、上層に積層形成される膜の被覆性を良好なものとするため、絶縁物 514 の上端部または下端部に曲率を有する曲面が形成されるようにするのが好ましい。例えば、絶縁物 514 の材料としてポジ型の感光性アクリル樹脂を用いた場合、絶縁物 514 の上端部に曲率半径 (0.2 μm ~ 3 μm) を有する曲面を持たせることができ。また、絶縁物 514 として、ネガ型の感光性樹脂、或いはポジ型の感光性樹脂のいずれも使用することができ、有機化合物に限らず無機化合物、例えば、酸化シリコン、酸窒化シリコン等、の両者を使用することができる。

【 0161 】

第 1 の電極 513 上には、EL 層 515 及び第 2 の電極 516 が積層形成されている。EL 層 515 は、少なくとも正孔輸送層、及び発光層が設けられている。正孔輸送層、及び発光層は、実施の形態 1 または実施の形態 2 で示した構成を適用することができる。なお、本実施の形態においては、第 2 の電極 516 を陰極として用いる。

【 0162 】

なお、第 1 の電極 513、EL 層 515 及び第 2 の電極 516 との積層構造で、発光素子 517 が形成されている。第 1 の電極 513、EL 層 515 及び第 2 の電極 516 の用いる材料としては、実施の形態 2 に示す材料を用いることができる。また、ここでは図示しないが、第 2 の電極 516 は外部入力端子である FPC 508 に電気的に接続されている。

【 0163 】

また、図 9 (B) に示す断面図では発光素子 517 を 1 つのみ図示しているが、画素部 502 において、複数の発光素子がマトリクス状に配置されているものとする。画素部 502 には、3 種類 (R、G、B) の発光が得られる発光素子をそれぞれ選択的に形成し、フルカラー表示可能な発光装置を形成することができる。また、カラーフィルタと組み合わせることによってフルカラー表示可能な発光装置としてもよい。

【 0164 】

さらに、シール材 505 で封止基板 506 を素子基板 501 と貼り合わせることにより、素子基板 501、封止基板 506、およびシール材 505 で囲まれた空間 518 に発光素子 517 が備えられた構造になっている。なお、空間 518 には、不活性気体 (窒素やアルゴン等) が充填される場合の他、シール材 505 で充填される構成も含むものとする。

【 0165 】

なお、シール材 505 にはエポキシ系樹脂を用いるのが好ましい。また、これらの材料はできるだけ水分や酸素を透過しない材料であることが望ましい。また、封止基板 506 に用いる材料としてガラス基板や石英基板の他、FRP (Fiberglass-Reinforced Plastic)、PVF (ポリビニルフロライド)、ポリエチレンまたはアクリル等からなるプラスチック基板を用いることができる。

【 0166 】

以上のようにして、アクティブマトリクス型の発光装置を得ることができる。

【 0167 】

なお、本実施の形態に示す構成は、他の実施の形態に示した構成を適宜組み合わせて用いることができる。

【 0168 】

(実施の形態 6)

本実施の形態では、上記実施の形態に示す本発明の一態様の発光装置をその一部に含む

10

20

30

40

50

電子機器について説明する。電子機器としては、ビデオカメラ、デジタルカメラ等のカメラ、ゴーグル型ディスプレイ、ナビゲーションシステム、音響再生装置（カーオーディオ、オーディオコンポ等）、コンピュータ、ゲーム機器、携帯情報端末（モバイルコンピュータ、携帯電話、スマートフォン、携帯型ゲーム機、電子書籍、またはタブレット型端末等）、記録媒体を備えた画像再生装置（具体的には、Digital Versatile Disc (DVD) 等の記録媒体を再生し、その画像を表示しうる表示装置を備えた装置）などが挙げられる。これらの電子機器の具体例について、図10、及び図11を用いて説明する。

【0169】

図10(A)は、本発明の一態様に係るテレビ装置であり、筐体611、支持台612、表示部613、スピーカー部614、ビデオ入力端子615等を含む。このテレビ装置において、表示部613には、本発明の一態様の発光装置を適用することができる。本発明の一態様の発光装置は、低駆動電圧で、高い電流効率が得られるため、本発明の一態様の発光装置を適用することで、消費電力の低減されたテレビ装置を得ることができる。

10

【0170】

図10(B)は、本発明の一態様に係るコンピュータであり、本体621、筐体622、表示部623、キーボード624、外部接続ポート625、ポインティングデバイス626等を含む。このコンピュータにおいて、表示部623には、本発明の一態様の発光装置を適用することができる。本発明の一態様の発光装置は、低駆動電圧で、高い電流効率が得られるため、本発明の一態様の発光装置を適用することで、消費電力の低減されたコンピュータを得ることができる。

20

【0171】

図10(C)は、本発明の一態様に係る携帯電話であり、本体631、筐体632、表示部633、音声入力部634、音声出力部635、操作キー636、外部接続ポート637、アンテナ638等を含む。この携帯電話において、表示部633には、本発明の一態様の発光装置を適用することができる。本発明の一態様の発光装置は、低駆動電圧で、高い電流効率が得られるため、本発明の一態様の発光装置を適用することで、消費電力の低減された携帯電話を得ることができる。

【0172】

図10(D)は、本発明の一態様に係るカメラであり、本体641、表示部642、筐体643、外部接続ポート644、リモコン受信部645、受像部646、バッテリー647、音声入力部648、操作キー649、接眼部650等を含む。このカメラにおいて、表示部642には、本発明の一態様の発光装置を適用することができる。本発明の一態様の発光装置は、低駆動電圧で、高い電流効率が得られるため、本発明の一態様の発光装置を適用することで、消費電力の低減されたカメラを得ることができる。

30

【0173】

図11は、本発明の一態様に係る携帯型端末の一例であり、図11(A)、図11(B)、及び図11(C)は、携帯型端末5000を示し、図11(D)は、携帯型端末6000を示している。

40

【0174】

図11(A)、図11(B)、及び図11(C)に示す携帯型端末5000において、図11(A)は正面図を、図11(B)は側面図を、図11(C)は背面図を、それぞれ示している。また、図11(D)に示す携帯型端末6000においては、正面図を示している。

【0175】

携帯型端末5000は、筐体5001、表示部5003、電源ボタン5005、前面カメラ5007、背面カメラ5009、第1の外部接続端子5011、及び第2の外部接続端子5013などにより構成されている。

【0176】

また、表示部5003は、筐体5001に組み込まれており、タッチパネルとしても用

50

いることができる。例えば、表示部 5003 上にアイコン 5015 等を表示させて、メールや、スケジュール管理といった作業を行うことができる。また、筐体 5001 には、正面側に前面カメラ 5007 が組み込まれており、使用者側の映像を撮影することができる。また、筐体 5001 には、背面側に背面カメラ 5009 が組み込まれており、使用者と反対側の映像を撮影することができる。また、筐体 5001 には、第 1 の外部接続端子 5011、及び第 2 の外部接続端子 5013 を備えており、例えば、第 1 の外部接続端子 5011 により、イヤホン等に音声を出力し、第 2 の外部接続端子 5013 により、データの移動等を行うことができる。

【 0177 】

次に、図 11 (D) に示す携帯型端末 6000 は、第 1 の筐体 6001、第 2 の筐体 6003、ヒンジ部 6005、第 1 の表示部 6007、第 2 の表示部 6009、電源ボタン 6011、第 1 のカメラ 6013、第 2 のカメラ 6015 などにより構成されている。

【 0178 】

また、第 1 の表示部 6007 は、第 1 の筐体 6001 に組み込まれてあり、第 2 の表示部 6009 は、第 2 の筐体 6003 に組み込まれている。第 1 の表示部 6007、及び第 2 の表示部 6009 は、例えば、第 1 の表示部 6007 を表示用パネルとして使用し、第 2 の表示部 6009 をタッチパネルとする。第 1 の表示部 6007 に表示されたテキストアイコン 6017 を確認し、第 2 の表示部 6009 に表示させたアイコン 6019、またはキーボード 6021 (第 2 の表示部 6009 に表示されたキーボード画像) を用いて、画像の選択、または文字の入力等を行うことができる。もちろん、第 1 の表示部 6007 がタッチパネルであり、第 2 の表示部 6009 が表示用パネルといった構成や、第 1 の表示部 6007、及び第 2 の表示部 6009 ともにタッチパネルといった構成としてもよい。

【 0179 】

また、第 1 の筐体 6001 と、第 2 の筐体 6003 は、ヒンジ部 6005 により接続されており、第 1 の筐体 6001 と、第 2 の筐体 6003 と、を開閉することができる。このような構成とすることにより、携帯型端末 6000 を持ち運ぶ際に、第 1 の筐体 6001 に組み込まれた第 1 の表示部 6007 と、第 2 の筐体 6003 に組み込まれた第 2 の表示部 6009 と、を合わせることで、第 1 の表示部 6007、及び第 2 の表示部 6009 の表面 (例えば、プラスチック基板等) を保護することができるので好適である。

【 0180 】

また、第 1 の筐体 6001 と第 2 の筐体 6003 は、ヒンジ部 6005 により、分離できる構成としても良い (所謂コンバーチブル型)。このような構成とすることで、例えば、第 1 の筐体 6001 を縦置きとし、第 2 の筐体 6003 を横置きとして使用するといったように、使用範囲が広がるので好適である。

【 0181 】

また、第 1 のカメラ 6013、及び第 2 のカメラ 6015 により、3D 画像の撮影を行うこともできる。

【 0182 】

また、携帯型端末 5000、及び携帯型端末 6000 は、無線で情報を送受信できる構成としてもよい。例えば、無線により、インターネット等に接続し、所望の情報を購入し、ダウンロードする構成とすることも可能である。

【 0183 】

また、携帯型端末 5000、及び携帯型端末 6000 は、様々な情報 (静止画、動画、テキスト画像など) を表示する機能、カレンダー、日付又は時刻などを表示部に表示する機能、表示部に表示した情報をタッチ入力操作又は編集するタッチ入力機能、様々なソフトウェア (プログラム) によって処理を制御する機能、等を有することができる。また、外光の光量に応じて表示の輝度を最適にすることができる光センサや、ジャイロ、加速度センサの傾きを検出するセンサなどといった検出装置を内蔵させてよい。

【 0184 】

10

20

30

40

50

携帯型端末 5000 の表示部 5003、並びに携帯型端末 6000 の第 1 の表示部 6007、または / および第 2 の表示部 6009 において、本発明の一態様の発光装置を適用することができる。本発明の一態様の発光装置は、低駆動電圧で、高い電流効率が得られるため、本発明の一態様の発光装置を適用することで、消費電力の低減された携帯型端末を得ることができる。

【0185】

以上のように、本発明の一態様の発光装置の適用範囲は極めて広く、この発光装置をあらゆる分野の電子機器に適用することが可能である。本発明の一態様の発光装置を用いることにより、消費電力の低減された電子機器を得ることができる。

【0186】

また、本発明の一態様の発光装置は、照明装置として用いることもできる。照明装置の具体例について、図 12 を用いて説明する。

【0187】

図 12 (A) は、本発明の一態様の発光装置をバックライトとして用いた液晶表示装置の一例である。図 12 (A) に示した液晶表示装置は、筐体 701、液晶パネル 702、バックライト 703、筐体 704 を有し、液晶パネル 702 は、ドライバ IC 705 と接続されている。また、バックライト 703 は、本発明の一態様の発光装置が用いられおり、端子 706 により、電流が供給されている。このように本発明の一態様の発光装置を液晶表示装置のバックライトとして用いることにより、低消費電力のバックライトが得られる。また、本発明の一態様の発光装置は、面発光の照明装置であり大面積化も可能であるため、バックライトの大面積化も可能である。従って、低消費電力であり、大面積化された液晶表示装置を得ることができる。

【0188】

図 12 (B) は、本発明の一態様の発光装置を、照明装置である電気スタンドとして用いた例である。図 12 (B) に示す電気スタンドは、筐体 801 と、光源 802 を有し、光源 802 として、本発明の一態様の発光装置が用いられている。低駆動電圧で、高い電流効率が得られるため、本発明の一態様の発光装置を適用することで、低消費電力の電気スタンドを得ることが可能となる。

【0189】

図 12 (C) は、本発明の一態様の発光装置を、室内の照明装置 901 として用いた例である。本発明の一態様の発光装置は大面積化も可能であるため、大面積の照明装置として用いることができる。また、本発明の一態様の発光装置は、低駆動電圧で、高い電流効率が得られるため、本発明の一態様の発光装置を適用することで、低消費電力の照明装置を得ることが可能となる。このように、本発明の一態様の発光装置を、室内の照明装置 901 として用いた部屋に、図 10 (A) で説明したような、本発明の一態様のテレビ装置 902 を設置して公共放送や映画を鑑賞することができる。

【0190】

なお、本実施の形態は、他の実施の形態と適宜組み合わせることが可能である。

【実施例 1】

【0191】

本実施例では、本発明の一態様の発光素子（発光素子 1）、並びに比較用の発光素子（比較発光素子 2、比較発光素子 3、及び比較発光素子 4）について、図 13 を用いて説明する。また、本実施例で用いる材料の化学式を以下に示す。

【0192】

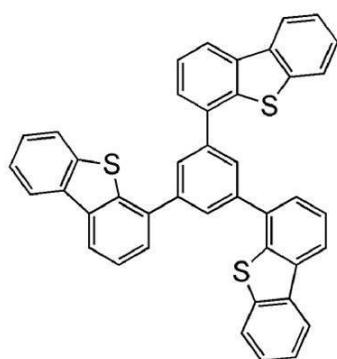
10

20

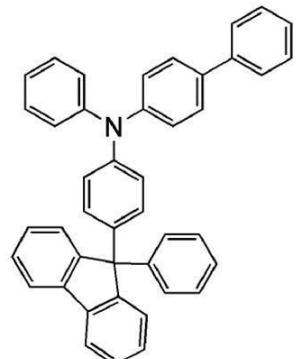
30

40

【化1】

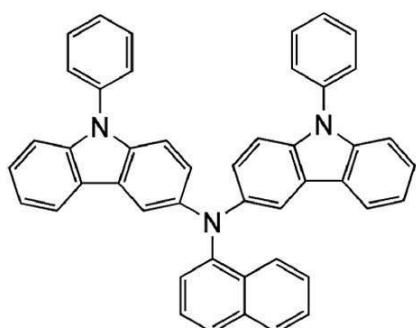


DBT3P-II

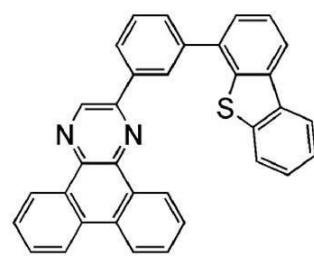


BPAFLP

10

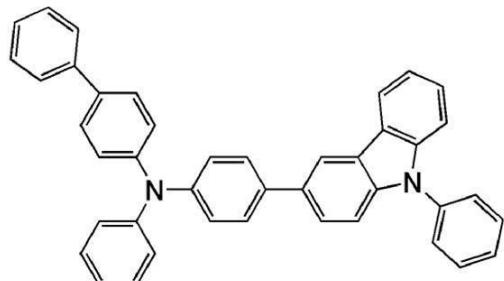


PCzPCN1



2mDBTPDBq-II

20

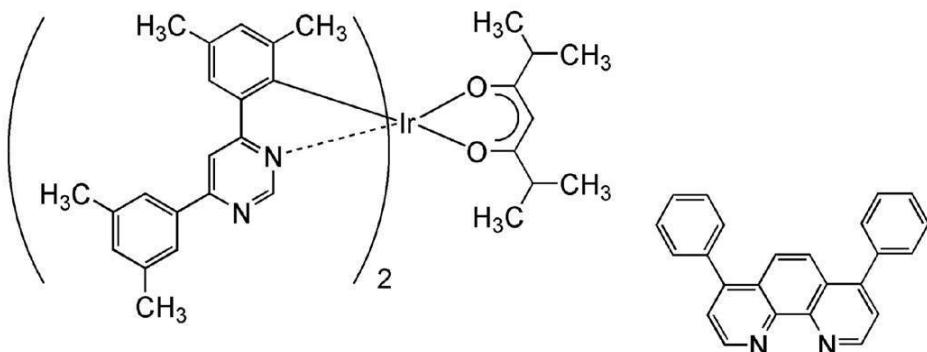


PCBA1BP

30

【0193】

【化2】



10

[Ir(dmdppm)₂(dibm)]

BPhen

【0194】

以下に、本実施例の発光素子1、比較発光素子2、比較発光素子3、及び比較発光素子4の作製方法を示す。

【0195】

(発光素子1)

まず、基板1100上に、珪素若しくは酸化珪素を含有した酸化インジウム-酸化スズ化合物(ITO-SiO₂、以下ITOと略記する。)をスパッタリング法にて成膜し、第1の電極1101を形成した。なお、用いたターゲットの組成は、In₂O₃:SnO₂:SiO₂=85:10:5[重量%]とした。また、第1の電極1101の膜厚は、110nmとし、電極面積は2mm×2mmとした。ここで、第1の電極1101は、発光素子の陽極として機能する電極である。

20

【0196】

次に、基板1100上に発光素子を形成するための前処理として、基板表面を水で洗浄し、200℃で1時間焼成した後、UVオゾン処理を370秒行った。

【0197】

その後、10⁻⁴Pa程度まで内部が減圧された真空蒸着装置に基板を導入し、真空蒸着装置内の加熱室において、170℃で30分間の真空焼成を行った後、基板1100を30分程度放冷した。

30

【0198】

次に、第1の電極1101が形成された面が下方となるように、第1の電極1101が形成された基板1100を真空蒸着装置内に設けられた基板ホルダーに固定し、10⁻⁴Pa程度まで減圧した後、第1の電極1101上に、抵抗加熱を用いた蒸着法により、4,4',4''-(ベンゼン-1,3,5-トリイル)トリ(ジベンゾチオフェン)(略称:DBT3P-II)と酸化モリブデンを共蒸着することで、正孔注入層1111を形成した。その膜厚は、40nmとし、DBT3P-II(略称)と酸化モリブデンの比率は、重量比で4:2(=DBT3P-II:酸化モリブデン)となるように調節した。なお、共蒸着法とは、一つの処理室内で、複数の蒸発源から同時に蒸着を行う蒸着法である。

40

【0199】

次に、正孔注入層1111上に、4-フェニル-4'-(9-フェニルフルオレン-9-イル)トリフェニルアミン(略称:BPAFLP)と3-[N-(1-ナフチル)-N-(9-フェニルカルバゾール-3-イル)アミノ]-9-フェニルカルバゾール(略称:PCzPCN1)を共蒸着することで、正孔輸送層1112を形成した。その膜厚は、20nmとし、BPAFLP(略称)とPCzPCN1(略称)の比率は、重量比で0.5:0.5(=BPAFLP:PCzPCN1)となるように調節した。

【0200】

50

次に、正孔輸送層 1112 上に、2-[3-(ジベンゾチオフェン-4-イル)フェニル]ジベンゾ[*f*, *h*]キノキサリン(略称: 2mDBTPDBq-II)と、PCzP CN1(略称)と、ビス{2-[6-(3,5-ジメチルフェニル)-4-ピリミジニル-N3]-4,6-ジメチルフェニル-C}(2,6-ジメチル-3,5-ヘプタンジオナト-²O,O')イリジウム(III)(略称: [Ir(dmdppm)₂(dibm)])と、を共蒸着し、第1の発光層 1113a を形成した。ここで、2mDBTPDBq-II(略称)、PCzP CN1(略称)、及び[Ir(dmdppm)₂(dibm)](略称)の重量比は、0.7:0.3:0.06(=2mDBTPDBq-II:PCzP CN1:[Ir(dmdppm)₂(dibm)])となるように調節した。また、第1の発光層 1113a の膜厚は 20 nm とした。

10

【0201】

なお、第1の発光層 1113aにおいて、2mDBTPDBq-II(略称)は、第1の有機化合物(ホスト材料)であり、PCzP CN1(略称)は、第2の有機化合物(アシスト材料)であり、[Ir(dmdppm)₂(dibm)](略称)は、第3の有機化合物(ゲスト材料)である。

【0202】

次に、第1の発光層 1113a 上に、2mDBTPDBq-II(略称)と、PCzP CN1(略称)と、[Ir(dmdppm)₂(dibm)](略称)と、を共蒸着し、第2の発光層 1113b を形成した。ここで、2mDBTPDBq-II(略称)、PCzP CN1(略称)、及び[Ir(dmdppm)₂(dibm)](略称)の重量比は、0.8:0.2:0.05(=2mDBTPDBq-II:PCzP CN1:[Ir(dmdppm)₂(dibm)])となるように調節した。また、第2の発光層 1113b の膜厚は 20 nm とした。

20

【0203】

なお、第2の発光層 1113bにおいて、2mDBTPDBq-II(略称)は、第1の有機化合物(ホスト材料)であり、PCzP CN1(略称)は、第2の有機化合物(アシスト材料)であり、[Ir(dmdppm)₂(dibm)](略称)は、第3の有機化合物(ゲスト材料)である。

【0204】

次に、第2の発光層 1113b 上に 2mDBTPDBq-II(略称)を膜厚 10 nm となるように成膜し、第1の電子輸送層 1114a を形成した。

30

【0205】

次に、第1の電子輸送層 1114a 上にバソフェナントロリン(略称: BPhen)を膜厚 20 nm となるように成膜し、第2の電子輸送層 1114b を形成した。

【0206】

次に、第2の電子輸送層 1114b 上に、フッ化リチウム(LiF)を 1 nm の膜厚で蒸着し、電子注入層 1115 を形成した。

【0207】

最後に、陰極として機能する第2の電極 1103 として、アルミニウム(Al)を 20 0 nm の膜厚となるように蒸着することで、本実施例の発光素子 1 を作製した。

40

【0208】

なお、上述した蒸着過程において、蒸着は全て抵抗加熱法を用いた。

【0209】

(比較発光素子 2)

比較発光素子 2 は、発光素子 1 と正孔輸送層 1112、第1の発光層 1113a、及び第2の発光層 1113b の構成が異なり、それ以外の構成は同じである。異なる構成のみ以下記載する。

【0210】

正孔注入層 1111 上に、BPAFLP(略称)を蒸着することで、正孔輸送層 1112 を形成した。その膜厚は、20 nm とした。

50

【0211】

正孔輸送層1112上に、2mDBTPDBq-II(略称)と、4-フェニル-4'-(9-フェニル-9H-カルバゾール-3-イル)トリフェニルアミン(略称:PCBA1Bp)と、[Ir(dmdppm)₂(dibm)](略称)と、を共蒸着し、第1の発光層1113aを形成した。ここで、2mDBTPDBq-II(略称)、PCBA1Bp(略称)、及び[Ir(dmdppm)₂(dibm)](略称)の重量比は、0.7:0.3:0.06(=2mDBTPDBq-II:PCBA1Bp:[Ir(dmdppm)₂(dibm)])となるように調節した。また、第1の発光層1113aの膜厚は20nmとした。

【0212】

10

なお、第1の発光層1113aにおいて、2mDBTPDBq-II(略称)は、第1の有機化合物(ホスト材料)であり、PCBA1Bp(略称)は、第2の有機化合物(アシスト材料)であり、[Ir(dmdppm)₂(dibm)](略称)は、第3の有機化合物(ゲスト材料)である。

【0213】

第1の発光層1113a上に、2mDBTPDBq-II(略称)と、PCBA1Bp(略称)と、[Ir(dmdppm)₂(dibm)](略称)と、を共蒸着し、第2の発光層1113bを形成した。ここで、2mDBTPDBq-II(略称)、PCBA1Bp(略称)、及び[Ir(dmdppm)₂(dibm)](略称)の重量比は、0.8:0.2:0.05(=2mDBTPDBq-II:PCBA1Bp:[Ir(dmdppm)₂(dibm)])となるように調節した。また、第2の発光層1113bの膜厚は20nmとした。

20

【0214】

なお、第2の発光層1113bにおいて、2mDBTPDBq-II(略称)は、第1の有機化合物(ホスト材料)であり、PCBA1Bp(略称)は、第2の有機化合物(アシスト材料)であり、[Ir(dmdppm)₂(dibm)](略称)は、第3の有機化合物(ゲスト材料)である。

【0215】

(比較発光素子3)

比較発光素子3は、発光素子1と正孔輸送層1112の構成が異なり、それ以外の構成は同じである。異なる構成のみ以下記載する。

30

【0216】

正孔注入層1111上に、BPAFLP(略称)を蒸着することで、正孔輸送層1112を形成した。その膜厚は、20nmとした。

【0217】

(比較発光素子4)

比較発光素子4は、発光素子1と正孔輸送層1112の構成が異なり、それ以外の構成は同じである。異なる構成のみ以下記載する。

【0218】

正孔注入層1111上に、PCzPCN1(略称)を蒸着することで、正孔輸送層1112を形成した。その膜厚は、20nmとした。

40

【0219】

以上により得られた発光素子1、比較発光素子2、比較発光素子3、及び比較発光素子4の素子構造を表1に示す。

【0220】

【表1】

	第1の電極	正孔注入層	正孔輸送層	第1の発光層	第2の発光層	第1の電子輸送層	第2の電子輸送層	電子注入層	第2の電極
発光素子1	ITSO 110nm	DBT3P-II:MoO _x (=4:2) 40nm	BPAFLP; PCzPCN1 (0.5:0.5) 20nm	下記記載	下記記載	2mDBTPDBq-II 10nm	BPhen 20nm	LiF 1nm	Al 200nm
比較 発光素子2	ITSO 110nm	DBT3P-II:MoO _x (=4:2) 40nm	BPAFLP 20nm	下記記載	下記記載	2mDBTPDBq-II 10nm	BPhen 20nm	LiF 1nm	Al 200nm
比較 発光素子3	ITSO 110nm	DBT3P-II:MoO _x (=4:2) 40nm	BPAFLP 20nm	下記記載	下記記載	2mDBTPDBq-II 10nm	BPhen 20nm	LiF 1nm	Al 200nm
比較 発光素子4	ITSO 110nm	DBT3P-II:MoO _x (=4:2) 40nm	PCzPCN1 20nm	下記記載	下記記載	2mDBTPDBq-II 10nm	BPhen 20nm	LiF 1nm	Al 200nm

10

	第1の発光層	第2の発光層
発光素子1	2mDBTPDBq-II:PCzPCN1:Ir(dmdppm) ₂ (dibm) (=0.7:0.3:0.06) 20nm	2mDBTPDBq-II:PCzPCN1:Ir(dmdppm) ₂ (dibm) (=0.8:0.2:0.05) 20nm
比較 発光素子2	2mDBTPDBq-II:PCBA1BP:Ir(dmdppm) ₂ (dibm) (=0.7:0.3:0.06) 20nm	2mDBTPDBq-II:PCBA1BP:Ir(dmdppm) ₂ (dibm) (=0.8:0.2:0.05) 20nm
比較 発光素子3	2mDBTPDBq-II:PCzPCN1:Ir(dmdppm) ₂ (dibm) (=0.7:0.3:0.06) 20nm	2mDBTPDBq-II:PCzPCN1:Ir(dmdppm) ₂ (dibm) (=0.8:0.2:0.05) 20nm
比較 発光素子4	2mDBTPDBq-II:PCzPCN1:Ir(dmdppm) ₂ (dibm) (=0.7:0.3:0.06) 20nm	2mDBTPDBq-II:PCzPCN1:Ir(dmdppm) ₂ (dibm) (=0.8:0.2:0.05) 20nm

20

【0221】

発光素子1、比較発光素子2、比較発光素子3、及び比較発光素子4を、窒素雰囲気のグローブボックス内において、各発光素子が大気に曝されないようにガラス基板により封止する作業（シール材を素子の周囲に塗布し、封止時に80にて1時間熱処理）を行った。その後、これらの発光素子の動作特性について測定を行った。なお、測定は室温（25に保たれた雰囲気）で行った。

【0222】

発光素子1、比較発光素子2、比較発光素子3、及び比較発光素子4の電流密度 - 輝度特性を図14に示す。図14において、横軸は電流密度（mA / cm²）を、縦軸は輝度（cd / m²）を表す。また、発光素子1、比較発光素子2、比較発光素子3、及び比較発光素子4の電圧 - 輝度特性を図15に示す。図15において、横軸は電圧（V）を、縦軸は輝度（cd / m²）を表す。また、発光素子1、比較発光素子2、比較発光素子3、及び比較発光素子4の輝度 - 電流効率特性を図16に示す。図16において、横軸は輝度（cd / m²）、縦軸は電流効率（cd / A）を表す。また、発光素子1、比較発光素子2、比較発光素子3、及び比較発光素子4の電圧 - 電流特性を図17に示す。図17において、横軸は電圧（V）を、縦軸は電流（mA）を表す。また、発光素子1、比較発光素子2、比較発光素子3、及び比較発光素子4の発光スペクトルを図18に示す。図18において、横軸は波長（nm）、縦軸は発光強度（任意単位）を表す。なお、図18において、各発光素子のデータが概略重なって示されている。

30

【0223】

また、各発光素子における輝度1000cd / m²付近のときの電圧（V）、電流密度（mA / cm²）、CIE色度座標（x、y）、電流効率（cd / A）、外部量子効率（%）を表2に示す。

【0224】

40

【表2】

	電圧(V)	電流密度 (mA/cm ²)	CIE色度座標		輝度 (cd/m ²)	電流効率 (cd/A)	外部 量子効率(%)
			x	y			
発光素子1	2.6	2.0	0.63	0.38	1036	53	28
比較発光素子2	3.0	2.2	0.63	0.37	1162	53	29
比較発光素子3	2.9	1.6	0.63	0.37	841	53	29
比較発光素子4	2.6	2.6	0.63	0.37	1217	47	26

10

【0225】

表2に示す通り、輝度1036cd/m²の発光素子1のCIE色度座標は、(x, y) = (0.63, 0.38)であった。また、輝度1162cd/m²の比較発光素子2のCIE色度座標は、(x, y) = (0.63, 0.37)であった。また、輝度841cd/m²の比較発光素子3のCIE色度座標は、(x, y) = (0.63, 0.37)であった。また、輝度1217cd/m²の比較発光素子4のCIE色度座標は、(x, y) = (0.63, 0.37)であった。

【0226】

また、輝度1036cd/m²の発光素子1の電圧は2.6Vであり、電流効率は53cd/Aであった。また、輝度1162cd/m²の比較発光素子2の電圧は3.0Vであり、電流効率は53cd/Aであった。また、輝度841cd/m²の比較発光素子3の電圧は2.9Vであり、電流効率は53cd/Aであった。また、輝度1217cd/m²の比較発光素子4の電圧は2.6Vであり、電流効率は47cd/Aであった。

20

【0227】

したがって、本発明の一態様である発光素子1は、比較発光素子2及び比較発光素子3と比べると、電圧を0.3V~0.4V低くすることができ、且つ電流効率を同等にできることが確認された。また、本発明の一態様である発光素子1は、比較発光素子4と比べると、電圧を同等に低減し、且つ電流効率を6cd/A高くできることが確認された。

【0228】

30

この結果は、以下のように説明できる。まず、本実施例で用いたPCzPcN1(略称)、PCBA1BP(略称)、及びBPAFLP(略称)の各薄膜でのHOMO準位は、それぞれ、-5.15eV、-5.42eV、-5.63eVである。なお、HOMO準位の値は、大気中の光電子分光法(理研計器社製、AC-2)で測定したイオン化ポテンシャルの値を、負の値に換算することにより得た。以下の実施例でも同様である。

【0229】

比較発光素子2の発光層に用いている第2の有機化合物(PCBA1BP)のHOMO準位は、発光素子1に用いている第2の有機化合物(PCzPcN1)のそれに比して低いため、それに伴って第1の有機化合物(2mDBTPDBq-II)との間で形成される励起錯体の波長も短波長シフトする。その結果、比較発光素子2の駆動開始電圧は高電圧側にシフトしている。一方、比較発光素子3および4は、発光層の構成は発光素子1と同じであるため、駆動開始電圧はほぼ同じである。

40

【0230】

しかしながら比較発光素子3は、正孔輸送層が発光層の第2の有機化合物(PCzPcN1)よりもHOMO準位がかなり低いBPAFLPのみからなっているため、正孔輸送層から発光層への正孔の移動が潤滑に進まず、高輝度(実用輝度)領域での電圧-電流特性が悪くなっていることがわかる。その結果、1000cd/m²付近での駆動電圧は、結局比較発光素子2と同様に高電圧シフトしてしまっている。

【0231】

比較発光素子4に関しては、正孔輸送層に発光層の第2の有機化合物(PCzPcN1)

50

)と同じ物質を用いているため、電圧 - 電流特性は発光素子1と概ね同じである。しかしながら、正孔輸送層がP C z P C N 1のみからなっているため、発光層の三重項励起エネルギーが正孔輸送層にまで拡散してしまい、外部量子効率（発光効率）および電流効率が低下していることがわかる。

【0232】

このように、本発明の一態様である発光素子1は、比較発光素子2～4と比べて、低い電圧を維持し、且つ高い電流効率であった。

【0233】

以上のように、本発明の一態様である発光素子は、発光層（第1の発光層1113a及び第2の発光層1113b）に用いる正孔輸送性を有する第2の有機化合物が、正孔輸送層1112にも含まれた素子構成である。このような構成とすることで、発光素子の電圧（駆動開始電圧および実用輝度領域での駆動電圧の双方）を正孔輸送層が有する第2の有機化合物により低くすることができます。また、本発明の一態様である発光素子は、第2の有機化合物だけで形成した正孔輸送層と比較し、第2の有機化合物以外の材料も有するため、発光層からの三重項励起エネルギーの拡散を第2の有機化合物以外の材料により抑制し、発光効率の高い優れた発光素子とすることができます。

10

【0234】

なお、本実施例（発光素子1）の発光層に用いた第1の有機化合物（2mD B T P D B q - I I）の薄膜のPLピーク波長は426nm、第2の有機化合物（P C z P C N 1）のPLピーク波長は479nmであるが、これらの混合膜のPLピーク波長は571nmであり、長波長シフトしていることがわかった。したがって、これら2種類の有機化合物は、励起錯体を形成する組み合わせである。

20

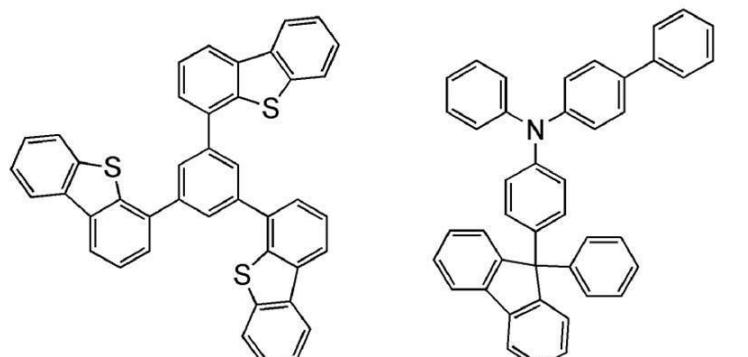
【実施例2】

【0235】

本実施例では、本発明の一態様の発光素子（発光素子5）、並びに比較用の発光素子（比較発光素子6、及び比較発光素子7）について、図13を用いて説明する。また、本実施例で用いる材料の化学式を以下に示す。

【0236】

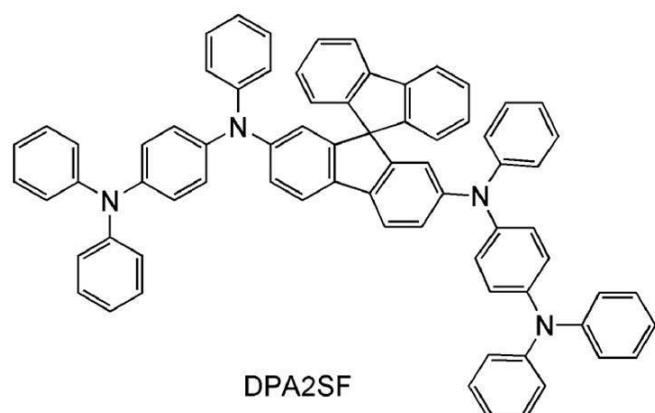
【化3】



10

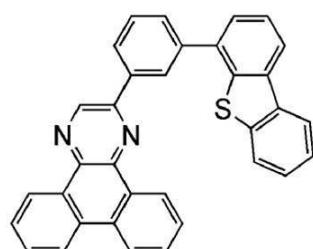
DBT3P-II

BPAFLP



20

DPA2SF

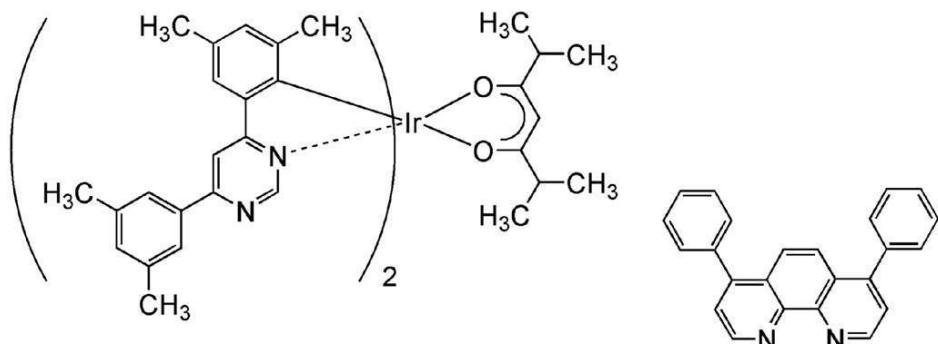


30

2mDBTPDBq-II

【0 2 3 7】

【化4】



40

[Ir(dmdppm)₂(dibm)]

BPhen

【0 2 3 8】

50

以下に、本実施例の発光素子5、比較発光素子6、及び比較発光素子7の作製方法を示す。

【0239】

(発光素子5)

まず、基板1100上に、珪素若しくは酸化珪素を含有した酸化インジウム-酸化スズ化合物(ITSO)をスパッタリング法にて成膜し、第1の電極1101を形成した。なお、用いたターゲットの組成は、 $In_2O_3 : SnO_2 : SiO_2 = 85 : 10 : 5$ [重量%]とした。また、第1の電極1101の膜厚は、110nmとし、電極面積は2mm \times 2mmとした。ここで、第1の電極1101は、発光素子の陽極として機能する電極である。

10

【0240】

次に、基板1100上に発光素子を形成するための前処理として、基板表面を水で洗浄し、200で1時間焼成した後、UVオゾン処理を370秒行った。

【0241】

その後、 10^{-4} Pa程度まで内部が減圧された真空蒸着装置に基板を導入し、真空蒸着装置内の加熱室において、170で30分間の真空焼成を行った後、基板1100を30分程度放冷した。

【0242】

次に、第1の電極1101が形成された面が下方となるように、第1の電極1101が形成された基板1100を真空蒸着装置内に設けられた基板ホルダーに固定し、 10^{-4} Pa程度まで減圧した後、第1の電極1101上に、抵抗加熱を用いた蒸着法により、DBT3P-II(略称)と酸化モリブデンを共蒸着することで、正孔注入層1111を形成した。その膜厚は、40nmとし、DBT3P-II(略称)と酸化モリブデンの比率は、重量比で4:2(=DBT3P-II:酸化モリブデン)となるように調節した。

20

【0243】

次に、正孔注入層1111上に、BPAFLP(略称)と2,7-ビス[N-(4-ジフェニルアミノフェニル)-N-フェニルアミノ]-スピロ-9,9'-ビフルオレン(略称:DPA2SF)を共蒸着することで、正孔輸送層1112を形成した。その膜厚は、20nmとし、BPAFLP(略称)とDPA2SF(略称)の比率は、重量比で0.5:0.5(=BPAFLP:DPA2SF)となるように調節した。

30

【0244】

次に、正孔輸送層1112上に、2mDBTPDBq-II(略称)と、DPA2SF(略称)と、[Ir(dmdppm)₂(dibm)](略称)と、を共蒸着し、第1の発光層1113aを形成した。ここで、2mDBTPDBq-II(略称)、DPA2SF(略称)、及び[Ir(dmdppm)₂(dibm)](略称)の重量比は、0.7:0.3:0.06(=2mDBTPDBq-II:DPA2SF:[Ir(dmdppm)₂(dibm)])となるように調節した。また、第1の発光層1113aの膜厚は20nmとした。

【0245】

なお、第1の発光層1113aにおいて、2mDBTPDBq-II(略称)は、第1の有機化合物(ホスト材料)であり、DPA2SF(略称)は、第2の有機化合物(アシスト材料)であり、[Ir(dmdppm)₂(dibm)](略称)は、第3の有機化合物(ゲスト材料)である。

40

【0246】

次に、第1の発光層1113a上に、2mDBTPDBq-II(略称)と、DPA2SF(略称)と、[Ir(dmdppm)₂(dibm)](略称)と、を共蒸着し、第2の発光層1113bを形成した。ここで、2mDBTPDBq-II(略称)、DPA2SF(略称)、及び[Ir(dmdppm)₂(dibm)](略称)の重量比は、0.8:0.2:0.05(=2mDBTPDBq-II:DPA2SF:[Ir(dmdppm)₂(dibm)])となるように調節した。また、第2の発光層1113bの膜

50

厚は 20 nm とした。

【 0 2 4 7 】

なお、第 2 の発光層 1113b において、2mDBTPDBq-II (略称) は、第 1 の有機化合物 (ホスト材料) であり、DPA2SF (略称) は、第 2 の有機化合物 (アシスト材料) であり、[Ir(dmdppm)₂ (dibm)] (略称) は、第 3 の有機化合物 (ゲスト材料) である。

【 0 2 4 8 】

次に、第 2 の発光層 1113b 上に 2mDBTPDBq-II (略称) を膜厚 10 nm となるように成膜し、第 1 の電子輸送層 1114a を形成した。

【 0 2 4 9 】

次に、第 1 の電子輸送層 1114a 上に Bphen (略称) を膜厚 20 nm となるように成膜し、第 2 の電子輸送層 1114b を形成した。

10

【 0 2 5 0 】

次に、第 2 の電子輸送層 1114b 上に、フッ化リチウム (LiF) を 1 nm の膜厚で蒸着し、電子注入層 1115 を形成した。

【 0 2 5 1 】

最後に、陰極として機能する第 2 の電極 1103 として、アルミニウム (Al) を 20 0 nm の膜厚となるように蒸着することで、本実施例の発光素子 5 を作製した。

【 0 2 5 2 】

なお、上述した蒸着過程において、蒸着は全て抵抗加熱法を用いた。

20

【 0 2 5 3 】

(比較発光素子 6)

比較発光素子 6 は、発光素子 5 と正孔輸送層 1112 の構成が異なり、それ以外の構成は同じである。異なる構成のみ以下記載する。

【 0 2 5 4 】

正孔注入層 1111 上に、BPAFLP (略称) を蒸着することで、正孔輸送層 1112 を形成した。その膜厚は、20 nm とした。

【 0 2 5 5 】

(比較発光素子 7)

比較発光素子 7 は、発光素子 5 と正孔輸送層 1112 の構成が異なり、それ以外の構成は同じである。異なる構成のみ以下記載する。

30

【 0 2 5 6 】

正孔注入層 1111 上に、DPA2SF (略称) を蒸着することで、正孔輸送層 1112 を形成した。その膜厚は、20 nm とした。

【 0 2 5 7 】

以上により得られた発光素子 5、比較発光素子 6、及び比較発光素子 7 の素子構造を表 3 に示す。

【 0 2 5 8 】

【表3】

	第1の電極	正孔注入層	正孔輸送層	第1の発光層	第2の発光層	第1の電子輸送層	第2の電子輸送層	電子注入層	第2の電極
発光素子5	ITSO 110nm	DBT3P-II:MoO _x (=4:2) 40nm	BPAFLP: DPA2SF (0.5:0.5) 20nm	下記記載	下記記載	2mDBTPDBq-II 10nm	BPhen 20nm	LiF 1nm	Al 200nm
比較発光素子6	ITSO 110nm	DBT3P-II:MoO _x (=4:2) 40nm	BPAFLP 20nm	下記記載	下記記載	2mDBTPDBq-II 10nm	BPhen 20nm	LiF 1nm	Al 200nm
比較発光素子7	ITSO 110nm	DBT3P-II:MoO _x (=4:2) 40nm	DPA2SF 20nm	下記記載	下記記載	2mDBTPDBq-II 10nm	BPhen 20nm	LiF 1nm	Al 200nm

	第1の発光層	第2の発光層
発光素子5	2mDBTPDBq-II:DPA2SF:Ir(dmdppm) ₂ (dibm) (=0.7:0.3:0.06) 20nm	2mDBTPDBq-II:DPA2SF:Ir(dmdppm) ₂ (dibm) (=0.8:0.2:0.05) 20nm
比較発光素子6	2mDBTPDBq-II:DPA2SF:Ir(dmdppm) ₂ (dibm) (=0.7:0.3:0.06) 20nm	2mDBTPDBq-II:DPA2SF:Ir(dmdppm) ₂ (dibm) (=0.8:0.2:0.05) 20nm
比較発光素子7	2mDBTPDBq-II:DPA2SF:Ir(dmdppm) ₂ (dibm) (=0.7:0.3:0.06) 20nm	2mDBTPDBq-II:DPA2SF:Ir(dmdppm) ₂ (dibm) (=0.8:0.2:0.05) 20nm

【0259】

発光素子5、比較発光素子6、及び比較発光素子7を、窒素雰囲気のグローブボックス内において、各発光素子が大気に曝されないようにガラス基板により封止する作業（シリアル材を素子の周囲に塗布し、封止時に80にて1時間熱処理）を行った。その後、これらの発光素子の動作特性について測定を行った。なお、測定は室温（25に保たれた雰囲気）で行った。

【0260】

発光素子5、比較発光素子6、及び比較発光素子7の電流密度-輝度特性を図19に示す。図19において、横軸は電流密度（mA/cm²）を、縦軸は輝度（cd/m²）を表す。また、発光素子5、比較発光素子6、及び比較発光素子7の電圧-輝度特性を図20に示す。図20において、横軸は電圧（V）を、縦軸は輝度（cd/m²）を表す。また、発光素子5、比較発光素子6、及び比較発光素子7の輝度-電流効率特性を図21に示す。図21において、横軸は輝度（cd/m²）、縦軸は電流効率（cd/A）を表す。また、発光素子5、比較発光素子6、及び比較発光素子7の電圧-電流特性を図22に示す。図22において、横軸は電圧（V）を、縦軸は電流（mA）を表す。また、発光素子5、比較発光素子6、及び比較発光素子7の発光スペクトルを図23に示す。図23において、横軸は波長（nm）、縦軸は発光強度（任意単位）を表す。なお、図23において、各発光素子のデータが概略重なって示されている。

【0261】

また、各発光素子における輝度1000cd/m²付近のときの電圧（V）、電流密度（mA/cm²）、CIE色度座標（x、y）、電流効率（cd/A）、外部量子効率（%）を表4に示す。

【0262】

【表4】

	電圧(V)	電流密度 (mA/cm ²)	CIE色度座標		輝度 (cd/m ²)	電流効率 (cd/A)	外部 量子効率(%)
			x	y			
発光素子5	2.7	2.0	0.62	0.38	1025	50	26
比較発光素子6	2.9	1.7	0.62	0.38	875	53	28
比較発光素子7	2.5	1.7	0.62	0.38	739	44	24

【0263】

10

20

30

40

50

表4に示す通り、輝度 1025 cd/m^2 の発光素子5のCIE色度座標は、 $(x, y) = (0.62, 0.38)$ であった。また、輝度 875 cd/m^2 の比較発光素子6のCIE色度座標は、 $(x, y) = (0.62, 0.38)$ であった。また、輝度 739 cd/m^2 の比較発光素子7のCIE色度座標は、 $(x, y) = (0.62, 0.38)$ であった。

【0264】

また、輝度 1025 cd/m^2 の発光素子5の電圧は 2.7 V であり、電流効率は 50 cd/A であった。また、輝度 875 cd/m^2 の比較発光素子6の電圧は 2.9 V であり、電流効率は 53 cd/A であった。また、輝度 739 cd/m^2 の比較発光素子7の電圧は 2.5 V であり、電流効率は 44 cd/A であった。

10

【0265】

したがって、本発明の一態様である発光素子5は、比較発光素子6と比べると、電圧を 0.2 V 低くすることができ、且つ電流効率を同等にできることが確認された。また、本発明の一態様である発光素子5は、比較発光素子7と比べると、電圧を同等とし、且つ電流効率を 6 cd/A 高くできることが確認された。

【0266】

この結果は、以下のように説明できる。まず、本実施例で用いたDPA2SF(略称)、及びBPAFLP(略称)の各薄膜でのHOMO準位は、それぞれ、 -5.09 eV 、 -5.63 eV である。

【0267】

比較発光素子6および7は、発光層の構成は発光素子5と同じであるため、駆動開始電圧はほぼ同じである。しかしながら比較発光素子6は、正孔輸送層が発光層の第2の有機化合物(DPA2SF)よりもHOMO準位がかなり低いBPAFLPのみからなっているため、正孔輸送層から発光層への正孔の移動が潤滑に進まず、高輝度(実用輝度)領域での電圧-電流特性が悪くなっていることがわかる。その結果、 1000 cd/m^2 付近での駆動電圧は高電圧シフトしている。

20

【0268】

一方、比較発光素子7に関しては、正孔輸送層に発光層の第2の有機化合物(DPA2SF)と同じ物質を用いているため、電圧-電流特性は発光素子5と概ね同じである。しかしながら、正孔輸送層がDPA2SFのみからなっているため、発光層の三重項励起エネルギーが正孔輸送層にまで拡散してしまい、外部量子効率(発光効率)および電流効率が低下していることがわかる。その結果、電力効率としては、発光素子5が最も高い。

30

【0269】

このように、本発明の一態様である発光素子5は、比較発光素子6及び比較発光素子7と比べて、低い電圧を維持し、且つ高い電流効率であった。

【0270】

以上のように、本発明の一態様である発光素子は、発光層(第1の発光層1113a及び第2の発光層1113b)に用いる正孔輸送性を有する第2の有機化合物が、正孔輸送層1112にも含まれた素子構成である。このような構成とすることで、発光素子の電圧(駆動開始電圧および実用輝度領域での駆動電圧の双方)を正孔輸送層が有する第2の有機化合物により低くすることができる。また、本発明の一態様である発光素子は、第2の有機化合物だけで形成した正孔輸送層と比較し、第2の有機化合物以外の材料も有するため、発光層からの三重項励起エネルギーの拡散を第2の有機化合物以外の材料により抑制し、発光効率の高い優れた発光素子とすることができます。

40

【0271】

なお、本実施例(発光素子5)の発光層に用いた第1の有機化合物(2mD BTPDBq-II)の薄膜のPLピーク波長は 426 nm 、第2の有機化合物(DPA2SF)のPLピーク波長は 433 nm であるが、これらの混合膜のPLピーク波長は 579 nm であり、長波長シフトしていることがわかった。したがって、これら2種類の有機化合物は、励起錯体を形成する組み合わせである。

50

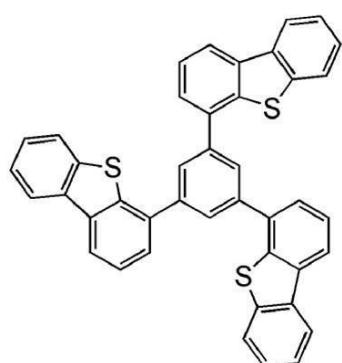
【実施例 3】

【0272】

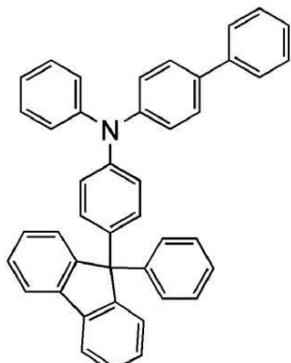
本実施例では、本発明の一態様の発光素子（発光素子8）、並びに比較用の発光素子（比較発光素子9及び比較発光素子10）について、図13を用いて説明する。また、本実施例で用いる材料の化学式を以下に示す。

【0273】

【化5】

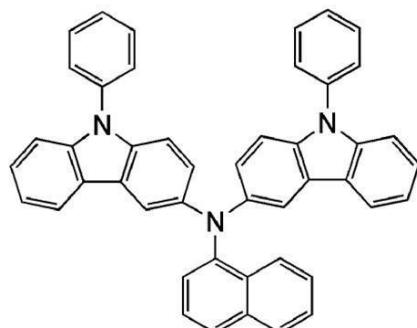


DBT3P-II

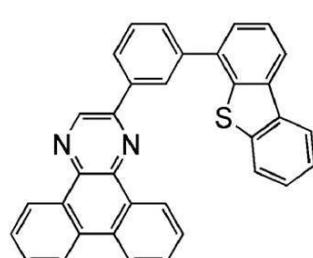


BPAFLP

10



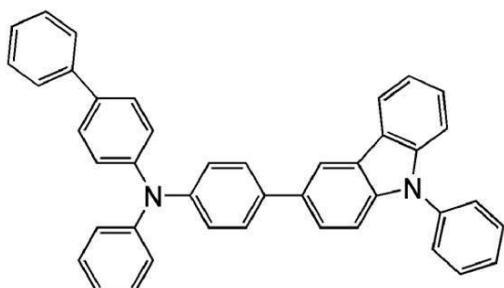
PCzPCN1



2mDBTPDBq-II

20

30

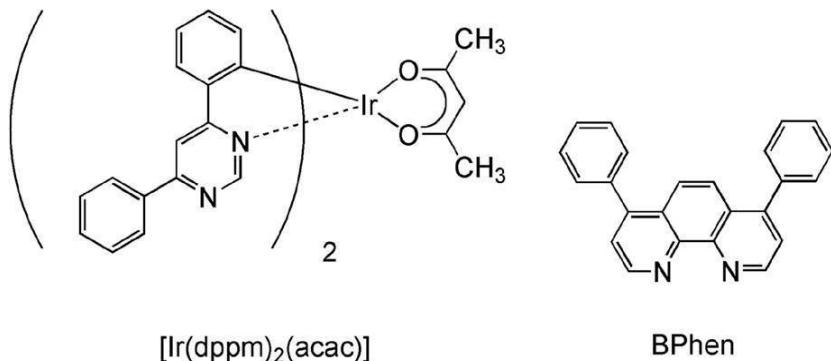


PCBA1BP

40

【0274】

【化6】



10

【0275】

以下に、本実施例の発光素子8、比較発光素子9、及び比較発光素子10の作製方法を示す。

【0276】

(発光素子8)

まず、基板1100上に、珪素若しくは酸化珪素を含有した酸化インジウム-酸化スズ化合物(ITSO)をスパッタリング法にて成膜し、第1の電極1101を形成した。なお、用いたターゲットの組成は、In₂O₃ : SnO₂ : SiO₂ = 85 : 10 : 5 [重量%]とした。また、第1の電極1101の膜厚は、110nmとし、電極面積は2mm²とした。ここで、第1の電極1101は、発光素子の陽極として機能する電極である。

20

【0277】

次に、基板1100上に発光素子を形成するための前処理として、基板表面を水で洗浄し、200℃で1時間焼成した後、UVオゾン処理を370秒行った。

【0278】

その後、10⁻⁴Pa程度まで内部が減圧された真空蒸着装置に基板を導入し、真空蒸着装置内の加熱室において、170℃で30分間の真空焼成を行った後、基板1100を30分程度放冷した。

30

【0279】

次に、第1の電極1101が形成された面が下方となるように、第1の電極1101が形成された基板1100を真空蒸着装置内に設けられた基板ホルダーに固定し、10⁻⁴Pa程度まで減圧した後、第1の電極1101上に、抵抗加熱を用いた蒸着法により、DBT3P-II(略称)と酸化モリブデンを共蒸着することで、正孔注入層1111を形成した。その膜厚は、40nmとし、DBT3P-II(略称)と酸化モリブデンの比率は、重量比で4:2(=DBT3P-II:酸化モリブデン)となるように調節した。

【0280】

次に、正孔注入層1111上に、BPAFLP(略称)とPCzPCN1(略称)を共蒸着することで、正孔輸送層1112を形成した。その膜厚は、20nmとし、BPAFLP(略称)とPCzPCN1(略称)の比率は、重量比で0.5:0.5(=BPAFLP:PCzPCN1)となるように調節した。

40

【0281】

次に、正孔輸送層1112上に、2mDBTPDBq-II(略称)と、PCzPCN1(略称)と、(アセチルアセトナト)ビス(4,6-ジフェニルピリミジナト)イリジウム(III)(略称:[Ir(dppm)₂(acac)])と、を共蒸着し、第1の発光層1113aを形成した。ここで、2mDBTPDBq-II(略称)、PCzPCN1(略称)、及び[Ir(dppm)₂(acac)](略称)の重量比は、0.7:0.3:0.06(=2mDBTPDBq-II:PCzPCN1:[Ir(dppm)₂(acac)])となるように調節した。また、第1の発光層1113aの膜厚は20

50

n mとした。

【0282】

なお、第1の発光層1113aにおいて、2mDBTPDBq-II(略称)は、第1の有機化合物(ホスト材料)であり、PCzPCN1(略称)は、第2の有機化合物(アシスト材料)であり、[Ir(dppm)₂(acac)](略称)は、第3の有機化合物(ゲスト材料)である。

【0283】

次に、第1の発光層1113a上に、2mDBTPDBq-II(略称)と、PCzPCN1(略称)と、[Ir(dppm)₂(acac)](略称)と、を共蒸着し、第2の発光層1113bを形成した。ここで、2mDBTPDBq-II(略称)、PCzPCN1(略称)、及び[Ir(dppm)₂(acac)](略称)の重量比は、0.8:0.2:0.05(=2mDBTPDBq-II:PCzPCN1:[Ir(dppm)₂(acac)])となるように調節した。また、第2の発光層1113bの膜厚は20nmとした。

【0284】

なお、第2の発光層1113bにおいて、2mDBTPDBq-II(略称)は、第1の有機化合物(ホスト材料)であり、PCzPCN1(略称)は、第2の有機化合物(アシスト材料)であり、[Ir(dppm)₂(acac)](略称)は、第3の有機化合物(ゲスト材料)である。

【0285】

次に、第2の発光層1113b上に2mDBTPDBq-II(略称)を膜厚10nmとなるように成膜し、第1の電子輸送層1114aを形成した。

【0286】

次に、第1の電子輸送層1114a上にBPhen(略称)を膜厚20nmとなるように成膜し、第2の電子輸送層1114bを形成した。

【0287】

次に、第2の電子輸送層1114b上に、フッ化リチウム(LiF)を1nmの膜厚で蒸着し、電子注入層1115を形成した。

【0288】

最後に、陰極として機能する第2の電極1103として、アルミニウム(Al)を200nmの膜厚となるように蒸着することで、本実施例の発光素子8を作製した。

【0289】

なお、上述した蒸着過程において、蒸着は全て抵抗加熱法を用いた。

【0290】

(比較発光素子9)

比較発光素子9は、発光素子8と正孔輸送層1112、第1の発光層1113a、及び第2の発光層1113bの構成が異なり、それ以外の構成は同じである。異なる構成のみ以下記載する。

【0291】

正孔注入層1111上に、BPAFLP(略称)を蒸着することで、正孔輸送層1112を形成した。その膜厚は、20nmとした。

【0292】

正孔輸送層1112上に、2mDBTPDBq-II(略称)と、PCBA1BP(略称)と、[Ir(dppm)₂(acac)](略称)と、を共蒸着し、第1の発光層1113aを形成した。ここで、2mDBTPDBq-II(略称)、PCBA1BP(略称)、及び[Ir(dppm)₂(acac)](略称)の重量比は、0.7:0.3:0.06(=2mDBTPDBq-II:PCBA1BP:[Ir(dppm)₂(acac)])となるように調節した。また、第1の発光層1113aの膜厚は20nmとした。

【0293】

10

20

30

40

50

なお、第1の発光層1113aにおいて、2mDBTPDBq-II (略称)は、第1の有機化合物(ホスト材料)であり、PCBA1BP (略称)は、第2の有機化合物(アシスト材料)であり、[Ir(dppm)₂(acac)] (略称)は、第3の有機化合物(ゲスト材料)である。

【0294】

第1の発光層1113a上に、2mDBTPDBq-II (略称)と、PCBA1BP (略称)と、[Ir(dppm)₂(acac)] (略称)と、を共蒸着し、第2の発光層1113bを形成した。ここで、2mDBTPDBq-II (略称)、PCBA1BP (略称)、及び[Ir(dppm)₂(acac)] (略称)の重量比は、0.8:0.2:0.05 (=2mDBTPDBq-II:PCBA1BP:[Ir(dppm)₂(acac)])となるように調節した。また、第2の発光層1113bの膜厚は20nmとした。 10

【0295】

なお、第2の発光層1113bにおいて、2mDBTPDBq-II (略称)は、第1の有機化合物(ホスト材料)であり、PCBA1BP (略称)は、第2の有機化合物(アシスト材料)であり、[Ir(dppm)₂(acac)] (略称)は、第3の有機化合物(ゲスト材料)である。

【0296】

(比較発光素子10)

比較発光素子10は、発光素子8と正孔輸送層1112の構成が異なり、それ以外の構成は同じである。異なる構成のみ以下記載する。 20

【0297】

正孔注入層1111上に、BPAFLP (略称)を蒸着することで、正孔輸送層1112を形成した。その膜厚は、20nmとした。

【0298】

以上により得られた発光素子8、比較発光素子9、及び比較発光素子10の素子構造を表5に示す。

【0299】

【表5】

	第1の電極	正孔注入層	正孔輸送層	第1の発光層	第2の発光層	第1の電子輸送層	第2の電子輸送層	電子注入層	第2の電極
発光素子8	ITSO 110nm	DBT3P-II:MoO _x (=4:2) 40nm	BPAFLP: PCzPCN1 (0.5:0.5) 20nm	下記記載	下記記載	2mDBTPDBq-II 10nm	BPhen 20nm	LiF 1nm	Al 200nm
比較 発光素子9	ITSO 110nm	DBT3P-II:MoO _x (=4:2) 40nm	BPAFLP 20nm	下記記載	下記記載	2mDBTPDBq-II 10nm	BPhen 20nm	LiF 1nm	Al 200nm
比較 発光素子10	ITSO 110nm	DBT3P-II:MoO _x (=4:2) 40nm	BPAFLP 20nm	下記記載	下記記載	2mDBTPDBq-II 10nm	BPhen 20nm	LiF 1nm	Al 200nm

	第1の発光層	第2の発光層
発光素子8	2mDBTPDBq-II:PCzPCN1:Ir(dppm) ₂ (acac) (=0.7:0.3:0.06) 20nm	2mDBTPDBq-II:PCzPCN1:Ir(dppm) ₂ (acac) (=0.8:0.2:0.05) 20nm
比較 発光素子9	2mDBTPDBq-II:PCBA1BP:Ir(dppm) ₂ (acac) (=0.7:0.3:0.06) 20nm	2mDBTPDBq-II:PCBA1BP:Ir(dppm) ₂ (acac) (=0.8:0.2:0.05) 20nm
比較 発光素子10	2mDBTPDBq-II:PCzPCN1:Ir(dppm) ₂ (acac) (=0.7:0.3:0.06) 20nm	2mDBTPDBq-II:PCzPCN1:Ir(dppm) ₂ (acac) (=0.8:0.2:0.05) 20nm

【0300】

発光素子8、比較発光素子9、及び比較発光素子10を、窒素雰囲気のグループボックス内において、各発光素子が大気に曝されないようにガラス基板により封止する作業(シール材を素子の周囲に塗布し、封止時に80にて1時間熱処理)を行った。その後、これらの発光素子の動作特性について測定を行った。なお、測定は室温(25)に保たれた 50

雰囲気)で行った。

【0301】

発光素子8、比較発光素子9、及び比較発光素子10の電流密度-輝度特性を図24に示す。図24において、横軸は電流密度(mA/cm^2)を、縦軸は輝度(cd/m^2)を表す。また、発光素子8、比較発光素子9、及び比較発光素子10の電圧-輝度特性を図25に示す。図25において、横軸は電圧(V)を、縦軸は輝度(cd/m^2)を表す。また、発光素子8、比較発光素子9、及び比較発光素子10の輝度-電流効率特性を図26に示す。図26において、横軸は輝度(cd/m^2)、縦軸は電流効率(cd/A)を表す。また、発光素子8、比較発光素子9、及び比較発光素子10の電圧-電流特性を図27に示す。図27において、横軸は電圧(V)を、縦軸は電流(mA)を表す。また、発光素子8、比較発光素子9、及び比較発光素子10の発光スペクトルを図28に示す。図28において、横軸は波長(nm)、縦軸は発光強度(任意単位)を表す。なお、図28において、各発光素子のデータが概略重なって示されている。
10

【0302】

また、各発光素子における輝度 $1000\text{cd}/\text{m}^2$ 付近のときの電圧(V)、電流密度(mA/cm^2)、CIE色度座標(x、y)、電流効率(cd/A)、外部量子効率(%)を表6に示す。

【0303】

【表6】

	電圧(V)	電流密度 (mA/cm^2)	CIE色度座標		輝度 (cd/m^2)	電流効率 (cd/A)	外部 量子効率(%)
			x	y			
発光素子8	2.5	1.0	0.57	0.43	791	76	30
比較発光素子9	2.9	1.4	0.56	0.44	1029	74	29
比較発光素子10	2.9	1.7	0.57	0.43	1211	73	29

20

【0304】

表6に示す通り、輝度 $791\text{cd}/\text{m}^2$ の発光素子8のCIE色度座標は、(x, y) = (0.57, 0.43)であった。また、輝度 $1029\text{cd}/\text{m}^2$ の比較発光素子9のCIE色度座標は、(x, y) = (0.56, 0.44)であった。また、輝度 $1211\text{cd}/\text{m}^2$ の比較発光素子10のCIE色度座標は、(x, y) = (0.57, 0.43)であった。
30

【0305】

また、輝度 $791\text{cd}/\text{m}^2$ の発光素子8の電圧は2.5Vであり、電流効率は76cd/Aであった。また、輝度 $1029\text{cd}/\text{m}^2$ の比較発光素子9の電圧は2.9Vであり、電流効率は74cd/Aであった。また、輝度 $1211\text{cd}/\text{m}^2$ の比較発光素子10の電圧は2.9Vであり、電流効率は73cd/Aであった。

【0306】

したがって、本発明の一態様である発光素子8は、比較発光素子9及び比較発光素子10と比べると、電圧を0.4V低くすることができ、且つ電流効率を同等にできることが確認された。
40

【0307】

この結果は、以下のように説明できる。まず、本実施例で用いたPCzPCN1(略称)、PCBA1BP(略称)、及びBPAFLP(略称)の各薄膜でのHOMO準位は、それぞれ、-5.15eV、-5.42eV、-5.63eVである。

【0308】

比較発光素子9の発光層に用いている第2の有機化合物(PCBA1BP)のHOMO準位は、発光素子8に用いている第2の有機化合物(PCzPCN1)のそれに比して低いため、それに伴って第1の有機化合物(2mDBTPDBq-II)との間で形成され
50

る励起錯体の波長も短波長シフトする。その結果、比較発光素子9の駆動開始電圧は高電圧側にシフトしている。一方、比較発光素子10は、発光層の構成は発光素子8と同じであるため、駆動開始電圧はほぼ同じである。

【0309】

しかしながら比較発光素子10は、正孔輸送層が発光層の第2の有機化合物（P C z P C N 1）よりもHOMO準位がかなり低いB P A F L Pのみからなっているため、正孔輸送層から発光層への正孔の移動が潤滑に進まず、高輝度（実用輝度）領域での電圧・電流特性が悪くなっていることがわかる。その結果、1000 cd / m²付近での駆動電圧は、結局比較発光素子9と同様に高電圧シフトしてしまっている。

【0310】

このように、本発明の一態様である発光素子8は、比較発光素子9及び比較発光素子10と比べて、低い電圧を維持し、且つ高い電流効率であった。

【0311】

以上のように、本発明の一態様である発光素子は、発光層（第1の発光層1113a及び第2の発光層1113b）に用いる正孔輸送性を有する第2の有機化合物が、正孔輸送層1112にも含まれた素子構成である。このような構成とすることで、発光素子の電圧（駆動開始電圧および実用輝度領域での駆動電圧の双方）を正孔輸送層が有する第2の有機化合物により低くすることができます。また、本発明の一態様である発光素子は、第2の有機化合物だけで形成した正孔輸送層と比較し、第2の有機化合物以外の材料も有するため、発光層からの三重項励起エネルギーの拡散を第2の有機化合物以外の材料により抑制し、発光効率の高い優れた発光素子とすることができます。

【0312】

なお、本実施例（発光素子8）の発光層に用いた第1の有機化合物（2mDBTPDBq-I）の薄膜のPLピーク波長は426 nm、第2の有機化合物（P C z P C N 1）のPLピーク波長は479 nmであるが、これらの混合膜のPLピーク波長は571 nmであり、長波長シフトしていることがわかった。したがって、これら2種類の有機化合物は、励起錯体を形成する組み合わせである。

【実施例4】

【0313】

本実施例では、本発明の一態様の発光素子（発光素子11）、及び比較用の発光素子（比較発光素子12）について、図13を用いて説明する。また、本実施例で用いる材料の化学式を以下に示す。

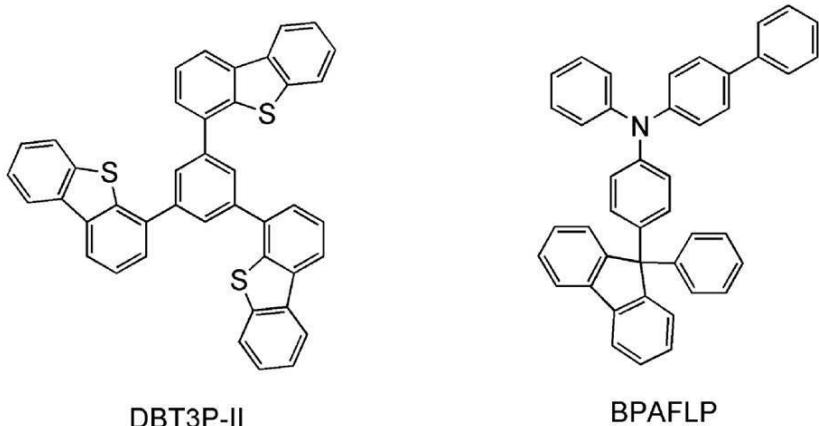
【0314】

10

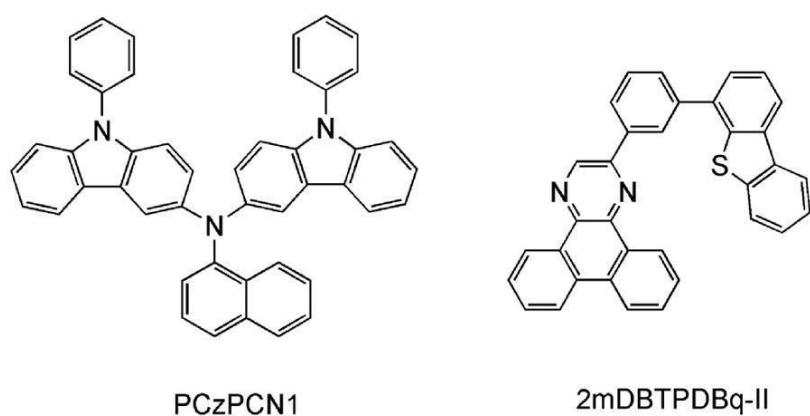
20

30

【化7】



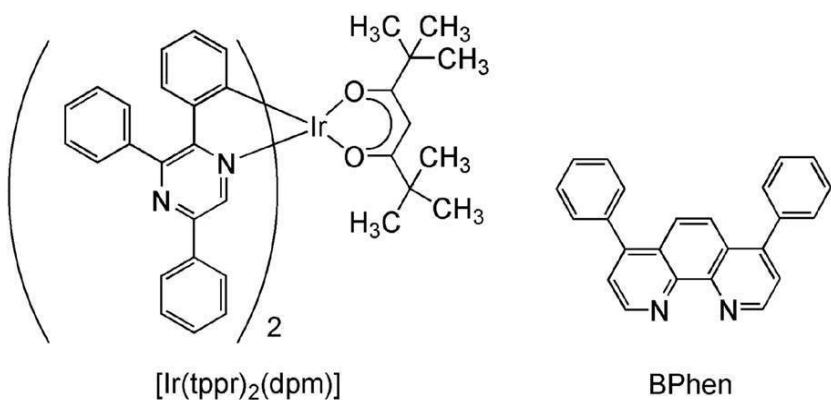
10



20

【0315】

【化8】



30

【0316】

以下に、本実施例の発光素子11、及び比較発光素子12の作製方法を示す。

【0317】

(発光素子11)

まず、基板1100上に、珪素若しくは酸化珪素を含有した酸化インジウム-酸化スズ化合物(ITSO)をスパッタリング法にて成膜し、第1の電極1101を形成した。なお、用いたターゲットの組成は、In₂O₃ : SnO₂ : SiO₂ = 85 : 10 : 5 [重量%]とした。また、第1の電極1101の膜厚は、110 nmとし、電極面積は2 mm × 2 mmとした。ここで、第1の電極1101は、発光素子の陽極として機能する電極である。

40

50

【0318】

次に、基板1100上に発光素子を形成するための前処理として、基板表面を水で洗浄し、200で1時間焼成した後、UVオゾン処理を370秒行った。

【0319】

その後、 10^{-4} Pa程度まで内部が減圧された真空蒸着装置に基板を導入し、真空蒸着装置内の加熱室において、170で30分間の真空焼成を行った後、基板1100を30分程度放冷した。

【0320】

次に、第1の電極1101が形成された面が下方となるように、第1の電極1101が形成された基板1100を真空蒸着装置内に設けられた基板ホルダーに固定し、 10^{-4} Pa程度まで減圧した後、第1の電極1101上に、抵抗加熱を用いた蒸着法により、DBT3P-II(略称)と酸化モリブデンを共蒸着することで、正孔注入層1111を形成した。その膜厚は、40nmとし、DBT3P-II(略称)と酸化モリブデンの比率は、重量比で4:2(=DBT3P-II:酸化モリブデン)となるように調節した。

【0321】

次に、正孔注入層1111上に、BPAFLP(略称)とPCzPCN1(略称)を共蒸着することで、正孔輸送層1112を形成した。その膜厚は、20nmとし、BPAFLP(略称)とPCzPCN1(略称)の比率は、重量比で0.5:0.5(=BPAFLP:PCzPCN1)となるように調節した。

【0322】

次に、正孔輸送層1112上に、2mDBTPDBq-II(略称)と、PCzPCN1(略称)と、(ジピバロイルメタナト)ビス(2,3,5-トリフェニルピラジナト)イリジウム(III)(略称[Ir(tppr)₂(dpm)])と、を共蒸着し、第1の発光層1113aを形成した。ここで、2mDBTPDBq-II(略称)、PCzPCN1(略称)、及び[Ir(tppr)₂(dpm)](略称)の重量比は、0.7:0.3:0.06(=2mDBTPDBq-II:PCzPCN1:[Ir(tppr)₂(dpm)])となるように調節した。また、第1の発光層1113aの膜厚は20nmとした。

【0323】

なお、第1の発光層1113aにおいて、2mDBTPDBq-II(略称)は、第1の有機化合物(ホスト材料)であり、PCzPCN1(略称)は、第2の有機化合物(アシスト材料)であり、[Ir(tppr)₂(dpm)](略称)は、第3の有機化合物(ゲスト材料)である。

【0324】

次に、第1の発光層1113a上に、2mDBTPDBq-II(略称)と、PCzPCN1(略称)と、[Ir(tppr)₂(dpm)](略称)と、を共蒸着し、第2の発光層1113bを形成した。ここで、2mDBTPDBq-II(略称)、PCzPCN1(略称)、及び[Ir(tppr)₂(dpm)](略称)の重量比は、0.8:0.2:0.05(=2mDBTPDBq-II:PCzPCN1:[Ir(tppr)₂(dpm)])となるように調節した。また、第2の発光層1113bの膜厚は20nmとした。

【0325】

なお、第2の発光層1113bにおいて、2mDBTPDBq-II(略称)は、第1の有機化合物(ホスト材料)であり、PCzPCN1(略称)は、第2の有機化合物(アシスト材料)であり、[Ir(tppr)₂(dpm)](略称)は、第3の有機化合物(ゲスト材料)である。

【0326】

次に、第2の発光層1113b上に2mDBTPDBq-II(略称)を膜厚10nmとなるように成膜し、第1の電子輸送層1114aを形成した。

【0327】

10

20

30

40

50

次に、第1の電子輸送層1114a上にBPhen(略称)を膜厚20nmとなるよう成膜し、第2の電子輸送層1114bを形成した。

【0328】

次に、第2の電子輸送層1114b上に、フッ化リチウム(LiF)を1nmの膜厚で蒸着し、電子注入層1115を形成した。

【0329】

最後に、陰極として機能する第2の電極1103として、アルミニウム(Al)を200nmの膜厚となるよう蒸着することで、本実施例の発光素子11を作製した。

【0330】

なお、上述した蒸着過程において、蒸着は全て抵抗加熱法を用いた。

10

【0331】

(比較発光素子12)

比較発光素子12は、発光素子11と正孔輸送層1112の構成が異なり、それ以外の構成は同じである。異なる構成のみ以下記載する。

【0332】

正孔注入層1111上に、BPAFLP(略称)を蒸着することで、正孔輸送層1112を形成した。その膜厚は、20nmとした。

【0333】

以上により得られた発光素子11、及び比較発光素子12の素子構造を表7に示す。

【0334】

【表7】

	第1の電極	正孔注入層	正孔輸送層	第1の発光層	第2の発光層	第1の電子輸送層	第2の電子輸送層	電子注入層	第2の電極
発光素子11	ITSO 110nm	DBT3P-II:MoO _x (=4.2) 40nm	BPAFLP: PCzPCN1 (0.5:0.5) 20nm	下記記載	下記記載	2mDBTPDBq-II 10nm	BPhen 20nm	LiF 1nm	Al 200nm
比較発光素子12	ITSO 110nm	DBT3P-II:MoO _x (=4.2) 40nm	BPAFLP 20nm	下記記載	下記記載	2mDBTPDBq-II 10nm	BPhen 20nm	LiF 1nm	Al 200nm

	第1の発光層	第2の発光層
発光素子11	2mDBTPDBq-II:PCzPCN1:Ir(tppr) ₂ (dpm) (=0.7:0.3:0.06) 20nm	2mDBTPDBq-II:PCzPCN1:Ir(tppr) ₂ (dpm) (=0.8:0.2:0.05) 20nm
比較発光素子12	2mDBTPDBq-II:PCzPCN1:Ir(tppr) ₂ (dpm) (=0.7:0.3:0.06) 20nm	2mDBTPDBq-II:PCzPCN1:Ir(tppr) ₂ (dpm) (=0.8:0.2:0.05) 20nm

【0335】

発光素子11、及び比較発光素子12を、窒素雰囲気のグローブボックス内において、各発光素子が大気に曝されないようにガラス基板により封止する作業(シール材を素子の周囲に塗布し、封止時に80にて1時間熱処理)を行った。その後、これらの発光素子の動作特性について測定を行った。なお、測定は室温(25に保たれた雰囲気)で行った。

【0336】

発光素子11、及び比較発光素子12の電流密度-輝度特性を図29に示す。図29において、横軸は電流密度(mA/cm²)を、縦軸は輝度(cd/m²)を表す。また、発光素子11、及び比較発光素子12の電圧-輝度特性を図30に示す。図30において、横軸は電圧(V)を、縦軸は輝度(cd/m²)を表す。また、発光素子11、及び比較発光素子12の輝度-電流効率特性を図31に示す。図31において、横軸は輝度(cd/m²)、縦軸は電流効率(cd/A)を表す。また、発光素子11、及び比較発光素子12の電圧-電流特性を図32に示す。図32において、横軸は電圧(V)を、縦軸は電流(mA)を表す。また、発光素子11、及び比較発光素子12の発光スペクトルを図33に示す。図33において、横軸は波長(nm)、縦軸は発光強度(任意単位)を表す。なお、図33において、各発光素子のデータが概略重なって示されている。

40

30

50

【0337】

また、各発光素子における輝度 1000 cd/m^2 付近のときの電圧 (V)、電流密度 (mA/cm²)、CIE色度座標 (x, y)、電流効率 (cd/A)、外部量子効率 (%) を表8に示す。

【0338】

【表8】

	電圧(V)	電流密度 (mA/cm ²)	CIE色度座標		輝度 (cd/m ²)	電流効率 (cd/A)	外部 量子効率(%)
			x	y			
発光素子11	2.9	3.9	0.66	0.34	1002	25	22
比較発光素子12	3.3	3.7	0.66	0.34	947	25	22

10

【0339】

表8に示す通り、輝度 1002 cd/m^2 の発光素子11のCIE色度座標は、(x, y) = (0.66, 0.34) であった。また、輝度 947 cd/m^2 の比較発光素子12のCIE色度座標は、(x, y) = (0.66, 0.34) であった。

【0340】

また、輝度 1002 cd/m^2 の発光素子11の電圧は 2.9 V であり、電流効率は 25 cd/A であった。また、輝度 947 cd/m^2 の比較発光素子12の電圧は 3.3 V であり、電流効率は 25 cd/A であった。

20

【0341】

したがって、本発明の一態様である発光素子11は、比較発光素子12と比べると、電圧を 0.4 V 低くすることができ、且つ電流効率を同等にできることができた。

【0342】

この結果は、以下のように説明できる。まず、本実施例で用いたP CZ PCN1(略称)、及びBPAFLP(略称)の各薄膜でのHOMO準位は、それぞれ、-5.15 eV、-5.63 eVである。

【0343】

比較発光素子12は、発光層の構成は発光素子11と同じであるため、駆動開始電圧はほぼ同じである。しかしながら比較発光素子12は、正孔輸送層が発光層の第2の有機化合物(P CZ PCN1)よりもHOMO準位がかなり低いBPAFLPのみからなっているため、正孔輸送層から発光層への正孔の移動が潤滑に進まず、高輝度(実用輝度)領域での電圧-電流特性が悪くなっていることがわかる。その結果、 1000 cd/m^2 付近での駆動電圧は高電圧シフトしている。

30

【0344】

このように、本発明の一態様である発光素子11は、比較発光素子12と比べて、低い電圧を維持し、且つ高い電流効率であった。

【0345】

以上のように、本発明の一態様である発光素子は、発光層(第1の発光層1113a及び第2の発光層1113b)に用いる正孔輸送性を有する第2の有機化合物が、正孔輸送層1112にも含まれた素子構成である。このような構成とすることで、発光素子の電圧(駆動開始電圧および実用輝度領域での駆動電圧の双方)を正孔輸送層が有する第2の有機化合物により低くすることができる。また、本発明の一態様である発光素子は、第2の有機化合物だけで形成した正孔輸送層と比較し、第2の有機化合物以外の材料も有するため、発光層からの三重項励起エネルギーの拡散を第2の有機化合物以外の材料により抑制し、発光効率の高い優れた発光素子とすることができます。

40

【0346】

なお、本実施例(発光素子11)の発光層に用いた第1の有機化合物(2mDBTPD Bq-II)の薄膜のPLピーク波長は 426 nm、第2の有機化合物(P CZ PCN1)のPLピーク波長は 479 nm であるが、これらの混合膜のPLピーク波長は 571 n

50

mであり、長波長シフトしていることがわかった。したがって、これら2種類の有機化合物は、励起錯体を形成する組み合わせである。

【0347】

次に、発光素子11、及び比較発光素子12について、信頼性試験の評価を行った。信頼性試験の結果を図34に示す。

【0348】

図34において、信頼性試験の測定方法は、初期輝度を5000cd/m²に設定し、電流密度一定の条件で各発光素子を駆動した。横軸は素子の駆動時間(h)を、縦軸は初期輝度を100%とした時の規格化輝度(%)を表す。図34から、駆動時間219時間経過後の発光素子11の規格化輝度は82%であり、比較発光素子12の規格化輝度は82%であった。
10

【0349】

このように図34より、本発明の一態様である発光素子11は、長寿命な発光素子であることがわかった。

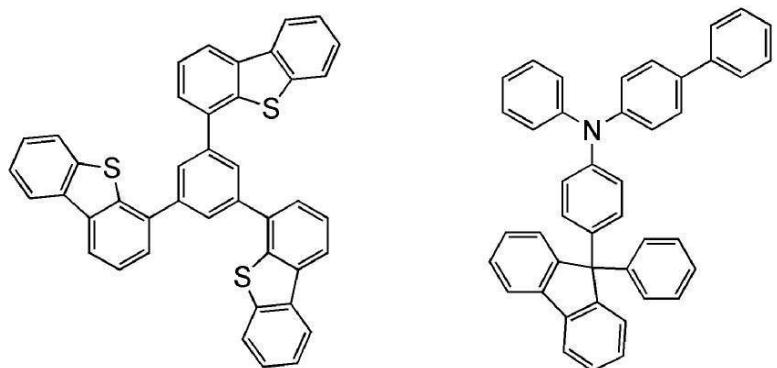
【実施例5】

【0350】

本実施例では、本発明の一態様の発光素子(発光素子13)、及び比較用の発光素子(比較発光素子14及び比較発光素子15)について、図13を用いて説明する。また、本実施例で用いる材料の化学式を以下に示す。

【0351】

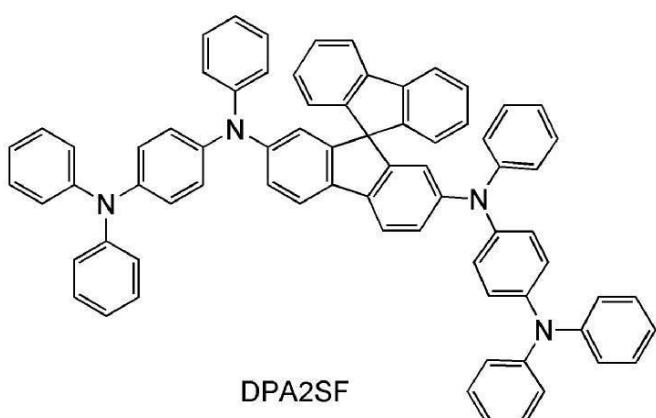
【化 9】



DBT3P-II

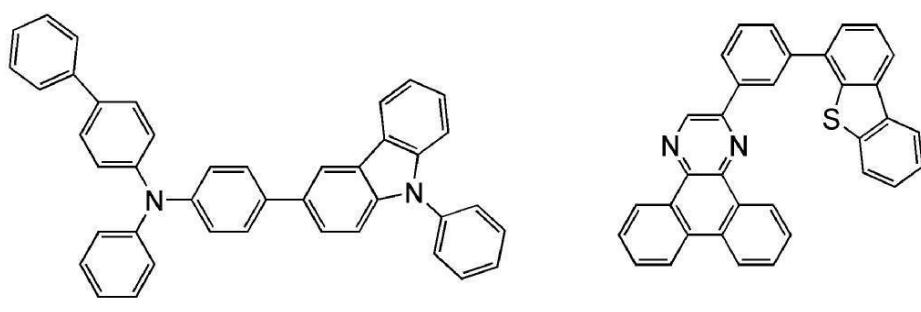
BPAFLP

10



DPA2SF

20



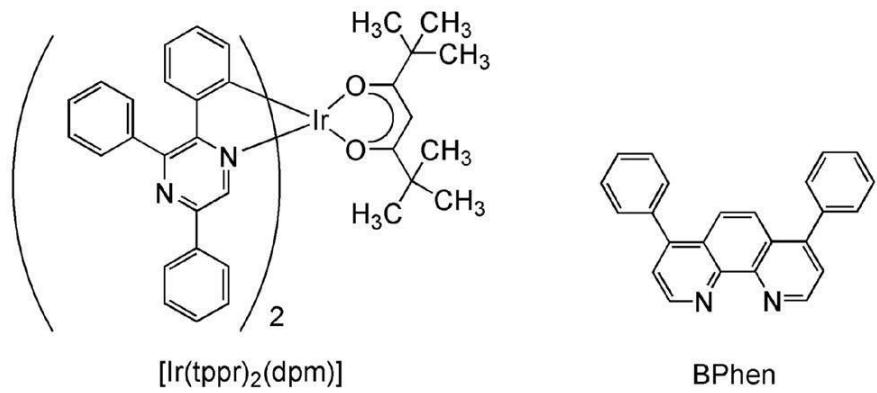
PCBA1BP

2mDBTPDBq-II

30

【 0 3 5 2 】

【化 1 0 】



[Ir(tppr)₂(dpm)]

BPhen

40

【 0 3 5 3 】

50

以下に、本実施例の発光素子 13、比較発光素子 14、及び比較発光素子 15 の作製方法を示す。

【0354】

(発光素子 13)

まず、基板 1100 上に、珪素若しくは酸化珪素を含有した酸化インジウム - 酸化スズ化合物 (ITO) をスパッタリング法にて成膜し、第 1 の電極 1101 を形成した。なお、用いたターゲットの組成は、 $In_2O_3 : SnO_2 : SiO_2 = 85 : 10 : 5$ [重量 %] とした。また、第 1 の電極 1101 の膜厚は、110 nm とし、電極面積は 2 mm \times 2 mm とした。ここで、第 1 の電極 1101 は、発光素子の陽極として機能する電極である。

10

【0355】

次に、基板 1100 上に発光素子を形成するための前処理として、基板表面を水で洗浄し、200 で 1 時間焼成した後、UV オゾン処理を 370 秒行った。

【0356】

その後、 10^{-4} Pa 程度まで内部が減圧された真空蒸着装置に基板を導入し、真空蒸着装置内の加熱室において、170 で 30 分間の真空焼成を行った後、基板 1100 を 30 分程度放冷した。

【0357】

次に、第 1 の電極 1101 が形成された面が下方となるように、第 1 の電極 1101 が形成された基板 1100 を真空蒸着装置内に設けられた基板ホルダーに固定し、 10^{-4} Pa 程度まで減圧した後、第 1 の電極 1101 上に、抵抗加熱を用いた蒸着法により、DBT3P-II (略称) と酸化モリブデンを共蒸着することで、正孔注入層 1111 を形成した。その膜厚は、40 nm とし、DBT3P-II (略称) と酸化モリブデンの比率は、重量比で 4 : 2 (= DBT3P-II : 酸化モリブデン) となるように調節した。

20

【0358】

次に、正孔注入層 1111 上に、BPAFLP (略称) と DPA2SF (略称) を共蒸着することで、正孔輸送層 1112 を形成した。その膜厚は、20 nm とし、BPAFLP (略称) と DPA2SF (略称) の比率は、重量比で 0.5 : 0.5 (= BPAFLP : DPA2SF) となるように調節した。

【0359】

30

次に、正孔輸送層 1112 上に、2mDBTPDBq-II (略称) と、DPA2SF (略称) と、 $[Ir(tppr)_2(dpm)]$ (略称) と、を共蒸着し、第 1 の発光層 1113a を形成した。ここで、2mDBTPDBq-II (略称)、DPA2SF (略称)、及び $[Ir(tppr)_2(dpm)]$ (略称) の重量比は、0.7 : 0.3 : 0.06 (= 2mDBTPDBq-II : DPA2SF : $[Ir(tppr)_2(dpm)]$) となるように調節した。また、第 1 の発光層 1113a の膜厚は 20 nm とした。

【0360】

なお、第 1 の発光層 1113a において、2mDBTPDBq-II (略称) は、第 1 の有機化合物 (ホスト材料) であり、DPA2SF (略称) は、第 2 の有機化合物 (アシスト材料) であり、 $[Ir(tppr)_2(dpm)]$ (略称) は、第 3 の有機化合物 (ゲスト材料) である。

40

【0361】

次に、第 1 の発光層 1113a 上に、2mDBTPDBq-II (略称) と、DPA2SF (略称) と、 $[Ir(tppr)_2(dpm)]$ (略称) と、を共蒸着し、第 2 の発光層 1113b を形成した。ここで、2mDBTPDBq-II (略称)、DPA2SF (略称)、及び $[Ir(tppr)_2(dpm)]$ (略称) の重量比は、0.8 : 0.2 : 0.05 (= 2mDBTPDBq-II : DPA2SF : $[Ir(tppr)_2(dpm)]$) となるように調節した。また、第 2 の発光層 1113b の膜厚は 20 nm とした。

【0362】

50

なお、第2の発光層1113bにおいて、2mDBTPDBq-II(略称)は、第1の有機化合物(ホスト材料)であり、DPA2SF(略称)は、第2の有機化合物(アシスト材料)であり、[Ir(tppr)₂(dpm)](略称)は、第3の有機化合物(ゲスト材料)である。

【0363】

次に、第2の発光層1113b上に2mDBTPDBq-II(略称)を膜厚10nmとなるように成膜し、第1の電子輸送層1114aを形成した。

【0364】

次に、第1の電子輸送層1114a上にBPhen(略称)を膜厚20nmとなるように成膜し、第2の電子輸送層1114bを形成した。

10

【0365】

次に、第2の電子輸送層1114b上に、フッ化リチウム(LiF)を1nmの膜厚で蒸着し、電子注入層1115を形成した。

【0366】

最後に、陰極として機能する第2の電極1103として、アルミニウム(Al)を200nmの膜厚となるように蒸着することで、本実施例の発光素子13を作製した。

【0367】

なお、上述した蒸着過程において、蒸着は全て抵抗加熱法を用いた。

【0368】

(比較発光素子14)

20

比較発光素子14は、発光素子13と正孔輸送層1112、第1の発光層1113a、及び第2の発光層1113bの構成が異なり、それ以外の構成は同じである。異なる構成のみ以下記載する。

【0369】

正孔注入層1111上に、BPAFLP(略称)を蒸着することで、正孔輸送層1112を形成した。その膜厚は、20nmとした。

【0370】

正孔輸送層1112上に、2mDBTPDBq-II(略称)と、PCBA1BP(略称)と、[Ir(tppr)₂(dpm)](略称)と、を共蒸着し、第1の発光層1113aを形成した。ここで、2mDBTPDBq-II(略称)、PCBA1BP(略称)、及び[Ir(tppr)₂(dpm)](略称)の重量比は、0.7:0.3:0.06(=2mDBTPDBq-II:PCBA1BP:[Ir(tppr)₂(dpm)])となるように調節した。また、第1の発光層1113aの膜厚は20nmとした。

30

【0371】

なお、第1の発光層1113aにおいて、2mDBTPDBq-II(略称)は、第1の有機化合物(ホスト材料)であり、PCBA1BP(略称)は、第2の有機化合物(アシスト材料)であり、[Ir(tppr)₂(dpm)](略称)は、第3の有機化合物(ゲスト材料)である。

【0372】

第1の発光層1113a上に、2mDBTPDBq-II(略称)と、PCBA1BP(略称)と、[Ir(tppr)₂(dpm)](略称)と、を共蒸着し、第2の発光層1113bを形成した。ここで、2mDBTPDBq-II(略称)、PCBA1BP(略称)、及び[Ir(tppr)₂(dpm)](略称)の重量比は、0.8:0.2:0.05(=2mDBTPDBq-II:PCBA1BP:[Ir(tppr)₂(dpm)])となるように調節した。また、第2の発光層1113bの膜厚は20nmとした。

40

【0373】

なお、第2の発光層1113bにおいて、2mDBTPDBq-II(略称)は、第1の有機化合物(ホスト材料)であり、PCBA1BP(略称)は、第2の有機化合物(アシスト材料)であり、[Ir(tppr)₂(dpm)](略称)は、第3の有機化合物

50

(ゲスト材料)である。

【0374】

(比較発光素子15)

比較発光素子15は、発光素子13と正孔輸送層1112の構成が異なり、それ以外の構成は同じである。異なる構成のみ以下記載する。

【0375】

正孔注入層1111上に、BPAFLP(略称)を蒸着することで、正孔輸送層1112を形成した。その膜厚は、20nmとした。

【0376】

以上により得られた発光素子13、比較発光素子14、及び比較発光素子15の素子構造を表9に示す。

【0377】

【表9】

	第1の電極	正孔注入層	正孔輸送層	第1の発光層	第2の発光層	第1の電子輸送層	第2の電子輸送層	電子注入層	第2の電極
--	-------	-------	-------	--------	--------	----------	----------	-------	-------

発光素子13	ITSO 110nm	DBT3P-II:MoO _x (=4:2) 40nm	BPAFLP: DPA2SF (0.5:0.5) 20nm	下記記載	下記記載	2mDBTPDBq-II 10nm	BPhen 20nm	LiF 1nm	Al 200nm
--------	---------------	---	--	------	------	----------------------	---------------	------------	-------------

比較発光素子14	ITSO 110nm	DBT3P-II:MoO _x (=4:2) 40nm	BPAFLP 20nm	下記記載	下記記載	2mDBTPDBq-II 10nm	BPhen 20nm	LiF 1nm	Al 200nm
----------	---------------	---	----------------	------	------	----------------------	---------------	------------	-------------

比較発光素子15	ITSO 110nm	DBT3P-II:MoO _x (=4:2) 40nm	BPAFLP 20nm	下記記載	下記記載	2mDBTPDBq-II 10nm	BPhen 20nm	LiF 1nm	Al 200nm
----------	---------------	---	----------------	------	------	----------------------	---------------	------------	-------------

	第1の発光層	第2の発光層
発光素子13	2mDBTPDBq-II:DPA2SF:Ir(tppr) ₂ (dpm) (=0.7:0.3:0.06) 20nm	2mDBTPDBq-II:DPA2SF:Ir(tppr) ₂ (dpm) (=0.8:0.2:0.05) 20nm
比較発光素子14	2mDBTPDBq-II:PCBA1BP:Ir(tppr) ₂ (dpm) (=0.7:0.3:0.06) 20nm	2mDBTPDBq-II:PCBA1BP:Ir(tppr) ₂ (dpm) (=0.8:0.2:0.05) 20nm
比較発光素子15	2mDBTPDBq-II:DPA2SF:Ir(tppr) ₂ (dpm) (=0.7:0.3:0.06) 20nm	2mDBTPDBq-II:DPA2SF:Ir(tppr) ₂ (dpm) (=0.8:0.2:0.05) 20nm

【0378】

発光素子13、比較発光素子14、及び比較発光素子15を、窒素雰囲気のグローブボックス内において、各発光素子が大気に曝されないようにガラス基板により封止する作業(シール材を素子の周囲に塗布し、封止時に80にて1時間熱処理)を行った。その後、これらの発光素子の動作特性について測定を行った。なお、測定は室温(25に保たれた雰囲気)で行った。

【0379】

発光素子13、比較発光素子14、及び比較発光素子15の電流密度-輝度特性を図35に示す。図35において、横軸は電流密度(mA/cm²)を、縦軸は輝度(cd/m²)を表す。また、発光素子13、比較発光素子14、及び比較発光素子15の電圧-輝度特性を図36に示す。図36において、横軸は電圧(V)を、縦軸は輝度(cd/m²)を表す。また、発光素子13、比較発光素子14、及び比較発光素子15の輝度-電流効率特性を図37に示す。図37において、横軸は輝度(cd/m²)、縦軸は電流効率(cd/A)を表す。また、発光素子13、比較発光素子14、及び比較発光素子15の電圧-電流特性を図38に示す。図38において、横軸は電圧(V)を、縦軸は電流(mA)を表す。また、発光素子13、比較発光素子14、及び比較発光素子15の発光スペクトルを図39に示す。図39において、横軸は波長(nm)、縦軸は発光強度(任意単位)を表す。なお、図39において、各発光素子のデータが概略重なって示されている。

【0380】

また、各発光素子における輝度1000cd/m²付近のときの電圧(V)、電流密度(mA/cm²)、CIE色度座標(x、y)、電流効率(cd/A)、外部量子効率(

10

20

30

40

50

%)を表10に示す。

【0381】

【表10】

	電圧(V)	電流密度 (mA/cm ²)	CIE色度座標		輝度 (cd/m ²)	電流効率 (cd/A)	外部 量子効率(%)
			x	y			
発光素子13	2.9	4.0	0.66	0.34	995	25	22
比較発光素子14	3.3	4.1	0.66	0.34	1019	25	22
比較発光素子15	3.3	4.3	0.66	0.34	1050	25	22

10

【0382】

表10に示す通り、輝度995cd/m²の発光素子13のCIE色度座標は、(x, y)=(0.66, 0.34)であった。また、輝度1019cd/m²の比較発光素子14のCIE色度座標は、(x, y)=(0.66, 0.34)であった。また、輝度1050cd/m²の比較発光素子15のCIE色度座標は、(x, y)=(0.66, 0.34)であった。

【0383】

また、輝度995cd/m²の発光素子13の電圧は2.9Vであり、電流効率は25cd/Aであった。また、輝度1019cd/m²の比較発光素子14の電圧は3.3Vであり、電流効率は25cd/Aであった。また、輝度1050cd/m²の比較発光素子15の電圧は3.3Vであり、電流効率は25cd/Aであった。

20

【0384】

したがって、本発明の一態様である発光素子13は、比較発光素子14及び比較発光素子15と比べると、電圧を0.4V低くすることができ、且つ電流効率を同等にできることが確認された。

【0385】

この結果は、以下のように説明できる。まず、本実施例で用いたDPA2SF(略称)、PCBA1BP(略称)、及びBPAFLP(略称)の各薄膜でのHOMO準位は、それぞれ、-5.09eV、-5.42eV、-5.63eVである。

30

【0386】

比較発光素子14の発光層に用いている第2の有機化合物(PCBA1BP)のHOMO準位は、発光素子13に用いている第2の有機化合物(DPA2SF)のそれに比して低いため、それに伴って第1の有機化合物(2mDBTPDBq-II)との間で形成される励起錯体の波長も短波長シフトする。その結果、比較発光素子14の駆動開始電圧は高電圧側にシフトしている。一方、比較発光素子15は、発光層の構成は発光素子13と同じであるため、駆動開始電圧はほぼ同じである。

【0387】

しかしながら比較発光素子15は、正孔輸送層が発光層の第2の有機化合物(DPA2SF)よりもHOMO準位がかなり低いBPAFLPのみからなっているため、正孔輸送層から発光層への正孔の移動が潤滑に進まず、高輝度(実用輝度)領域での電圧-電流特性が悪くなっていることがわかる。その結果、1000cd/m²付近での駆動電圧は、結局比較発光素子14と同様に高電圧シフトしてしまっている。

40

【0388】

このように、本発明の一態様である発光素子13は、比較発光素子14及び比較発光素子15と比べて、低い電圧を維持し、且つ高い電流効率であった。

【0389】

以上のように、本発明の一態様である発光素子は、発光層(第1の発光層1113a及び第2の発光層1113b)に用いる正孔輸送性を有する第2の有機化合物が、正孔輸送層1112にも含まれた素子構成である。このような構成とすることで、発光素子の電圧

50

(駆動開始電圧および実用輝度領域での駆動電圧の双方)を正孔輸送層が有する第2の有機化合物により低くすることができる。また、本発明の一態様である発光素子は、第2の有機化合物だけで形成した正孔輸送層と比較し、第2の有機化合物以外の材料も有するため、発光層からの三重項励起エネルギーの拡散を第2の有機化合物以外の材料により抑制し、発光効率の高い優れた発光素子とすることができます。

【0390】

なお、本実施例(発光素子13)の発光層に用いた第1の有機化合物(2mDBTPD Bq-II)の薄膜のPLピーク波長は426nm、第2の有機化合物(DPA2SF)のPLピーク波長は433nmであるが、これらの混合膜のPLピーク波長は579nmであり、長波長シフトしていることがわかった。したがって、これら2種類の有機化合物は、励起錯体を形成する組み合わせである。

10

【0391】

次に、発光素子13、比較発光素子14、及び比較発光素子15について、信頼性試験の評価を行った。信頼性試験の結果を図40に示す。

【0392】

図40において、信頼性試験の測定方法は、初期輝度を5000cd/m²に設定し、電流密度一定の条件で各発光素子を駆動した。横軸は素子の駆動時間(h)を、縦軸は初期輝度を100%とした時の規格化輝度(%)を表す。図40から、駆動時間290時間経過後の発光素子13の規格化輝度は85%であり、比較発光素子14の規格化輝度は69%であり、比較発光素子15の規格化輝度は81%であった。

20

【0393】

このように図40より、本発明の一態様である発光素子13は、長寿命な発光素子であることがわかった。

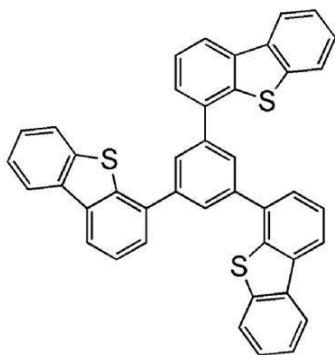
【実施例6】

【0394】

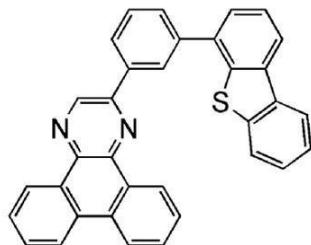
本実施例では、本発明の一態様の発光素子(発光素子16)、及び比較用の発光素子(比較発光素子17)について、図13を用いて説明する。また、本実施例で用いる材料の化学式を以下に示す。

【0395】

【化11】

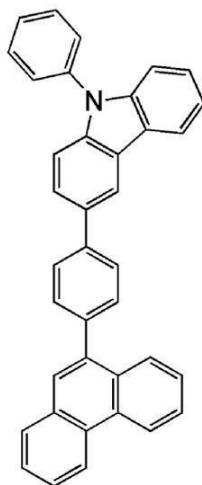


DBT3P-II

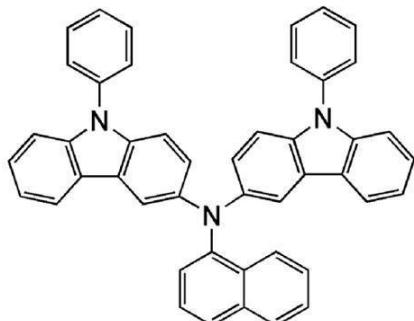


2mDBTPDBq-II

10



PCPPn



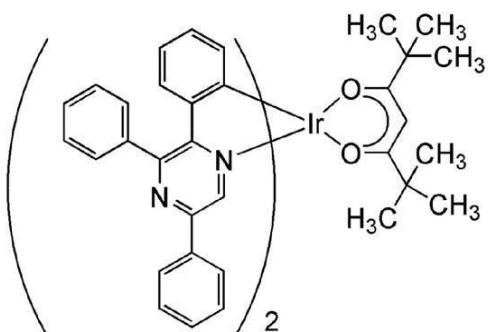
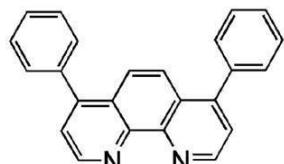
PCzPCN1

20

【0396】

【化12】

30

[Ir(tppr)₂(dpm)]

BPhen

40

【0397】

以下に、本実施例の発光素子16、及び比較発光素子17の作製方法を示す。

【0398】

(発光素子16)

まず、基板1100上に、珪素若しくは酸化珪素を含有した酸化インジウム-酸化スズ化合物(ITSO)をスパッタリング法にて成膜し、第1の電極1101を形成した。なお、用いたターゲットの組成は、In₂O₃ : SnO₂ : SiO₂ = 85 : 10 : 5 [重]

50

量%]とした。また、第1の電極1101の膜厚は、110nmとし、電極面積は2mm×2mmとした。ここで、第1の電極1101は、発光素子の陽極として機能する電極である。

【0399】

次に、基板1100上に発光素子を形成するための前処理として、基板表面を水で洗浄し、200℃で1時間焼成した後、UVオゾン処理を370秒行った。

【0400】

その後、 10^{-4} Pa程度まで内部が減圧された真空蒸着装置に基板を導入し、真空蒸着装置内の加熱室において、170℃で30分間の真空焼成を行った後、基板1100を30分程度放冷した。

10

【0401】

次に、第1の電極1101が形成された面が下方となるように、第1の電極1101が形成された基板1100を真空蒸着装置内に設けられた基板ホルダーに固定し、 10^{-4} Pa程度まで減圧した後、第1の電極1101上に、抵抗加熱を用いた蒸着法により、DBT3P-II(略称)と酸化モリブデンを共蒸着することで、正孔注入層1111を形成した。その膜厚は、30nmとし、DBT3P-II(略称)と酸化モリブデンの比率は、重量比で4:2(=DBT3P-II:酸化モリブデン)となるように調節した。

【0402】

次に、正孔注入層1111上に、3-[4-(9-フェナントリル)-フェニル]-9-フェニル-9H-カルバゾール(略称:PCPPn)とPCzPCN1(略称)を共蒸着することで、正孔輸送層1112を形成した。その膜厚は、20nmとし、PCPPn(略称)とPCzPCN1(略称)の比率は、重量比で1:1(=PCPPn:PCzPCN1)となるように調節した。

20

【0403】

次に、正孔輸送層1112上に、2mDBTPDBq-II(略称)と、PCzPCN1(略称)と、[Ir(tppr)₂(dpm)](略称)と、を共蒸着し、第1の発光層1113aを形成した。ここで、2mDBTPDBq-II(略称)、PCzPCN1(略称)、及び[Ir(tppr)₂(dpm)](略称)の重量比は、0.5:0.5:0.05(=2mDBTPDBq-II:PCzPCN1:[Ir(tppr)₂(dpm)])となるように調節した。また、第1の発光層1113aの膜厚は20nmとした。

30

【0404】

なお、第1の発光層1113aにおいて、2mDBTPDBq-II(略称)は、第1の有機化合物(ホスト材料)であり、PCzPCN1(略称)は、第2の有機化合物(アシスト材料)であり、[Ir(tppr)₂(dpm)](略称)は、第3の有機化合物(ゲスト材料)である。

【0405】

次に、第1の発光層1113a上に、2mDBTPDBq-II(略称)と、PCzPCN1(略称)と、[Ir(tppr)₂(dpm)](略称)と、を共蒸着し、第2の発光層1113bを形成した。ここで、2mDBTPDBq-II(略称)、PCzPCN1(略称)、及び[Ir(tppr)₂(dpm)](略称)の重量比は、0.8:0.2:0.05(=2mDBTPDBq-II:PCzPCN1:[Ir(tppr)₂(dpm)])となるように調節した。また、第2の発光層1113bの膜厚は20nmとした。

40

【0406】

なお、第2の発光層1113bにおいて、2mDBTPDBq-II(略称)は、第1の有機化合物(ホスト材料)であり、PCzPCN1(略称)は、第2の有機化合物(アシスト材料)であり、[Ir(tppr)₂(dpm)](略称)は、第3の有機化合物(ゲスト材料)である。

【0407】

50

次に、第2の発光層1113b上に2mDBTPDBq-II(略称)を膜厚10nmとなるように成膜し、第1の電子輸送層1114aを形成した。

【0408】

次に、第1の電子輸送層1114a上にバソフェナントロリン(略称:BPheN)を膜厚20nmとなるように成膜し、第2の電子輸送層1114bを形成した。

【0409】

次に、第2の電子輸送層1114b上に、フッ化リチウム(LiF)を1nmの膜厚で蒸着し、電子注入層1115を形成した。

【0410】

最後に、陰極として機能する第2の電極1103として、アルミニウム(A1)を200nmの膜厚となるように蒸着することで、本実施例の発光素子16を作製した。

【0411】

なお、上述した蒸着過程において、蒸着は全て抵抗加熱法を用いた。

【0412】

(比較発光素子17)

比較発光素子17は、発光素子16と正孔輸送層1112の構成が異なり、それ以外の構成は同じである。異なる構成のみ以下記載する。

【0413】

正孔注入層1111上に、PCPPn(略称)を蒸着することで、正孔輸送層1112を形成した。その膜厚は、20nmとした。

【0414】

以上により得られた発光素子16、及び比較発光素子17の素子構造を表11に示す。

【0415】

【表11】

	第1の電極	正孔注入層	正孔輸送層	第1の発光層	第2の発光層	第1の電子輸送層	第2の電子輸送層	電子注入層	第2の電極
発光素子16	ITSO 110nm	DBT3P-II:MoO _x (=4:2) 30nm	PCPPn: PCzPCN1 (1:1) 20nm	下記記載	下記記載	2mDBTPDBq-II 10nm	BPheN 20nm	LiF 1nm	Al 200nm
比較発光素子17	ITSO 110nm	DBT3P-II:MoO _x (=4:2) 30nm	PCPPn 20nm	下記記載	下記記載	2mDBTPDBq-II 10nm	BPheN 20nm	LiF 1nm	Al 200nm

	第1の発光層	第2の発光層
発光素子16	2mDBTPDBq-II:PCzPCN1:Ir(tppr) ₂ (dpm) (=0.5:0.5:0.05) 20nm	2mDBTPDBq-II:PCzPCN1:Ir(tppr) ₂ (dpm) (=0.8:0.2:0.05) 20nm
比較発光素子17	2mDBTPDBq-II:PCzPCN1:Ir(tppr) ₂ (dpm) (=0.5:0.5:0.05) 20nm	2mDBTPDBq-II:PCzPCN1:Ir(tppr) ₂ (dpm) (=0.8:0.2:0.05) 20nm

【0416】

発光素子16、及び比較発光素子17を、窒素雰囲気のグローブボックス内において、各発光素子が大気に曝されないようにガラス基板により封止する作業(シール材を素子の周囲に塗布し、封止時に80にて1時間熱処理)を行った。その後、これらの発光素子の動作特性について測定を行った。なお、測定は室温(25に保たれた雰囲気)で行った。

【0417】

発光素子16、及び比較発光素子17の電流密度-輝度特性を図41に示す。図41において、横軸は電流密度(mA/cm²)を、縦軸は輝度(cd/m²)を表す。また、発光素子16、及び比較発光素子17の電圧-輝度特性を図42に示す。図42において、横軸は電圧(V)を、縦軸は輝度(cd/m²)を表す。また、発光素子16、及び比較発光素子17の輝度-電流効率特性を図43に示す。図43において、横軸は輝度(cd/m²)、縦軸は電流効率(cd/A)を表す。また、発光素子16、及び比較発光素子17の電圧-電流特性を図44に示す。図44において、横軸は電圧(V)を、縦軸は

10

20

30

40

50

電流 (mA) を表す。また、発光素子16、及び比較発光素子17の発光スペクトルを図45に示す。図45において、横軸は波長 (nm)、縦軸は発光強度 (任意単位) を表す。なお、図45において、各発光素子のデータが概略重なって示されている。

【0418】

また、各発光素子における輝度 1000 cd/m^2 付近のときの電圧 (V)、電流密度 (mA/cm²)、CIE色度座標 (x, y)、電流効率 (cd/A)、外部量子効率 (%) を表12に示す。

【0419】

【表12】

	電圧(V)	電流密度 (mA/cm ²)	CIE色度座標		輝度 (cd/m ²)	電流効率 (cd/A)	外部 量子効率(%)
			x	y			
発光素子16	2.9	3.5	0.66	0.34	1095	31	25
比較発光素子17	3.2	3.1	0.66	0.34	910	30	25

10

【0420】

表12に示す通り、輝度 1095 cd/m^2 の発光素子16のCIE色度座標は、(x, y) = (0.66, 0.34) であった。また、輝度 910 cd/m^2 の比較発光素子17のCIE色度座標は、(x, y) = (0.66, 0.34) であった。

【0421】

20

また、輝度 1095 cd/m^2 の発光素子16の電圧は2.9Vであり、電流効率は31cd/Aであった。また、輝度 910 cd/m^2 の比較発光素子17の電圧は3.2Vであり、電流効率は30cd/Aであった。

【0422】

したがって、本発明の一態様である発光素子16は、比較発光素子17と比べると、電圧を0.3V低くすることができ、且つ電流効率を同等にできることができた。

【0423】

この結果は、以下のように説明できる。まず、本実施例で用いたPCzPCN1(略称)、及びPCPPn(略称)の各薄膜でのHOMO準位は、それぞれ、-5.15eV、-5.78eVである。

30

【0424】

比較発光素子17は、発光層の構成は発光素子16と同じであるため、駆動開始電圧はほぼ同じである。しかしながら比較発光素子17は、正孔輸送層が発光層の第2の有機化合物(PCzPCN1)よりもHOMO準位がかなり低いPCPPnのみからなっているため、正孔輸送層から発光層への正孔の移動が潤滑に進まず、高輝度(実用輝度)領域での電圧-電流特性が悪くなっていることがわかる。その結果、 1000 cd/m^2 付近での駆動電圧は高電圧シフトしている。

【0425】

このように、本発明の一態様である発光素子16は、比較発光素子17と比べて、低い電圧を維持し、且つ高い電流効率であった。

40

【0426】

以上のように、本発明の一態様である発光素子は、発光層(第1の発光層1113a及び第2の発光層1113b)に用いる正孔輸送性を有する第2の有機化合物が、正孔輸送層1112にも含まれた素子構成である。このような構成とすることで、発光素子の電圧(駆動開始電圧および実用輝度領域での駆動電圧の双方)を正孔輸送層が有する第2の有機化合物により低くすることができる。また、本発明の一態様である発光素子は、第2の有機化合物だけで形成した正孔輸送層と比較し、第2の有機化合物以外の材料も有するため、発光層からの三重項励起エネルギーの拡散を第2の有機化合物以外の材料により抑制し、発光効率の高い優れた発光素子とすることができます。

【0427】

50

なお、本実施例（発光素子 16）の発光層に用いた第1の有機化合物（2mDBTPD Bq-II）の薄膜のPLピーク波長は426 nm、第2の有機化合物（PCzPCN1）のPLピーク波長は479 nmであるが、これらの混合膜のPLピーク波長は571 nmであり、長波長シフトしていることがわかった。したがって、これら2種類の有機化合物は、励起錯体を形成する組み合わせである。

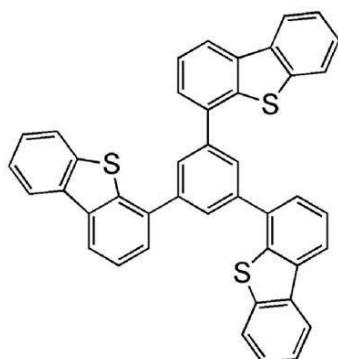
【実施例7】

【0428】

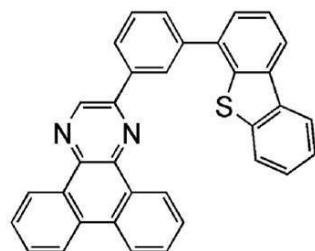
本実施例では、本発明の一態様の発光素子（発光素子18）、及び比較用の発光素子（比較発光素子19）について、図13を用いて説明する。また、本実施例で用いる材料の化学式を以下に示す。

【0429】

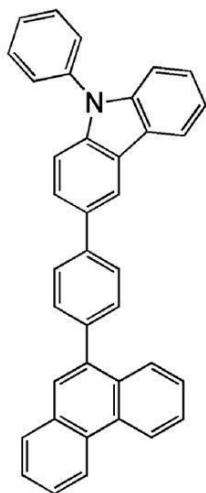
【化13】



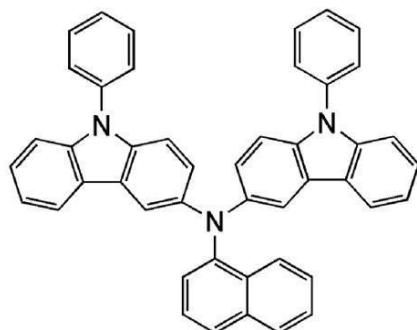
DBT3P-II



2mDBTPDBq-II



PCPPn



PCzPCN1

【0430】

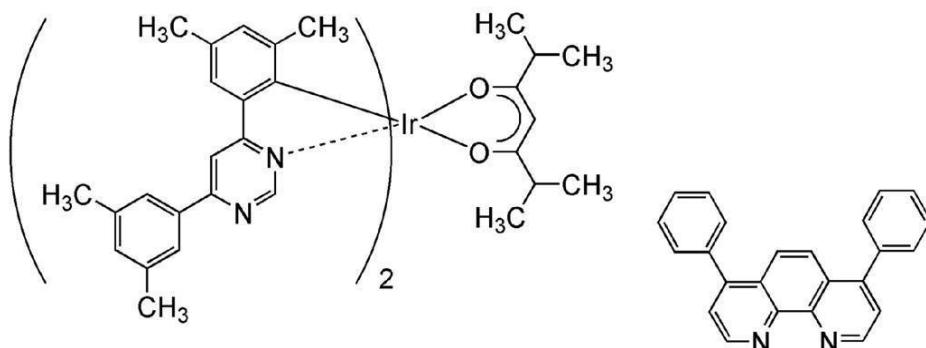
10

20

30

40

【化14】

[Ir(dmdppm)₂(dibm)]

BPhen

【0431】

以下に、本実施例の発光素子18、及び比較発光素子19の作製方法を示す。

【0432】

(発光素子18)

まず、基板1100上に、珪素若しくは酸化珪素を含有した酸化インジウム-酸化スズ化合物(ITSO)をスパッタリング法にて成膜し、第1の電極1101を形成した。なお、用いたターゲットの組成は、In₂O₃ : SnO₂ : SiO₂ = 85 : 10 : 5 [重量%]とした。また、第1の電極1101の膜厚は、110 nmとし、電極面積は2 mm × 2 mmとした。ここで、第1の電極1101は、発光素子の陽極として機能する電極である。

【0433】

次に、基板1100上に発光素子を形成するための前処理として、基板表面を水で洗浄し、200℃で1時間焼成した後、UVオゾン処理を370秒行った。

【0434】

その後、10⁻⁴ Pa程度まで内部が減圧された真空蒸着装置に基板を導入し、真空蒸着装置内の加熱室において、170℃で30分間の真空焼成を行った後、基板1100を30分程度放冷した。

【0435】

次に、第1の電極1101が形成された面が下方となるように、第1の電極1101が形成された基板1100を真空蒸着装置内に設けられた基板ホルダーに固定し、10⁻⁴ Pa程度まで減圧した後、第1の電極1101上に、抵抗加熱を用いた蒸着法により、DBT3P-II(略称)と酸化モリブデンを共蒸着することで、正孔注入層1111を形成した。その膜厚は、30 nmとし、DBT3P-II(略称)と酸化モリブデンの比率は、重量比で4:2(=DBT3P-II:酸化モリブデン)となるように調節した。

【0436】

次に、正孔注入層1111上に、PCPPn(略称)とPCzPCN1(略称)を共蒸着することで、正孔輸送層1112を形成した。その膜厚は、20 nmとし、PCPPn(略称)とPCzPCN1(略称)の比率は、重量比で1:1(=PCPPn:PCzPCN1)となるように調節した。

【0437】

次に、正孔輸送層1112上に、2mDBTPDBq-II(略称)と、PCzPCN1(略称)と、[Ir(dmdppm)₂(dibm)](略称)と、を共蒸着し、第1の発光層1113aを形成した。ここで、2mDBTPDBq-II(略称)、PCzPCN1(略称)、及び[Ir(dmdppm)₂(dibm)](略称)の重量比は、0.5:0.5:0.05(=2mDBTPDBq-II:PCzPCN1:[Ir(dmdppm)₂(dibm)])となるように調節した。また、第1の発光層1113aの膜厚は20 nmとした。

10

20

30

40

50

【0438】

なお、第1の発光層1113aにおいて、2mDBTPDBq-II(略称)は、第1の有機化合物(ホスト材料)であり、PCzPCN1(略称)は、第2の有機化合物(アシスト材料)であり、[Ir(dmdppm)₂(dibm)](略称)は、第3の有機化合物(ゲスト材料)である。

【0439】

次に、第1の発光層1113a上に、2mDBTPDBq-II(略称)と、PCzPCN1(略称)と、[Ir(dmdppm)₂(dibm)](略称)と、を共蒸着し、第2の発光層1113bを形成した。ここで、2mDBTPDBq-II(略称)、PCzPCN1(略称)、及び[Ir(dmdppm)₂(dibm)](略称)の重量比は10、0.8:0.2:0.05(=2mDBTPDBq-II:PCzPCN1:[Ir(dmdppm)₂(dibm)])となるように調節した。また、第2の発光層1113bの膜厚は20nmとした。

【0440】

なお、第2の発光層1113bにおいて、2mDBTPDBq-II(略称)は、第1の有機化合物(ホスト材料)であり、PCzPCN1(略称)は、第2の有機化合物(アシスト材料)であり、[Ir(dmdppm)₂(dibm)](略称)は、第3の有機化合物(ゲスト材料)である。

【0441】

次に、第2の発光層1113b上に2mDBTPDBq-II(略称)を膜厚10nm20ととなるように成膜し、第1の電子輸送層1114aを形成した。

【0442】

次に、第1の電子輸送層1114a上にパソフェナントロリン(略称:BPhen)を膜厚20nmとなるように成膜し、第2の電子輸送層1114bを形成した。

【0443】

次に、第2の電子輸送層1114b上に、フッ化リチウム(LiF)を1nmの膜厚で蒸着し、電子注入層1115を形成した。

【0444】

最後に、陰極として機能する第2の電極1103として、アルミニウム(Al)を200nmの膜厚となるように蒸着することで、本実施例の発光素子18を作製した。30

【0445】

なお、上述した蒸着過程において、蒸着は全て抵抗加熱法を用いた。

【0446】

(比較発光素子19)

比較発光素子19は、発光素子18と正孔輸送層1112の構成が異なり、それ以外の構成は同じである。異なる構成のみ以下記載する。

【0447】

正孔注入層1111上に、PCPPn(略称)を蒸着することで、正孔輸送層1112を形成した。その膜厚は、20nmとした。

【0448】

以上により得られた発光素子18、及び比較発光素子19の素子構造を表13に示す。

【0449】

【表13】

	第1の電極	正孔注入層	正孔輸送層	第1の発光層	第2の発光層	第1の電子輸送層	第2の電子輸送層	電子注入層	第2の電極
発光素子18	ITSO 110nm	DBT3P-II:MoO _x (=4:2) 30nm	PCPPn: PCzPCN1 (1:1) 20nm	下記記載	下記記載	2mDBTPDBq-II 10nm	BPhen 20nm	LiF 1nm	Al 200nm
比較発光素子19	ITSO 110nm	DBT3P-II:MoO _x (=4:2) 30nm	PCPPn 20nm	下記記載	下記記載	2mDBTPDBq-II 10nm	BPhen 20nm	LiF 1nm	Al 200nm
第1の発光層									
発光素子18	2mDBTPDBq-II:PCzPCN1:Ir(dmdppm) ₂ (dibm) (=0.5:0.5:0.05) 20nm				2mDBTPDBq-II:PCzPCN1:Ir(dmdppm) ₂ (dibm) (=0.8:0.2:0.05) 20nm				
比較発光素子19	2mDBTPDBq-II:PCzPCN1:Ir(dmdppm) ₂ (dibm) (=0.5:0.5:0.05) 20nm				2mDBTPDBq-II:PCzPCN1:Ir(dmdppm) ₂ (dibm) (=0.8:0.2:0.05) 20nm				

【0450】

発光素子18、及び比較発光素子19を、窒素雰囲気のグローブボックス内において、各発光素子が大気に曝されないようにガラス基板により封止する作業（シール材を素子の周囲に塗布し、封止時に80にて1時間熱処理）を行った。その後、これらの発光素子の動作特性について測定を行った。なお、測定は室温（25に保たれた雰囲気）で行った。

【0451】

発光素子18、及び比較発光素子19の電流密度-輝度特性を図46に示す。図46において、横軸は電流密度（mA/cm²）を、縦軸は輝度（cd/m²）を表す。また、発光素子18、及び比較発光素子19の電圧-輝度特性を図47に示す。図47において、横軸は電圧（V）を、縦軸は輝度（cd/m²）を表す。また、発光素子18、及び比較発光素子19の輝度-電流効率特性を図48に示す。図48において、横軸は輝度（cd/m²）、縦軸は電流効率（cd/A）を表す。また、発光素子18、及び比較発光素子19の電圧-電流特性を図49に示す。図49において、横軸は電圧（V）を、縦軸は電流（mA）を表す。また、発光素子18、及び比較発光素子19の発光スペクトルを図50に示す。図50において、横軸は波長（nm）、縦軸は発光強度（任意単位）を表す。なお、図50において、各発光素子のデータが概略重なって示されている。

【0452】

また、各発光素子における輝度1000cd/m²付近のときの電圧（V）、電流密度（mA/cm²）、CIE色度座標（x、y）、電流効率（cd/A）、外部量子効率（%）を表14に示す。

【0453】

【表14】

	電圧(V)	電流密度 (mA/cm ²)	CIE色度座標		輝度 (cd/m ²)	電流効率 (cd/A)	外部 量子効率(%)
			x	y			
発光素子18	2.6	1.3	0.61	0.39	931	62	30
比較発光素子19	3.0	1.6	0.61	0.39	941	59	29

【0454】

表14に示す通り、輝度931cd/m²の発光素子18のCIE色度座標は、（x、y）=（0.61, 0.39）であった。また、輝度941cd/m²の比較発光素子19のCIE色度座標は、（x、y）=（0.61, 0.39）であった。

【0455】

また、輝度931cd/m²の発光素子18の電圧は2.6Vであり、電流効率は62cd/Aであった。また、輝度941cd/m²の比較発光素子19の電圧は3.0Vであり、電流効率は59cd/Aであった。

10

20

30

40

50

【0456】

したがって、本発明の一態様である発光素子18は、比較発光素子19と比べると、電圧を0.4V低くすることができ、且つ電流効率を同等にできることができることが確認された。

【0457】

この結果は、以下のように説明できる。まず、本実施例で用いたP CZ PCN1(略称)、及びPCPPn(略称)の各薄膜でのHOMO準位は、それぞれ、-5.15eV、-5.78eVである。

【0458】

比較発光素子19は、発光層の構成は発光素子18と同じであるため、駆動開始電圧はほぼ同じである。しかしながら比較発光素子19は、正孔輸送層が発光層の第2の有機化合物(P CZ PCN1)よりもHOMO準位がかなり低いPCPPnのみからなっているため、正孔輸送層から発光層への正孔の移動が潤滑に進まず、高輝度(実用輝度)領域での電圧-電流特性が悪くなっていることがわかる。その結果、1000cd/m²付近での駆動電圧は高電圧シフトしてしまっている。

【0459】

このように、本発明の一態様である発光素子18は、比較発光素子19と比べて、低い電圧を維持し、且つ高い電流効率であった。

【0460】

以上のように、本発明の一態様である発光素子は、発光層(第1の発光層1113a及び第2の発光層1113b)に用いる正孔輸送性を有する第2の有機化合物が、正孔輸送層1112にも含まれた素子構成である。このような構成とすることで、発光素子の電圧(駆動開始電圧および実用輝度領域での駆動電圧の双方)を正孔輸送層が有する第2の有機化合物により低くすることができる。また、本発明の一態様である発光素子は、第2の有機化合物だけで形成した正孔輸送層と比較し、第2の有機化合物以外の材料も有するため、発光層からの三重項励起エネルギーの拡散を第2の有機化合物以外の材料により抑制し、発光効率の高い優れた発光素子とすることができます。

【0461】

なお、本実施例(発光素子18)の発光層に用いた第1の有機化合物(2mDBTPD Bq-II)の薄膜のPLピーク波長は426nm、第2の有機化合物(P CZ PCN1)のPLピーク波長は479nmであるが、これらの混合膜のPLピーク波長は571nmであり、長波長シフトしていることがわかった。したがって、これら2種類の有機化合物は、励起錯体を形成する組み合わせである。

【0462】

(参考例1)

上記実施例で用いたビス{2-[6-(3,5-ジメチルフェニル)-4-ピリミジニル-N(3)-4,6-ジメチルフェニル-C}(2,6-ジメチル-3,5-ヘプタジオナト-²O,O')イリジウム(III)(略称:[Ir(dmdppm)₂(dibm)])の合成方法について具体的に説明する。[Ir(dmdppm)₂(dibm)](略称)の構造を以下に示す。

【0463】

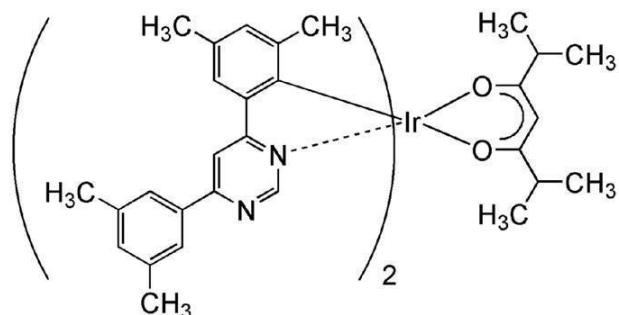
10

20

30

40

【化15】



10

[Ir(dmdppm)₂(dibm)]

【0464】

<ステップ1: 4,6-ビス(3,5-ジメチルフェニル)ピリミジン(略称:Hdm dp pm)の合成法>

まず、4,6-ジクロロピリミジン5.97gと3,5-ジメチルフェニルボロン酸12.04g、炭酸ナトリウム8.48g、ビス(トリフェニルホスフィン)パラジウム(II)ジクロリド(Pd(PPh₃)₂C₁₂)0.34g、水20mL、1,3-ジメチル-3,4,5,6-テトラヒドロ-2(1H)ピリミジノン(略称:DMPU)20mLを、還流管を付けたナスフラスコに入れ、内部をアルゴン置換した。この反応容器にマイクロ波(2.45GHz 100W)を60分間照射することで加熱した。ここで更に3,5-ジメチルフェニルボロン酸2.58g、炭酸ナトリウム1.78g、Pd(PPh₃)₂C₁₂0.070g、水5mL、DMPU5mLをフラスコに入れ、再度マイクロ波(2.45GHz 100W)を60分間照射することで加熱した。

20

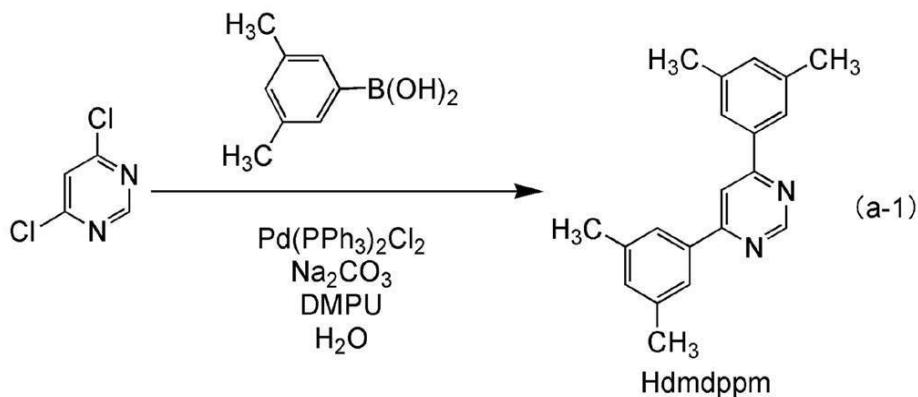
【0465】

その後、得られた残渣を水で吸引ろ過し、水、エタノールで洗浄した。得られた固体をジクロロメタンに溶かし、セライト、アルミナ、セライトの順で積層した濾過補助剤を通して濾過した後、エタノールで洗浄することにより、目的のピリミジン誘導体Hdm dp pmを得た(白色粉末、収率56%)。なお、マイクロ波の照射はマイクロ波合成装置(CEM社製Discover)を用いた。ステップ1の合成スキームを下記(a-1)に示す。

30

【0466】

【化16】



40

【0467】

<ステップ2:ジ-μ-クロロ-テトラキス{2-[6-(3,5-ジメチルフェニル)-4-ピリミジニル-N3]-4,6-ジメチルフェニル-C}ジイリジウム(II)

50

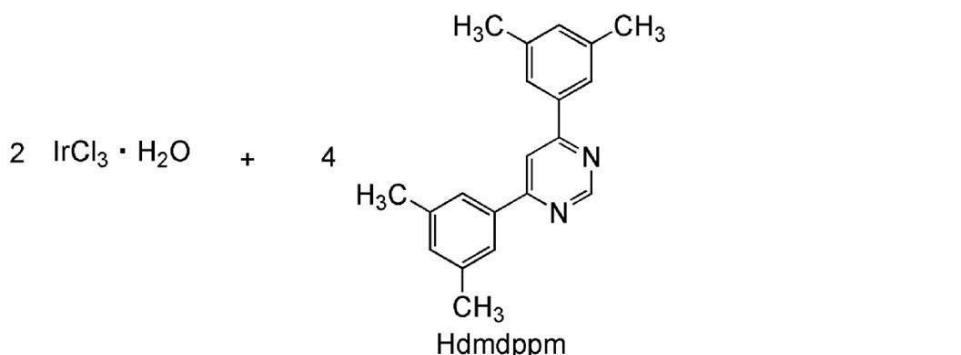
I) (略称 : [Ir(dmdppm)₂Cl]₂) の合成法 >

次に、2-エトキシエタノール 15 mL と水 5 mL、上記ステップ 1 で得た H d m d p p m (略称) 2.10 g、塩化イリジウム水和物 (IrCl₃ · H₂O) (Sigma-Aldrich 社製) 1.07 g を、還流管を付けたナスフラスコに入れ、フラスコ内をアルゴン置換した。その後、マイクロ波 (2.45 GHz 100 W) を 1 時間照射し、反応させた。溶媒を留去した後、得られた残渣をエタノールで吸引ろ過、洗浄し、複核錯体 [Ir(dmdppm)₂Cl]₂ (略称) を得た (赤褐色粉末、収率 74 %)。ステップ 2 の合成スキームを下記 (a-2) に示す。

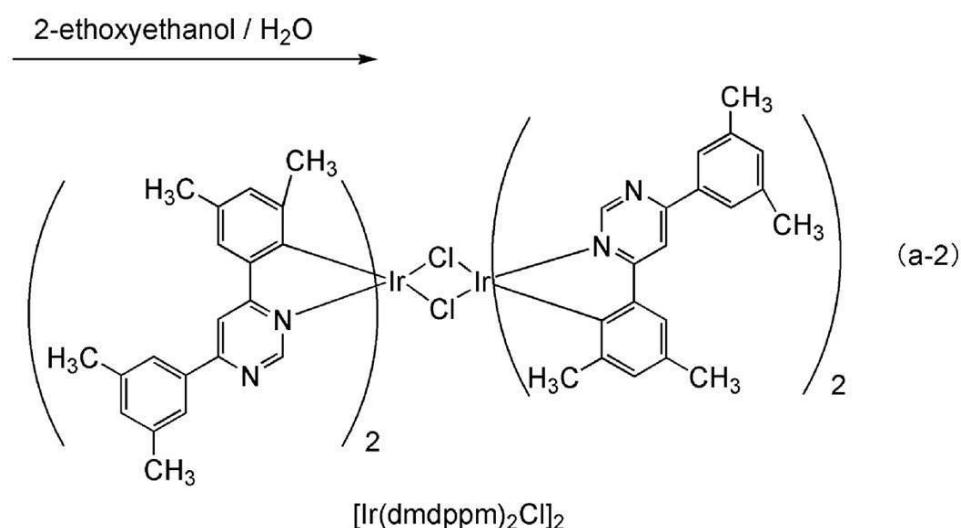
【0468】

【化17】

10



20



30

【0469】

<ステップ 3 : ビス { 2 - [6 - (3 , 5 - ジメチルフェニル) - 4 - ピリミジニル - N₃] - 4 , 6 - ジメチルフェニル - C } (2 , 6 - ジメチル - 3 , 5 - ヘプタンジオナト - O²⁻ , O⁻) イリジウム (III) (略称 : [Ir(dmdppm)₂(dibm)]) の合成法 >

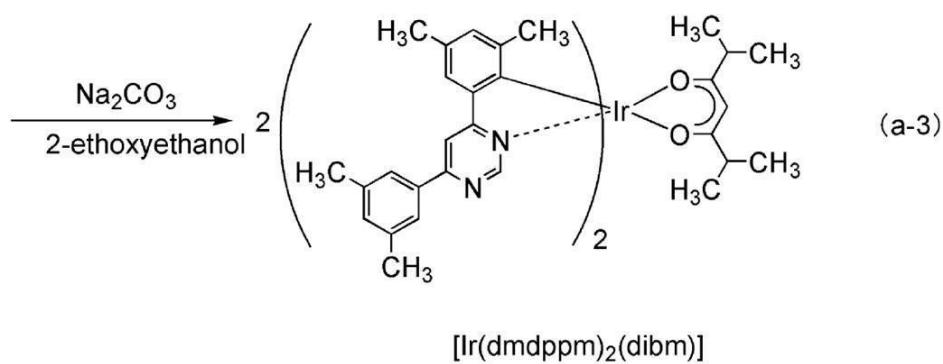
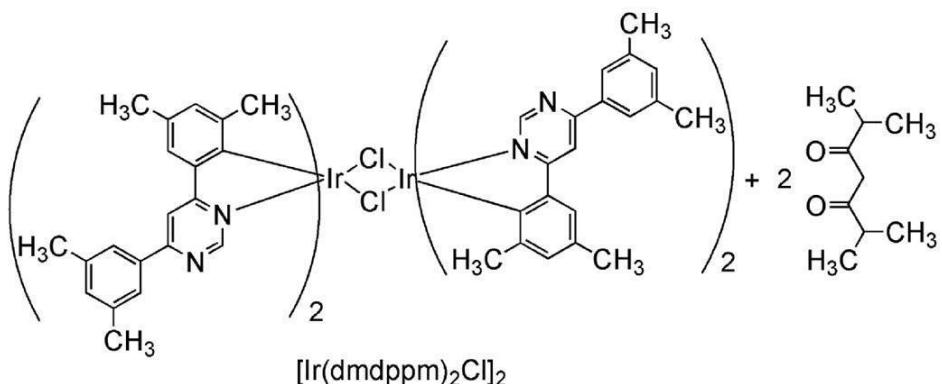
40

さらに、2-エトキシエタノール 30 mL、上記ステップ 2 で得た複核錯体 [Ir(dmdppm)₂Cl]₂ (略称) 1.09 g、ジイソブチリルメタン (略称 : H dibm) 0.32 g、炭酸ナトリウム 0.72 g を、還流管を付けたナスフラスコに入れ、フラスコ内をアルゴン置換した。その後、マイクロ波 (2.45 GHz 120 W) を 60 分間照射することで加熱した。溶媒を留去し、得られた残渣をエタノールで吸引ろ過した。得られた固体を水、エタノールで洗浄し、ジクロロメタンとエタノールの混合溶媒にて再結晶することにより、実施例に用いた有機金属錯体 [Ir(dmdppm)₂(dibm)] (略称) を赤色粉末として得た (収率 62 %)。ステップ 3 の合成スキームを下記 (a-3) に示す。

【0470】

50

【化18】



【0471】

なお、上記合成方法により得られた化合物を核磁気共鳴分光法（¹H-NMR）により測定した。測定結果から、[Ir(dmdppm)₂(dibm)]（略称）が得られたことがわかった。

【0472】

得られた物質の¹H-NMRデータを以下に示す。

¹H-NMR. (CDC13): 0.69 (d, 6H), 0.82 (d, 6H), 1.51 (s, 6H), 2.17-2.23 (m, 2H), 2.31 (s, 6H), 2.45 (s, 12H), 5.19 (s, 1H), 6.61 (s, 2H), 7.17 (s, 2H), 7.56 (s, 2H), 7.82 (s, 4H), 8.11 (d, 2H), 8.88 (d, 2H).

【0473】

(参考例2)

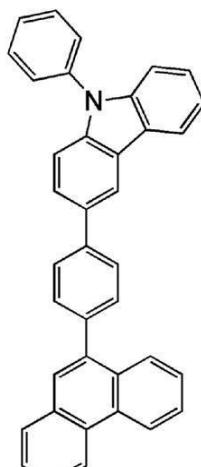
上記実施例で用いた3-[4-(9-フェナントリル)-フェニル]-9-フェニル-9H-カルバゾール（略称：PCPPn）の合成方法について具体的に説明する。PCPPn（略称）の構造を以下に示す。

【0474】

30

40

【化19】



10

PCPPn

【0475】

<ステップ1：3-(4-ブロモフェニル)-9-フェニル-9H-カルバゾールの合成法>

20

300 mL 三口フラスコにて、4-ブロモヨードベンゼン 14 g (50 mmol)、9-フェニル-9H-カルバゾール-3-ボロン酸 14 g (50 mmol)、酢酸パラジウム (II) 110 mg (0.5 mmol)、トリ(0-トリル)ホスフィン 300 mg (1.0 mmol)、トルエン 50 mL、エタノール 10 mL、2 mol/L 炭酸カリウム水溶液 25 mL の混合物を、減圧下で攪拌しながら脱気した後、窒素雰囲気下、80 で 6 時間加熱攪拌し、反応させた。

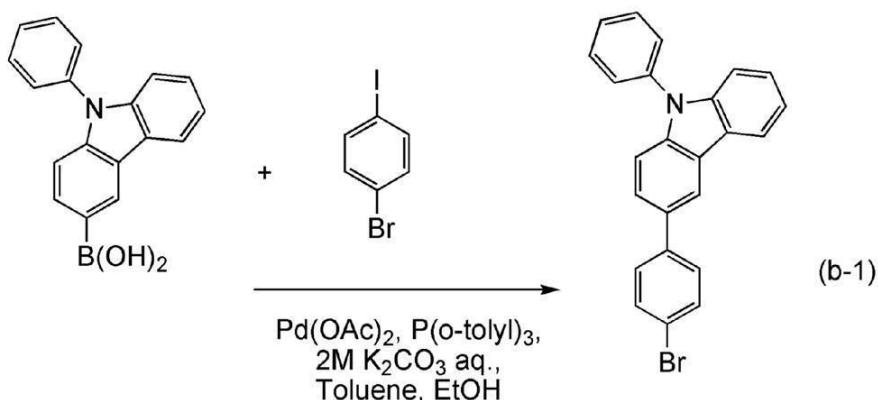
【0476】

反応後、この反応混合液にトルエン 200 mL を加え、この懸濁液をフロリジール、セライトを通してろ過した。得られたろ液を水で洗浄し、硫酸マグネシウムを加えて水分を吸着させた。この懸濁液をろ過してろ液を得た。得られたろ液を濃縮し、シリカゲルカラムクロマトグラフィーによる精製を行った。このとき、クロマトグラフィーの展開溶媒として、トルエンとヘキサンの混合溶媒 (トルエン：ヘキサン = 1 : 4) を用いた。得られたフラクションを濃縮し、ヘキサンを加えて超音波をかけたのち、再結晶したところ、目的物の白色粉末を収量 15 g、収率 75 % で得た。上記ステップ1の反応スキームを下記 (b-1) に示す。

30

【0477】

【化20】



40

(b-1)

50

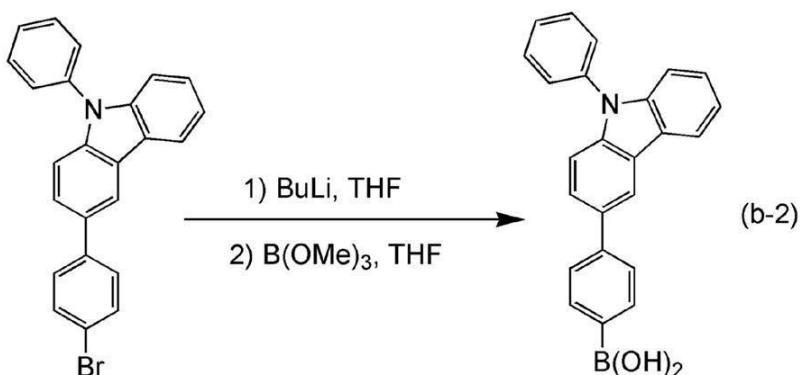
【0478】

<ステップ2: 4-(9-フェニル-9H-カルバゾール-3-イル)フェニルボロン酸の合成法>

300mL三口フラスコに、上記反応スキーム(b-1)で得られた3-(4-ブロモフェニル)-9-フェニル-9H-カルバゾールを8.0g(20mmol)入れ、フラスコ内の雰囲気を窒素置換したのち、脱水テトラヒドロフラン(略称: THF)100mLを加えて-78℃にした。この混合液に1.65mol/Lのn-ブチルリチウムヘキサン溶液15mL(24mmol)を滴下し、2時間攪拌した。この混合物にホウ酸トリメチル3.4mL(30mmol)を加え、-78℃で2時間、室温で18時間攪拌した。反応後、この反応溶液に1M希塩酸を酸性になるまで加えて7時間攪拌した。これを酢酸エチルで抽出し、得られた有機層を飽和食塩水で洗浄した。洗浄後、有機層に硫酸マグネシウムを加えて水分を吸着させた。この懸濁液をろ過し、得られたろ液を濃縮し、ヘキサンを加え超音波をかけたのち、再結晶したところ、目的の白色粉末を収量6.4g、収率88%で得た。上記ステップ2の反応スキームを下記(b-2)に示す。

【0479】

【化21】



【0480】

<ステップ2: 3-[4-(9-フェナントリル)-フェニル]-9-フェニル-9H-カルバゾール(略称: PCPPn)の合成法>

200mL三口フラスコへ9-フェニル-9H-カルバゾール-3-イル-フェニル-4-ボロン酸を1.5g(5.0mmol)、9-ブロモフェナントレンを3.2g(1.1mmol)、酢酸パラジウム(II)を11mg(0.1mmol)、トリ(o-トリル)ホスフィンを30mg(0.1mmol)、トルエン30mL、エタノール3mL、2mol/L炭酸カリウム水溶液5mLの混合物を、減圧下で攪拌しながら脱気した後、窒素雰囲気下、90℃で6時間加熱攪拌し、反応させた。

【0481】

反応後、この反応混合液にトルエン200mLを加え、この混合液の有機層をフロリジール、アルミナ、セライトを通してろ過した。得られたろ液を水で洗浄し、硫酸マグネシウムを加えて水分を吸着させた。この懸濁液をろ過してろ液を得た。得られたろ液を濃縮し、シリカゲルカラムクロマトグラフィーによる精製を行った。このとき、クロマトグラフィーの展開溶媒として、トルエンとヘキサンの混合溶媒(トルエン:ヘキサン=1:4)を用いた。得られたフラクションを濃縮し、アセトンとメタノールを加えて超音波をかけたのち、再結晶したところ、目的物の白色粉末を収量2.2g、収率75%で得た。ステップ3の反応スキームを下記(b-3)に示す。

【0482】

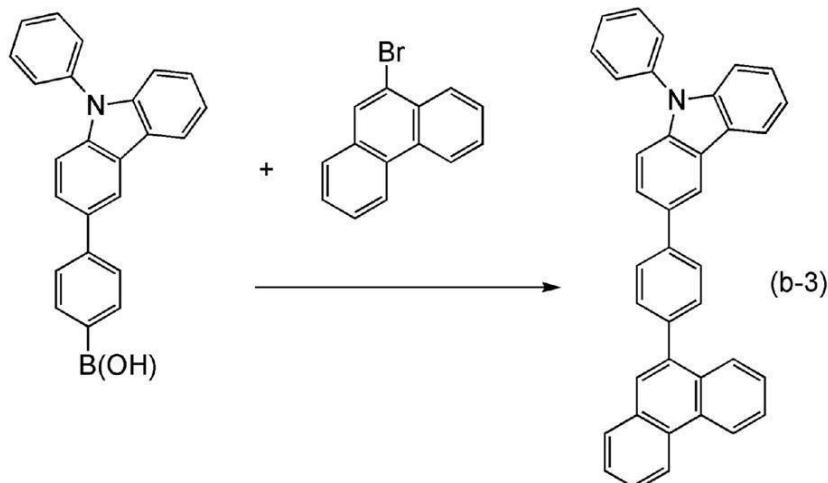
10

20

30

40

【化22】



【0483】

なお、上記合成方法により得られた化合物を核磁気共鳴分光法 (¹H-NMR) により測定した。測定結果から、PCPPn (略称) が得られたことがわかった。

【0484】

得られた物質の ¹H-NMR データを以下に示す。

20

¹H-NMR (CDCl₃, 300 MHz): (ppm) = 7.30 - 7.35 (m, 11H), 7.43 - 7.78 (m, 16H), 7.86 - 7.93 (m, 3H), 8.01 (dd, J = 0.9 Hz, 7.8 Hz, 1H), 8.23 (d, J = 7.8 Hz, 1H), 8.47 (d, J = 1.5 Hz, 1H), 8.74 (d, J = 8.1 Hz, 1H), 8.80 (d, J = 7.8 Hz, 1H).

【0485】

(参考例3)

上述した実施例において、各発光素子に用いた2mDBTPDBq-II (略称)、PCzPCN1 (略称)、DPA2SF (略称)、BPALP (略称)、およびPCPPn (略称)のT₁準位について測定した。なお、T₁準位の測定は、各物質の燐光発光を測定し、燐光発光波長をエレクトロンボルトに換算することにより求めた。測定条件としては、325 nm の励起光を各物質に照射し、測定温度10 Kで測定した。なお、エネルギー準位の測定は、発光波長より吸収波長から算出した方が精度は高い。しかしながら、T₁準位の吸収は極めて微弱であり、測定が困難であることから、ここでは、燐光スペクトルの最も短波長側に位置するピーク波長を測定することによりT₁準位を求めた。したがって、測定値に多少の誤差を含むものとする。

30

【0486】

測定した2mDBTPDBq-II (略称)の燐光発光を図51に、測定したPCzPCN1 (略称)の燐光発光を図52に、測定したDPA2SF (略称)の燐光発光を図53に、測定したBPALP (略称)の燐光発光を図54に、測定したPCPPn (略称)の燐光発光を図55にそれぞれ示す。また、測定結果を表15にまとめた。この結果からわかるように、上述した実施例において第1の有機化合物として用いた2mDBTPDBq-II (略称)や、第2の有機化合物として用いたPCzPCN1 (略称)およびDPA2SF (略称)に比べ、正孔輸送層に添加したBPALP (略称)や第4の有機化合物に相当するPCPPn (略称)は、T₁準位が高いことがわかる。

40

【0487】

【表 1 5】

物質名	発光発光波長(nm)	T1準位(eV)
2mDBTPDBq-II(略称)	516	2.40
PCzPCN1(略称)	560	2.21
DPA2SF(略称)	534	2.32
BPAFLP(略称)	497	2.49
PCPPn(略称)	502	2.47

【符号の説明】

10

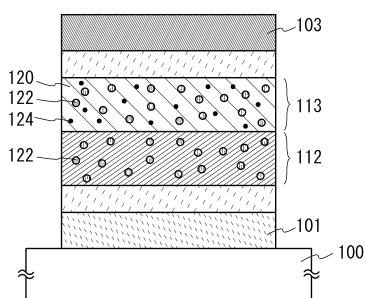
【0 4 8 8】

1 0 0	基板	
1 0 1	第1の電極	
1 0 3	第2の電極	
1 1 1	正孔注入層	
1 1 2	正孔輸送層	
1 1 2 a	正孔輸送層	
1 1 2 b	正孔輸送層	
1 1 2 c	正孔輸送層	
1 1 3	発光層	20
1 1 4	電子輸送層	
1 1 5	電子注入層	
1 2 0	第1の有機化合物	
1 2 2	第2の有機化合物	
1 2 4	第3の有機化合物	
1 2 6	第4の有機化合物	
3 0 1	第1の電極	
3 0 3	第2の電極	
3 1 1	第1の発光層	
3 1 2	第2の発光層	30
3 1 3	電荷発生層	
4 5 0 R	第1の発光素子	
4 5 0 G	第2の発光素子	
4 5 0 B	第3の発光素子	
4 5 1	反射電極	
4 5 2	半透過・半反射電極	
4 5 3 a	第1の透明導電層	
4 5 3 b	第2の透明導電層	
4 5 4	発光層	
4 5 4 B	第1の発光層	40
4 5 4 G	第2の発光層	
4 5 4 R	第3の発光層	
4 5 5	EL層	
5 0 1	素子基板	
5 0 2	画素部	
5 0 3	駆動回路部	
5 0 4	駆動回路部	
5 0 5	シール材	
5 0 6	封止基板	
5 0 7	配線	50

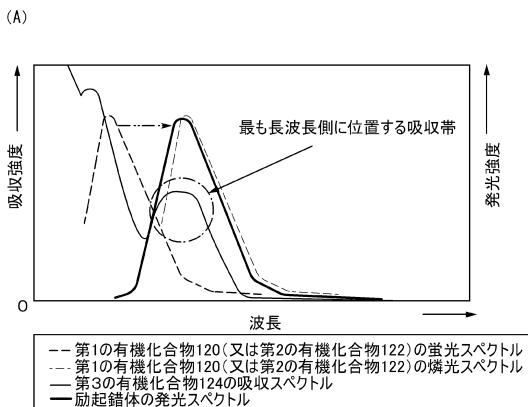
5 0 8	F P C	
5 0 9	n チャネル型 T F T	
5 1 0	p チャネル型 T F T	
5 1 1	スイッチング用 T F T	
5 1 2	電流制御用 T F T	
5 1 3	第 1 の電極	
5 1 4	絶縁物	
5 1 5	E L 層	
5 1 6	第 2 の電極	
5 1 7	発光素子	10
5 1 8	空間	
6 1 1	筐体	
6 1 2	支持台	
6 1 3	表示部	
6 1 4	スピーカー部	
6 1 5	ビデオ入力端子	
6 2 1	本体	
6 2 2	筐体	
6 2 3	表示部	
6 2 4	キー ボード	20
6 2 5	外部接続ポート	
6 2 6	ポインティングデバイス	
6 3 1	本体	
6 3 2	筐体	
6 3 3	表示部	
6 3 4	音声入力部	
6 3 5	音声出力部	
6 3 6	操作キー	
6 3 7	外部接続ポート	
6 3 8	アンテナ	30
6 4 1	本体	
6 4 2	表示部	
6 4 3	筐体	
6 4 4	外部接続ポート	
6 4 5	リモコン受信部	
6 4 6	受像部	
6 4 7	バッテリー	
6 4 8	音声入力部	
6 4 9	操作キー	
6 5 0	接眼部	40
7 0 1	筐体	
7 0 2	液晶パネル	
7 0 3	バックライト	
7 0 4	筐体	
7 0 5	ドライバ I C	
7 0 6	端子	
8 0 1	筐体	
8 0 2	光源	
9 0 1	照明装置	
9 0 2	テレビ装置	50

1 1 0 0	基板	
1 1 0 1	第 1 の電極	
1 1 0 3	第 2 の電極	
1 1 1 1	正孔注入層	
1 1 1 2	正孔輸送層	
1 1 1 3 a	第 1 の発光層	
1 1 1 3 b	第 2 の発光層	
1 1 1 4 a	第 1 の電子輸送層	
1 1 1 4 b	第 2 の電子輸送層	
1 1 1 5	電子注入層	10
5 0 0 0	携帯型端末	
5 0 0 1	筐体	
5 0 0 3	表示部	
5 0 0 5	電源ボタン	
5 0 0 7	前面カメラ	
5 0 0 9	背面カメラ	
5 0 1 1	外部接続端子	
5 0 1 3	外部接続端子	
5 0 1 5	アイコン	
6 0 0 0	携帯型端末	20
6 0 0 1	筐体	
6 0 0 3	筐体	
6 0 0 5	ヒンジ部	
6 0 0 7	表示部	
6 0 0 9	表示部	
6 0 1 1	電源ボタン	
6 0 1 3	カメラ	
6 0 1 5	カメラ	
6 0 1 7	テキストアイコン	
6 0 1 9	アイコン	30
6 0 2 1	キー ボード	

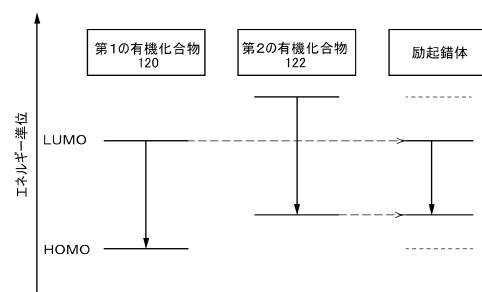
【図1】



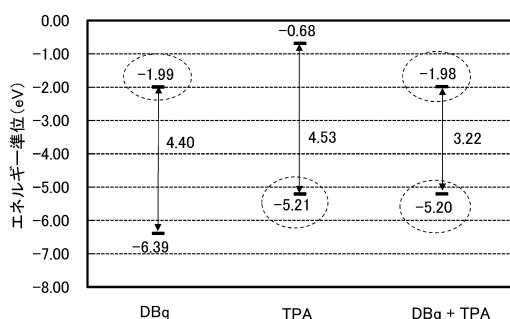
【図2】



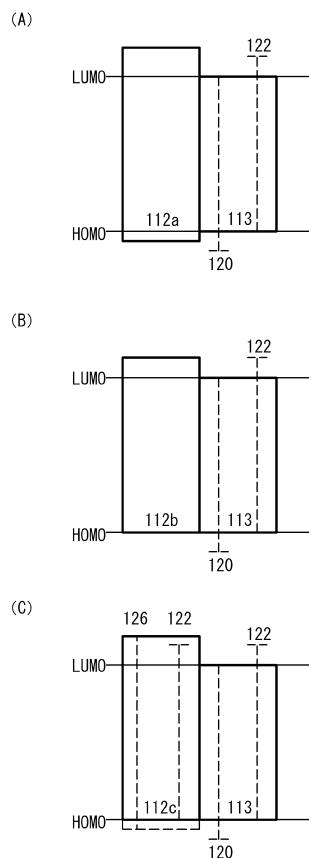
(B)



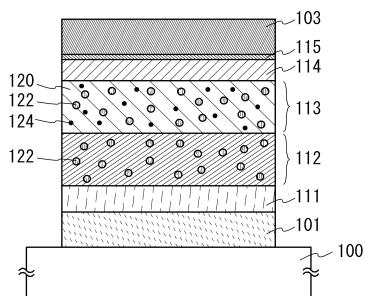
【図3】



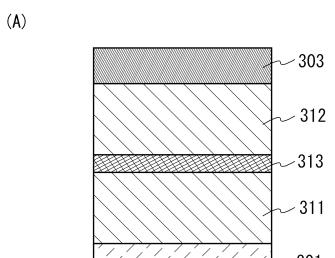
【図5】



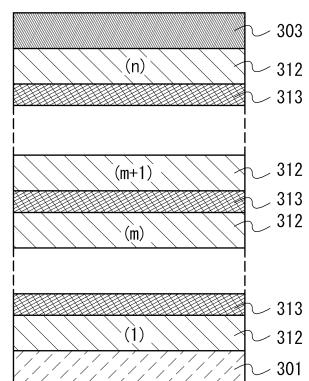
【図6】



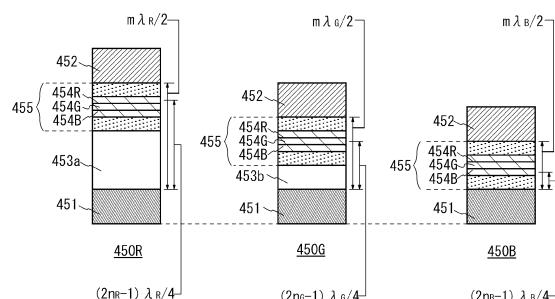
【図7】



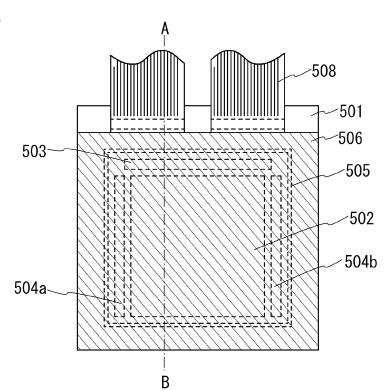
(B)



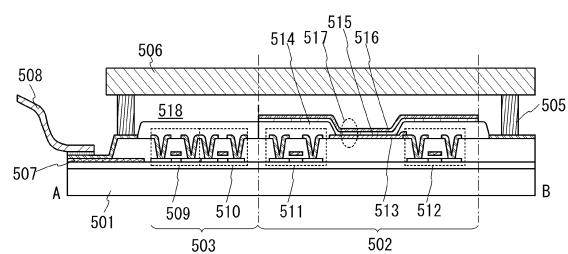
【図8】



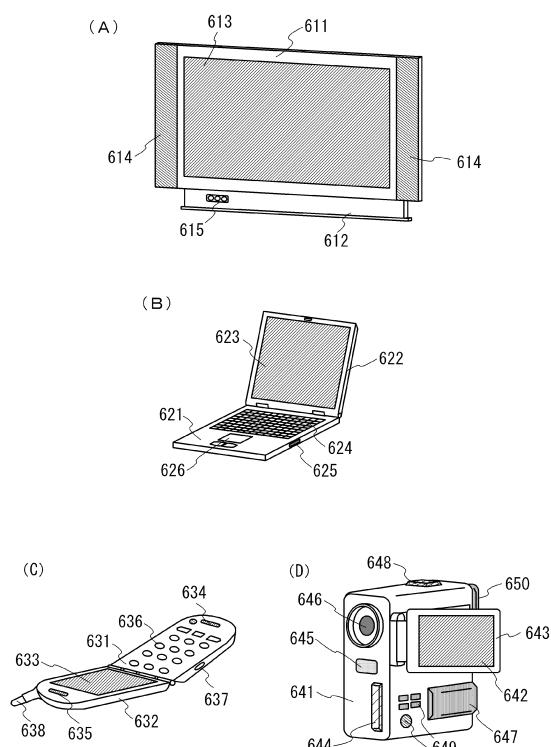
【図9】



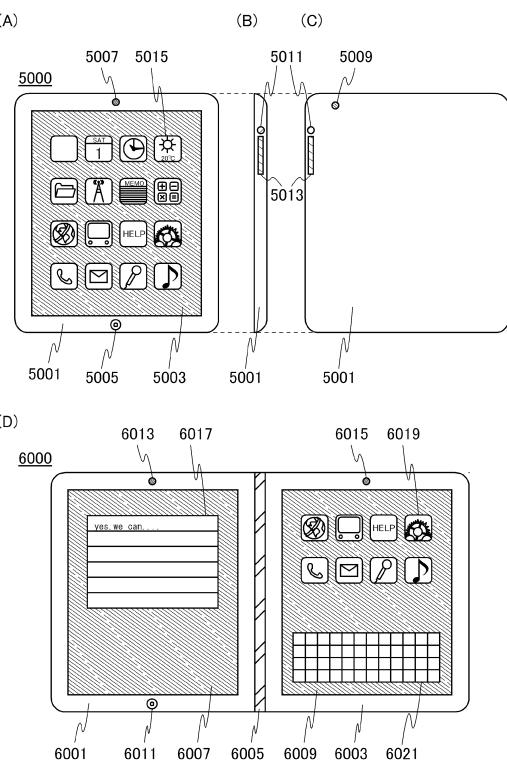
(B)



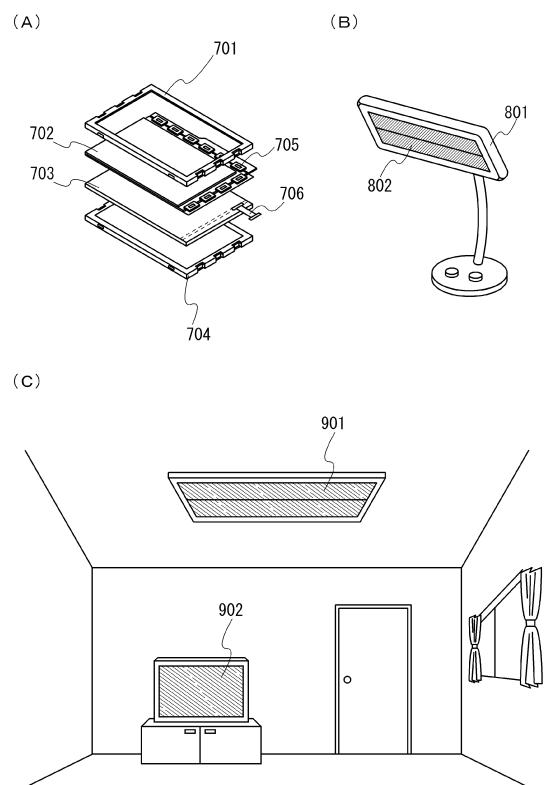
【図10】



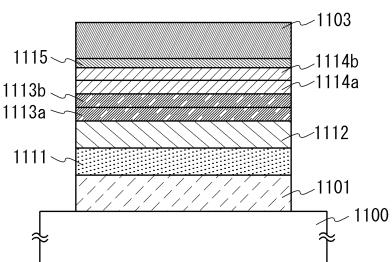
【図11】



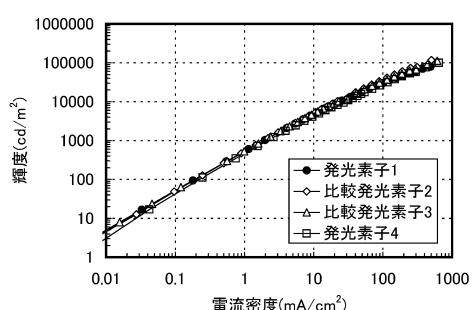
【図12】



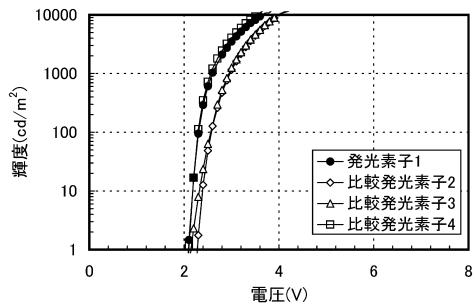
【図13】



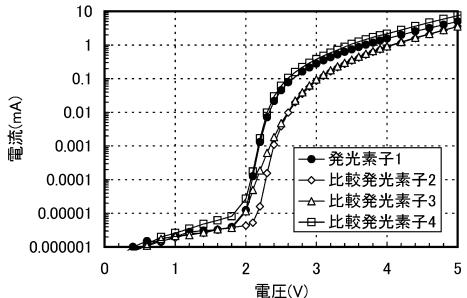
【図14】



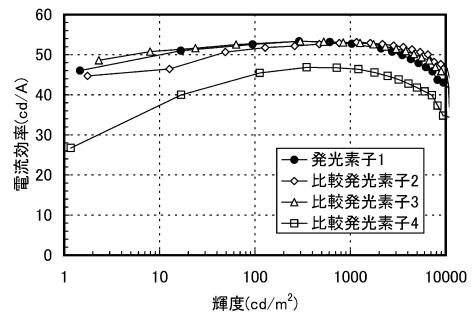
【図15】



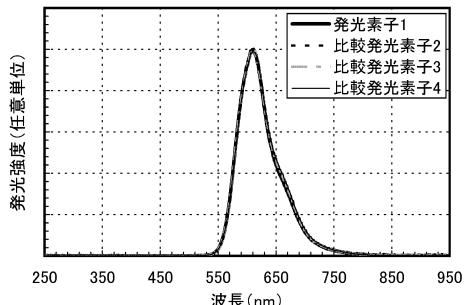
【図17】



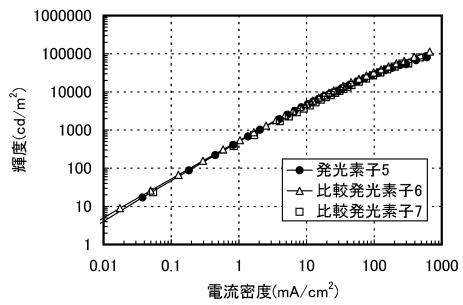
【図16】



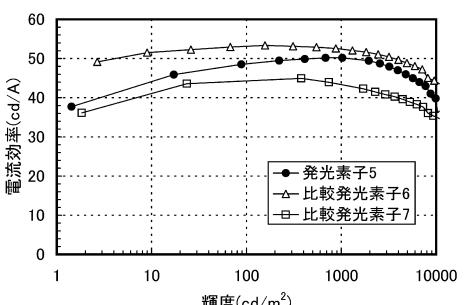
【図18】



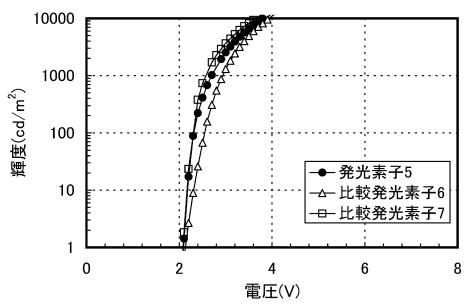
【図19】



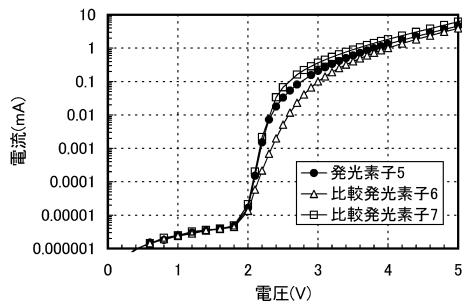
【図21】



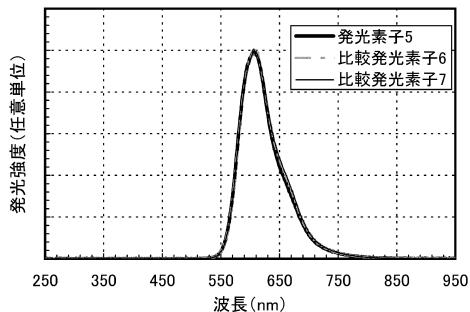
【図20】



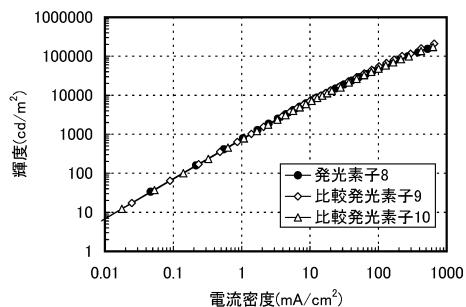
【図22】



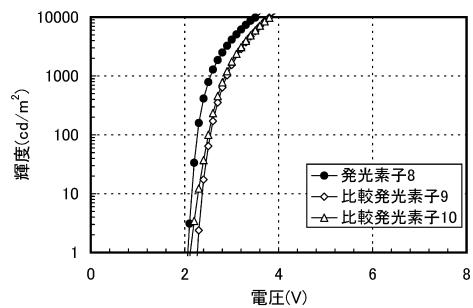
【図23】



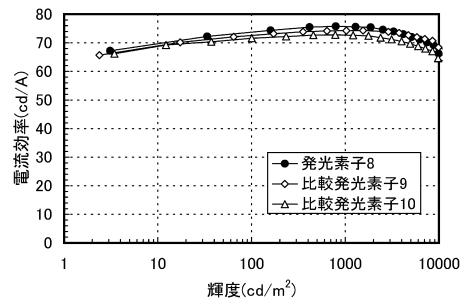
【図24】



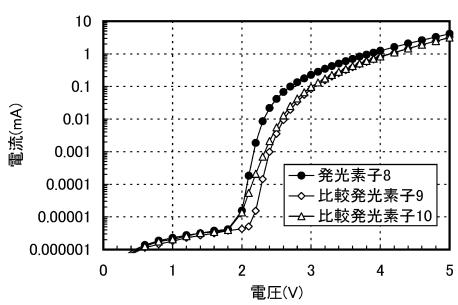
【図25】



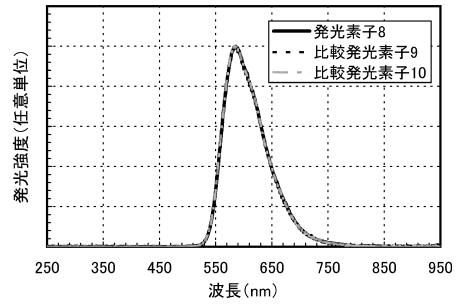
【図26】



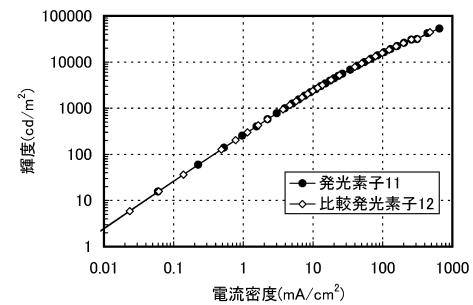
【図27】



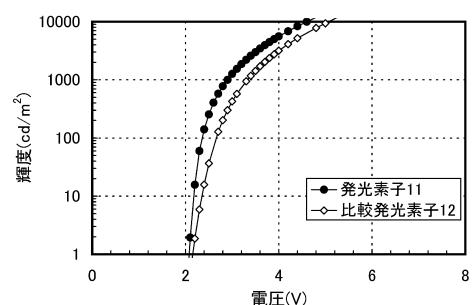
【図28】



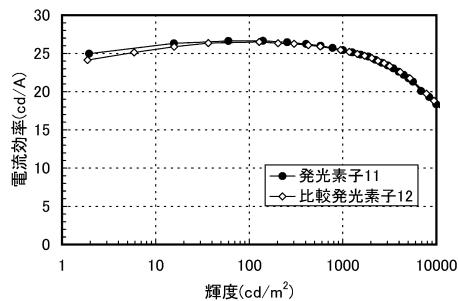
【図29】



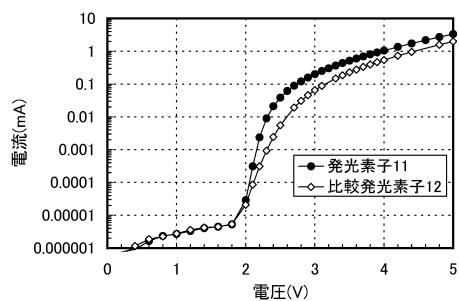
【図30】



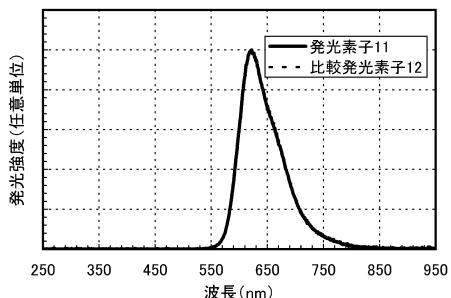
【図31】



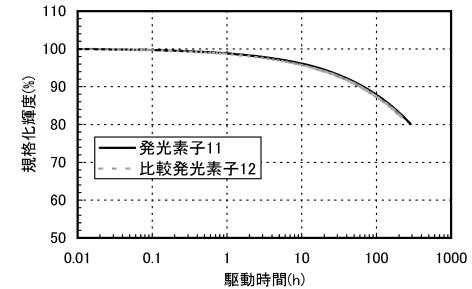
【図32】



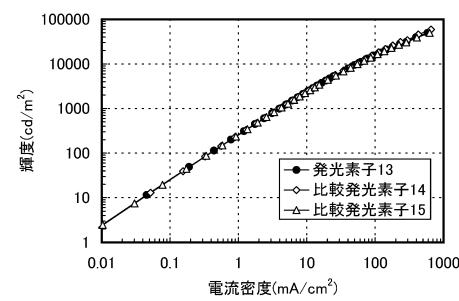
【図33】



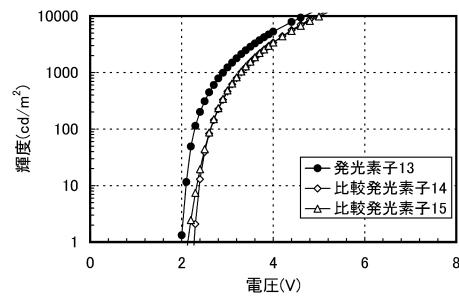
【図34】



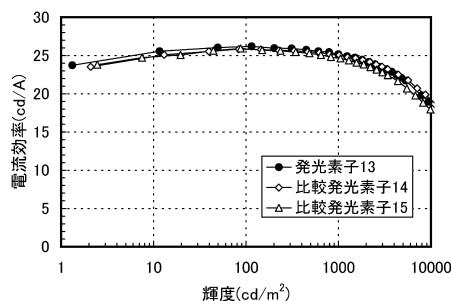
【図35】



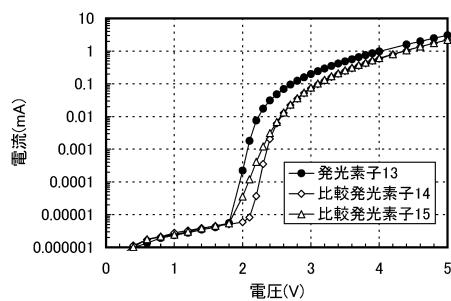
【図36】



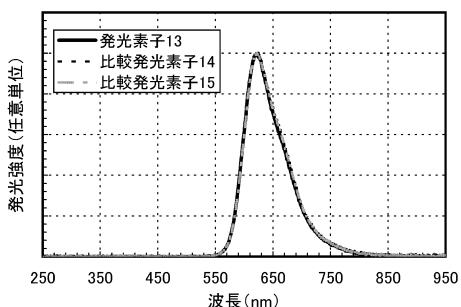
【図37】



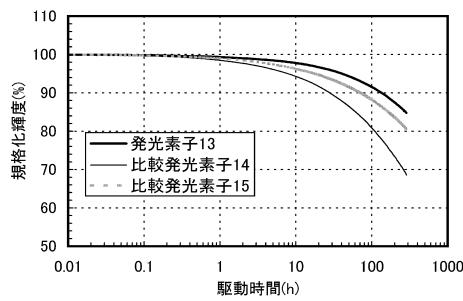
【図38】



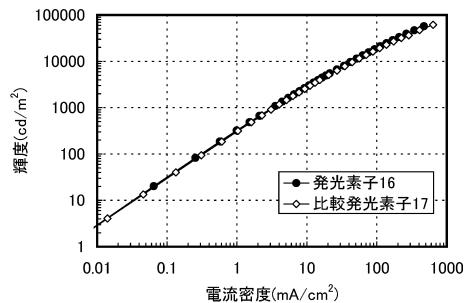
【図39】



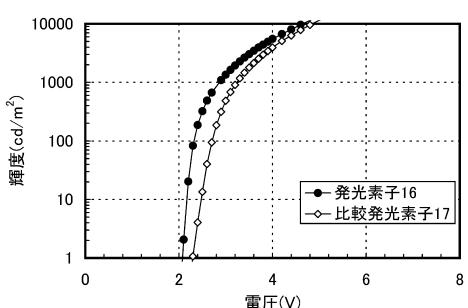
【図40】



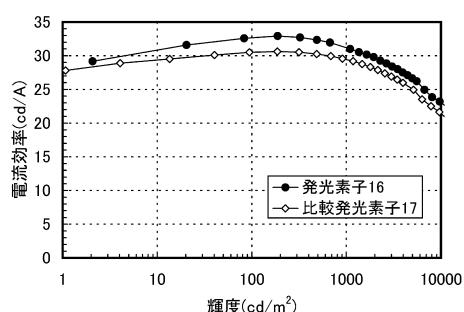
【図41】



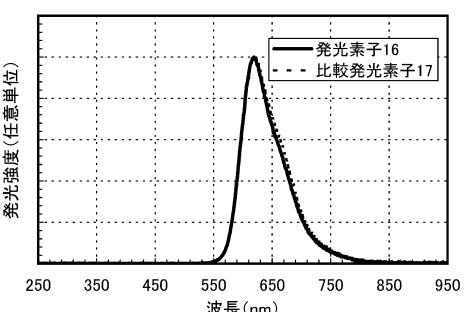
【図42】



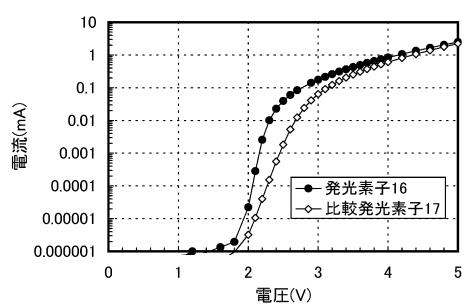
【図43】



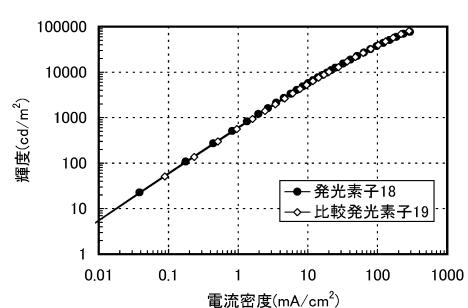
【図45】



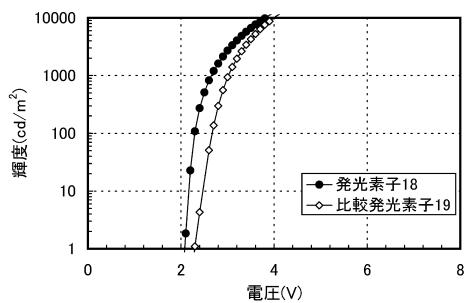
【図44】



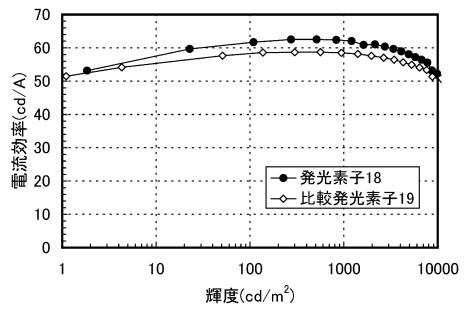
【図46】



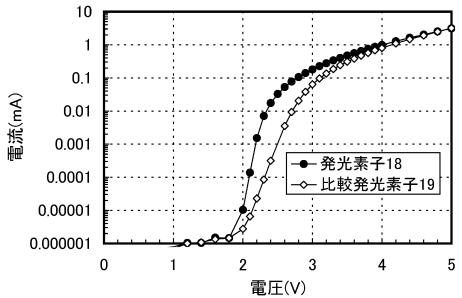
【図47】



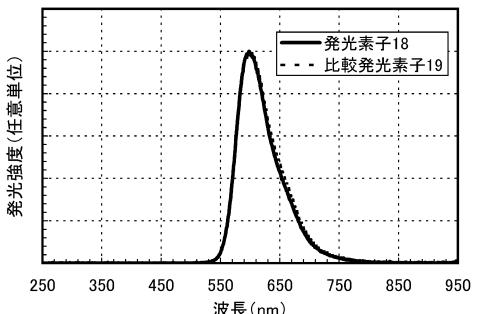
【図48】



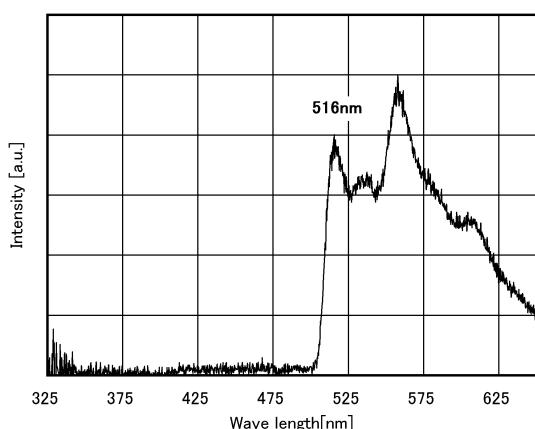
【図49】



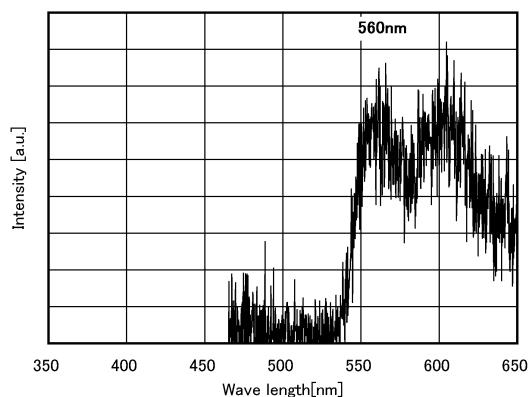
【図50】



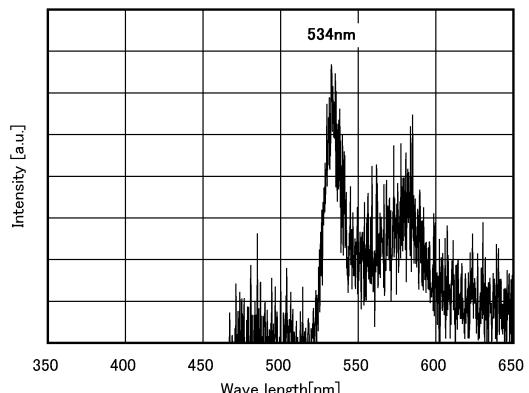
【図51】



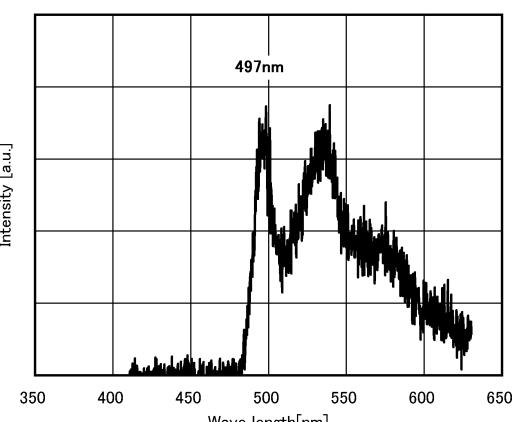
【図52】



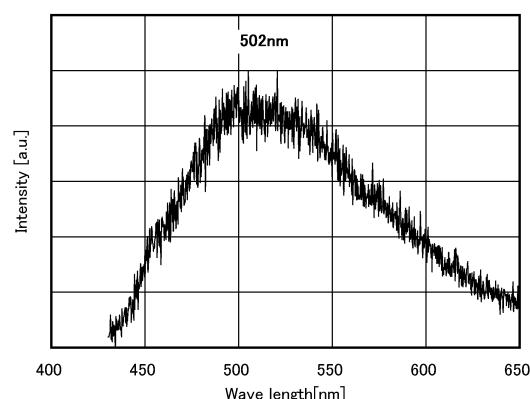
【図53】



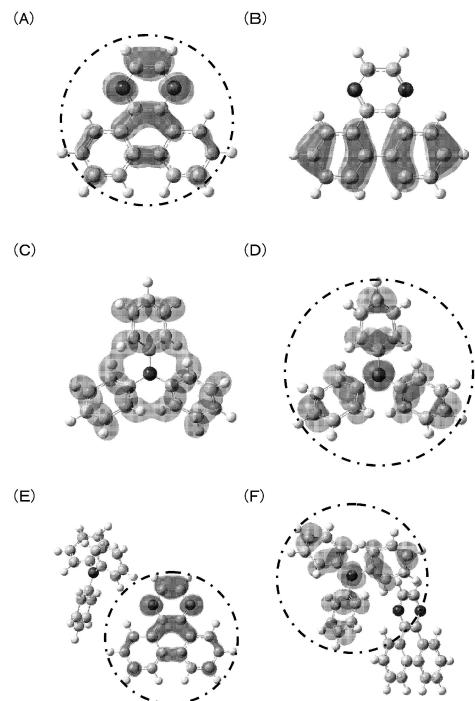
【図54】



【図5-5】



【図4】



フロントページの続き

(56)参考文献 特表2005-514754(JP,A)
特開2004-047493(JP,A)
特開2001-003044(JP,A)
特開2000-133453(JP,A)

(58)調査した分野(Int.Cl., DB名)

H01L 51/50